兵庫県ビームライン年報。成果集

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results

Vol. 5, 6 2016, 201

兵庫県ビームライン年報・成果集

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results Vol. 5, 6 (2016, 2017)

兵庫県立大学放射光ナノテクセンター

目 次

巻頭	頭言	Ι
年	報	III
	兵庫県ビームライン BL08B2	V
	兵庫県ビームライン BL24XU	IX
	施設運用および利用状況	XIV
成	果 集....................................	1
	DSC/USAXS-SAXS-WAXS によるポリアミドナノファイバーの高次構造解析	3
	cos a 法による半導体パッケージ封止用熱硬化性樹脂/銅界面の熱時残留応力その場解析 (住友ベークライト)加々良剛志,若林みどり,中井戸宙,長島大,和泉篤士	7
	Li イオン電池正極材断面の X 線マイクロビームによる反応分布解析	12
	<i>In-situ</i> XAFS/SAXS 同時測定による Au ナノ粒子生成過程解析	15
	X線 CT を用いた各国女性毛髪の観察	20
	小角 X 線散乱法によるナノフィラーの分散状態解析	, 24
	cos α 法による半導体パッケージ用熱硬化性封止樹脂/銅界面の冷熱時残留応力その場解析	28
	樹脂射出成形品の板厚断面方向の結晶化度分布解析	33
	放射光を利用したゴム階層構造追跡 (4)	37

(東洋ゴム) 城出健佑,大江裕彰,鷺谷智,菱川靖浩,三浦聡一郎,西川由真

兵庫県ビームライン研修会実施報告....................................	41
(放射光ナノテクセンター)漆原良昌,桑本 滋生,津坂佳幸,松井純爾	
兵庫県ビームライン成果発表一覧	49



巻頭言

兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター センター長 篭島 靖

兵庫県ビームラインの Figure 8 アンジュレータを光源とする BL24XU は、 国立研究開発法人理化学研究所(理研)及び公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)と締結した同ビームライン設置契約書に基づく設置期限を、 平成 29 年 11 月 13 日に迎えました。兵庫県は「兵庫県ビームライン(BL24XU) 利用状況等報告書・専用施設次期計画書」を提出し、同年 6 月 30 日に開催された専用施設審査委員会において、厳しい評価を受けました。

この審査結果に対応すべく、設置者の兵庫県、事業受託者の兵庫県立大学で 協議を重ね、産業利用という設置目的は堅持しつつ、SPring-8の環境変化に対 応し、ビームラインにおけるアクティビティを高め、SPring-8の発展に貢献す るため、ビームラインの運用体制を抜本的に見直すとともに、成果創出の「見 える化」の実現を目指すこととしました。

新年度から、兵庫県ビームラインは新しい運営体制となります。新たに兵庫 県放射光利用戦略会議とアドバイザリーボードを設置し、戦略的なビームライ ン運営を目指します。産業利用支援と産学連携の二つを柱として運営し、放射 光を活用するマテリアルズ・インフォマティクスや先端計測技術を活用した産 業利用を展開します。従来の利用形態に加えて、産業界をアカデミアが支援す る形のコンソーシアム体制を構築し、産業利用ビームラインとしての成果創出 を目指します。これまでご利用いただいているユーザーの皆様には、技術・事 務手続き両面での利用のしやすさを損なわないよう十分に配慮いたします。

一方、国が平成 28 年度に創設した「地方創生拠点整備交付金」に対して兵庫県が提案した「放射光を活用した次世代材料開発の社会実装拠点整備事業」が採択され、BL24XUの高度化予算が確保されました。これにより、①液体窒素冷却の分光器の導入と②実験装置・測定システムの自動測定システム導入によるハイスループット化等を図ることとなり、今年度ハード整備を実施いたしました。BL24XUは生まれ変わり、より優れた成果の創出を目指した活動を開始します。

新しい運営体制のもとで成果創出の見える化の実現を目指したいと思いま すので、今後とも関係機関の皆様の更なるご指導・ご支援を賜りますよう、何 卒よろしくお願い申し上げます。

年 報

兵庫県ビームライン BL08B2

1. はじめに

兵庫県では,産業界における放射光の利用促進を目 的として SPring-8 内に BL08B2 および BL24XUの2 つのビームラインを設置している.この運営ならびに ユーザーへの利用支援を兵庫県立大学放射光ナノテク センターが行っている.2本のビームラインそれぞれ に特徴的な機能を整備し,材料研究の目的に応じた使 い分けがなされている.その中で BL24XU ではアン ジュレータ光源の特性を活かしたX線マイクロビーム や高平行X線ビームを技術的な核として,半導体,金 属,ソフトマター等の分野における構造評価等で成果 を創出している.これに対し BL08B2 では,産業界に おいてスタンダードな分析法として活用されているX 線吸収微細構造(XAFS),小角X線散乱(SAXS), 粉末X線回折,X線トポグラフィ,イメージングの各 分析手法を提供している.

2016 年度も様々な産業分野において BL08B2 が利 用された.さらに新たなユーザーに対する分析機能の 高度化・改良に関しても様々な取り組みを行った.光 学系および測定系の自動操作化による実験の高効率 化,その場観察測定を目的とした試料環境の整備,分 析機能の複合化促進の整備を行い,ユーザーにとって 使い易い実験環境を整えることを目的として計画的に 進めてきた.

以下では 2016 年度における BL08B2 の活動の詳細 を報告する.

2. 産業界ユーザーによる BL08B2 利用

2016 年度もこれまで同様に利用課題の多くは産業 界ユーザーから提案されたものが占めた.利用形態と しては,ユーザーが実験責任者となって自ら利用する 「一般利用」と,測定代行に相当する「受託研究」の 両方において利用実績があった.2016 年度の産業界 ユーザーの一般利用の統計を図1に示す.ゴムや高分 子材料を含む工業材料,半導体材料,電池材料が主な 利用分野である.近年はこれらの分野が利用の大半を 占める傾向にある. 測定手法の点では,XAFS,SAXS,X線トポグラ フィの利用が占め,2016年度は粉末X線回折の手法単 体での利用はなかった.産業界としては複合的分析の 利用やその場観察に対するニーズが増えており,現有 の高分解能粉末X線回折の装置性能の変更を検討し, 計画的に装置改造を行っていきたい.

受託研究では、XAFS、SAXS、イメージング利用 にて14件の実験を実施した.いずれも数時間の利用 時間で完了している.試料数が限られており、かつ一 般利用に及ばない実験や迅速な分析実施が求められる 場合において、受託研究が利用されている.

ー般利用と受託研究のどちらの利用形態においても, ユーザーと実験ステーションの担当スタッフが密にコ ンタクトを取りながら支援を行っている.支援内容と しては幅広く,実験計画の立案,利用手続きや各種申 請登録に関するアドバイス,実験準備,測定,データ 解析等である.利用課題の募集は随時受け付けており, マシンタイムも SPring-8 のサイクル毎にユーザーの 要望を最大限取り入れながらスケジューリングしてい る.産業界が求めるタイムリーな放射光利用に配慮し た利用支援,ビームライン運営としている.



図 1. 2016 年度一般利用の統計.

3. 各実験ステーションの現状

3. 1 XAFS

兵庫県ビームライン BL08B2 は, 質の高い XAFS 測定の提供を目的として設計・建設されたビームライ ンである.産業界ユーザーの使い易さを優先し,ユー ザーニーズの高い低温・高温加熱炉等のユーティリティ 設備の拡充に努めてきた.特に環境・エネルギー分野 問題への応用テーマに対しては,実環境下でのその場 測定が行えるよう反応性ガス供給・排気装置を整備し た.その場測定だけでなく,ルーチン的な測定ニーズ にも対応するため,多数の試料を自動的に連続測定可 能とする簡易サンプルチェンジャーも導入している. 2016 年度の取り組みとして,ユーザーの利便性の向 上を目的とした XAFS 光学調整の自動化および検出 器(イオンチャンバー)用のガス混合システムの導入 を行った.



図 2. XAFS 光学系自動調整用ユーザーインターフェース.

	BL08B2 IC GAS CONTROLLER								
				START		STOP			
IO	CLOSE	FLUSH?	N2 🥆 100	96	He	0	%		
I1)	CLOSE	FLUSH?	N2 - 100	%	Ar	0	%		
12	CLOSE	FLUSH?	N2 🔽 100	%	Ar	0	%		

図 3. イオンチャンバー用ガス制御用ユーザーイン ターフェース.

BL08B2では、2結晶分光器の上流側にコリメーショ ン用ミラー(前置ミラー)を配置し、分光器との組み 合わせにより、エネルギー分解能の向上と高調波除去 を実現している.分光器の下流側には集光用ミラー (後置ミラー)を配置し、水平ならびに鉛直方向にお けるビーム集光を実現している.分光器および後置ミ ラーと、飛び地の配置であるハッチ間を接続するため の遮蔽配管については、前置ミラー反射によるX線光 軸方向の変位に追従できるよう傾斜架台および昇降架 台を備えている.架台はプログラム上で制御可能であ る.特に XAFS 実験では、測定吸収端(測定エネル ギー)に応じて前置ミラーと後置ミラーの角度、二つ の分光結晶の平行性, 傾斜・昇降架台の角度・高さ, ビーム成形用スリットおよび XAFS 測定系位置等を, 上流側より順次調整していく必要がある.また標準試 料を用いた測定エネルギーの校正も要する. このよう に XAFS 用光学調整は測定条件の変更の都度,多数の コンポーネントの調整と仕上げ状態の判断が必要であ るため、操作に熟練した者しか行うことができなかっ た.この状況に対してユーザーが簡単に XAFS 用光学 調整を行えるよう、機器セッティングの自動化システ ムを開発した. 図2に, 自動調整用プログラムのユー ザーインターフェースを示す. ユーザーは本プログラ ム上で測定元素ならびに吸収端のタイプを選択し、プ ログラムの実行ボタンを押すのみとなる. データベー ス化されたパラメータに基づいて各コンポーネントの 自動調整が行われる. その進行状況はプログラムの画 面上で確認できる.

XAFS 測定における基本的な検出器はイオンチャン バーである.検出感度を考慮して,計測するX線のエ ネルギーごとに検出ガスを選択する必要がある.広い 計測エネルギー範囲に対応できるよう,複数のガス種 および混合比を調整したガスボンベをビームラインに 常備していた.高圧ガスの貯蔵量は極力減らす必要が ある事情があり,この方針に沿ってイオンチャンバー に流すガス種(He, N₂, Ar および Kr)の流量およ び混合比を任意の値に調整可能とするためのガス混 合システムを導入した.本システムは制御プログラム (図3)を通じて,3か所のイオンチャンバー(I₀, I₁, I₂)に対して独立に供給するガスを調整することが可 能である.今後 XAFS 自動光学調整システムと組合 せた操作環境を整備し,自動測定システムの実現を目 指す.

3.2 小角×線散乱(SAXS)

SAXS ステーションでは,高分子材料・金属材料・ ナノ粒子コンポジット材料等の長周期構造の評価を目 的とし,産業界ユーザーを中心に利用展開している. SAXS カメラ長は,標準配置で0.5~6 m,極小角X線 散乱測定の長尺配置で16 mを利用可能であり,幅広い SAXS 分解能の選択性を有する.実験で使用するX線 エネルギーは7~25.5 keV の範囲から選択可能である. また,SAXS/WAXS 同時測定,GI-SWAXS, Rheo-SAXS, ASAXS, Quick-XAFS/SAXS/WAXS 同時測 定の各種複合分析モードを提供しており,これにより 産業界の様々な材料構造評価ニーズに対応している.

2016年度も高分子材料を中心に幅広い産業分野での 材料開発・分析に利用された. 例年通り加熱炉や引張 機等を使用したその場観察測定や多検体分析を目的と したサンプルチェンジャーの利用が大半を占めている. 特に加熱炉の利用が多く、ビームライン整備の加熱炉 ではユーザーから要求される温度変化範囲・速度に対 応できない状況となっている. そこで温度制御範囲が -190~600°C である小型冷却加熱炉(リンカム社製 10033L)を導入した. この加熱炉は150°C/min.の高 速温度変化が可能であり,液体窒素を利用し室温以下 でも精密な温度制御が可能である.同時に,SAXS 測 定時にX線透過率と試料温度を同時計測する自動デー タロガー,ならびに,加熱炉をホール側へ退避し試料 交換を容易にする加熱炉退避機構を導入した. このよ うに加熱炉を使用したその場観察 SAXS 測定にユー ザーが取り組みやすいシステムを構築している.

また、X線低透過率試料(高密度試料)や金属材料 の評価を目的とした比較的高いエネルギーでの測定 ニーズの増加と、PILATUS-100K からの検出面積増 大を目的とし、Si センサー厚1 mm の PILATUS3-X-300Kを導入した.これまでのSi センサー厚 0.45 mm の PILATUS と比べて 20 keV 以上で約2倍の量子効 率となり、20~25.5 keV のエネルギー域でも短時間露 光で良質な SAXS データが得られるようになった.ま た、検出面積の増大による積分情報量の増加により、 SAXS 散乱曲線において中角度域のノイズ低減と露光 時間の短縮が可能となった.特に前述の加熱炉と組み 合わせることで、高速な温度変化によるその場観察測 定が可能となっている.

3.3 X線トポグラフィ

耐高温・低損失パワーデバイスの材料として注目さ れているシリコンカーバイド(SiC)結晶は広いバン ドギャップ,高い熱伝導率,高い絶縁破壊電圧強度な ど優れた物性値を有しているものの,結晶欠陥の存在 により素子面積の拡大が困難となっている.そこで高 品質 SiC 結晶の開発を目的として,結晶欠陥や転位 の分布を評価できる X 線トポグラフィ実験が実施さ れた.4H-SiC エピタキシャル膜のトポグラフ像から, 形状の異なるコントラストを持つ刃状転位を捉える ことで,転位の位置情報と種類情報を得ることができ た. これらの結果を基にして,成膜条件等のプロセス の改良を図り,高品質 SiC 結晶の開発を行っていく. 一方,大面積 SiC 結晶の評価には,そのサイズ(4イ ンチウェハ以上)に対応した測定系が必要となる.現 在,幅 50 mm のワイドビームを利用しているが不十 分である.今後,長ストロークの試料並進ステージを 装置に組込み,検出器と連動する測定システムを構築 する予定である.

3.4 イメージング

X線イメージングは物質内部の構造を非破壊で可視 化できるツールである.中でも三次元空間構造評価が 可能な CT 法は産業界における利用ニーズが大きい. 平板状の試料においても CT 法を利用できるよう,試 料回転軸を傾斜させて測定する X 線ラミノグラフィ の観察機能も供与している.装置上にはユーザーが持 込む試料環境制御装置を設置するためのスペースもあ り,その場観察による観察も可能である.

BL08B2 では偏向電磁石光源からのワイドビーム の特徴を活かし、広視野イメージングが可能である. 基本的な測定機能としては、X線エネルギーは5~37 keV から選択可能であり、視野は 3~10 mm 角程度 を有する. 兵庫県ビームライン BL24XU が提供して いる高空間分解能イメージング(視野:1.3 mm 角, 0.65 μm/pixel) と相補的に利用することで,幅広い 視野レンジでのイメージング計測が可能である.これ は兵庫県ビームラインを利用するうえでの利点とし ているが、広視野と高空間分解能の計測で2つのビー ムラインを使い分ける必要があるため、同一ビームタ イムの間で両機能の利用は難しい. ユーザーの利便性 を考慮し、2016年度は BL08B2 における高空間分解 能化を検討し、その検証実験を行った. 高空間分解能 イメージング用の画像検出器には BL24XU のものを 使用した.本画像検出器は、X線を可視光に変換す るための単結晶シンチレータ部(GAGG;Ce: Ce 添加 Gd₃Al₂Ga₃O₁₂),光学顕微鏡ユニット部,高感度デ ジタルカメラ部(浜松ホトニクス製 ORCA-Flash4.0) で構成されている.光学顕微鏡ユニット部にある対物 レンズは Nikon 製 CFI Plan Apo l0× (開口数 0.45) を採用している. BL08B2 における高空間分解能イ メージングの問題点は1枚撮影当たりの長い露光時 間である. CT 測定では, 試料を 180 度回転させる間 に1000枚を超える撮影を行う場合がある.ひとつの

CT 測定にかける時間を1時間とした場合,構成する 1撮影の露光時間が3秒程度となる.この露光時間条 件で画像検出器の感度検証を行った.X線エネルギー が12.4 keV以上の条件で,カメラの中心部分の平均 計数の飽和度が50%に達した.一方10 keV以下の X線エネルギーの場合は,使用したシンチレータの発 光効率が著しく低いため実用的ではなかった.低エネ ルギー領域でも十分な検出効率を有するシンチレータ を整備し,ユーザーの利用に備えたい.

4. 今後の計画

兵庫県ビームライン BL08B2 は、様々な産業分野に おける材料開発を目的に複数の分析手法を産業界に提 供している.特に近年では、工業材料、半導体材料、 蓄電池材料の各分野における利用が占めている.食品 などのその他の産業分野における潜在的ニーズを開拓 するため、2017 年度からは研修会の開催機会を増や していく. 産業利用では,迅速な材料分析ニーズも高 く,受託研究の依頼件数が増加している. 来年度以降 もこの傾向は続くものと予想されるため,多検体サン プルチェンジャーの整備や,様々な実験条件を想定し た試料ホルダーや測定システムの整備も,ユーザーへ の調査を行いながら進める.

産業界のニーズを先取りするビームライン高度化計 画を検討し,ビームライン高度化を実行するための競 争的資金の獲得等もユーザーと協力して取り組んでい く.また新たな材料探索のための基盤技術の整備にも 目を向けていきたい

兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 放射光ナノテ クセンター

李 雷, 桑本滋生, 漆原良昌, 野瀬惣市, 横山和司, 松井純爾, 高山裕貴, 津坂佳幸, 篭島 靖

兵庫県ビームライン BL24XU

1. はじめに

兵庫県 ID ビームライン BL24XU は放射光の産業利 用推進を目的とし,兵庫県が設置した専用ビームライ ンである.管理,運営は兵庫県立大学 産学連携・研究 推進機構 放射光ナノテクセンターが行っており,産 業界を中心とした県内外ユーザーの受け入れ及び利用 支援を行っている.マイクロビームやイメージングに よる局所構造の高分解能評価に特化したエンドステー ションを整備しており (図 1),比較的バルクな試料を 観察可能な兵庫県 BM ビームライン BL08B2 と相補 的な構造情報を提供する.

光源には 8 の字アンジュレーターを採用しており, 大強度と低負荷の両立のみでなく,半整数次の高調波 を利用することで,垂直,水平偏光を選択可能である. ビームラインはタンデムハッチ構成の 2 本のブランチ (ブランチ A,ブランチ B)から成り (図 1),ダイヤ モンド薄板結晶を利用した長オフセット二結晶分岐分 光器により,単色光をブランチ A,透過光をブランチ B へ同時に供給できる.ブランチ A では Bonse-Hart 型超小角X線散乱 (USAXS),斜入射回折,マイク ロビーム小角X線散乱 (μ-SAXS),ブランチ B では X 線吸収分光,X 線顕微鏡,精密 X 線回折・トポグ ラフィの各ステーションを運用すると共に,高度化や 新規測定技術の開発を継続して進めている.また,産 業利用の新たな取り組みとして,2016 年度からマツ ダ株式会社と兵庫県立大学による次世代自動車材料開 発を目的とした共同研究が開始され,その専用基盤と してブランチ B に硬 X 線光電子分光 (HAXPES) ス テーションを新たに整備した.

2. 産業界ユーザーによる利用状況

兵庫県ビームラインでは、「一般利用」の他, 測定代 行にあたる「受託研究」を行っている.いずれの利用 形態においても,スタッフがユーザーと利用計画を密 に議論し,装置整備・高度化を行うことで利用成果の 創出に努めている.

2016 年度の産業界ユーザー一般利用の統計を図 2 に示す.半導体,素材,自動車,エネルギー,有機材 料やヘルスケアと,利用はハードからソフトマターま で多岐に亘った.ただし,ソフトマター系の利用は全 体の 20%程度であり,今後は利用の少ない食品等の産 業分野への支援も検討したい.測定手法は回折・散乱 が全体の半数を占め,イメージングと分光がそれぞれ 25%程度であった.

受託研究は μ-SAXS とイメージングが対象であり, 2016 年度は 7 件の μ-SAXS 測定が実施された.不均 質系試料の 100 nm 以下の構造へ高い関心があること が伺える.



図 1. BL24XUの概要.

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)





3. 各実験ステーションの現状

3.1 ブランチ A

ブランチ A は,長オフセットダイヤモンド二結晶 分光器のエネルギー変更が困難なため,10 keV 固定 にて運用している.

Bonse-Hart 型 USAXS は、シリコンチャンネルカット結晶を利用したスキャン方式であり、一次元方向のみの測定に限られるが、通常の SAXS 光学系では測定が困難な数ミクロンの秩序構造の観察が可能である.現在の測定領域は $q = 0.001 \sim 0.4 \text{ nm}^{-1}$ 、測定時間は約5分である.測定領域を限定することで約90秒間隔の時分割測定を実現しており、試料の経時変化の追跡も可能である.試料中の凝集体構造や階層構造試料のミクロンオーダーの秩序構造評価に利用されている.

 μ -SAXSでは、屈折レンズを利用した集光光学系を 採用しており、試料位置にてビームサイズ5~6 μ m 角、フォトン数4~5×10⁹ photons/sのマイクロ ビームを利用した局所構造評価が可能である。2016年 度からは、焦点距離の短い屈折レンズに変更すること で、新たに2.5~3 μ m角のマイクロビームも選択可 能となった。また、小型ズーム顕微鏡を導入し、モニ ター上で試料へのビーム照射位置を簡便かつ迅速に調 整可能となった。SAXSカメラ長は現在0.5~1.1 m を利用でき、WAXSとの同時測定も可能である。カ メラ長は、小角分解能向上を目的として、2017年度 に1.8 m までの伸長を計画している。毛髪、カーボン ファイバー等の細繊維、電線材料、電池材料、自動車 材料の局所構造分析で利用されている。

斜入射X線回折では,試料の表面・界面の結晶構造 評価を行っている.回折計に加熱炉を搭載することで 半導体試料等の反応過程の観察も可能である.

3.2 ブランチ B

ブランチ B は,直接水冷型水平分散シリコン二結 晶分光器を備えており,基本波で 8 keV 以上の単色光 を利用可能である.ブランチ A 運用時の利用エネル ギーは,基本波 10 keV とその半整数次を含む高調波 に制限される.

(1) X 線顕微鏡ステーション

X 線集光ビームや X 線イメージング光学系を利用 した,サブミクロン ~ ミクロンの空間分解能と高い 時間分解能を有する測定を展開している.また,産業 界から需要の大きい数十 ~ 数 nm 分解能での非侵襲 観察実現に向けて,2016 年度からコヒーレント X 線 回折イメージング法の開発に着手した [1] (§4.1).

集光ビームはゾーンプレートにより形成し,広角回 折,蛍光 X 線の点分析,実空間マッピング測定が可能 である.ビームサイズや強度,発散角は測定目的に応 じてオーダーメイドで最適化可能であり,10 keV や 15 keV で $0.2 \sim 2 \mu m$ 程度,~10⁹ photons/s のビー ムが,工業・エネルギー材料,機能性繊維の局所構造 分析に利用される.

イメージングでは,投影 CT やラミノグラフィ(視 野 1.3 mm, 空間分解能 0.65 µm/pixel), ゾーンプ レート結像光学系による顕微 CT (視野 200 µm 程度, 空間分解能 75 nm/pixel)を整備している.数秒の時 間分解能での高速投影 CT 測定も可能である. 2016 年 度には X 線画像検出器を高度化し、像品質の改善を 達成した.検出器は間接型を採用しており、投影 CT ではリレー光学系に高倍率の光学顕微鏡ユニットを用 いているため,画像周辺部の歪曲収差が生じていた. そこで、光学顕微鏡ユニットを結像面のイメージサー 結像 CT ではシンチレータに X 線-可視光変換効率の 高い Gd₂O₂S:Tb(P43)を用いていたが, 粉状材料 である P43 は粒状の感度ムラを生じ,特に低コントラ スト試料の測定において試料領域の視認が極めて困難 であった.今回,透明単結晶である CsI:Tb を導入す ることで,ほぼ感度ムラの無い均質な画像が得られ, 視認性を大幅に改善した.感度も従来の P43 と比べ て7 keV で 114%, 8 keV で 80%と高い値を実現した. (2) 精密回折・トポグラフィステーション

主に半導体結晶の微小領域高感度歪み計測を目的 に,微小領域回折実験を行っている.評価ビームは, (+,-,-,+)配置の2つのチャンネルカット結晶とベ ントシリンドリカルミラーを組み合わせて形成してい る.ユーザーは、光学系1 (ビームサイズ 0.8 μ m × 1.7 μ m,発散角 25 μ rad),光学系2 (0.4 μ m × 1.0 μ m,発散角 50 μ rad),光学系3 (35 μ m × 35 μ m, 発散角 3.5 μ rad)から選択して実験できる.焦点には $\theta - 2\theta$ 回折計が設置され、ロッキングカーブ測定や逆 格子空間マッピングが可能である.

また,多波回折条件下での前方透過ビームを用いた X線トポグラフ法(明視野トポグラフ法)を整備した [2] (§4.2).検出器に CMOS カメラを用いるため,現 像の必要がなく,高位置分解能の X線トポグラフ像 が取得できる.多波回折条件近傍では,回折ベクトル を容易に変更できるため,速やかなバーガースベクト ルの決定が可能である.

(3) X線吸収分光ステーション

XAFS ステーションでは, 1 ~ 2 μm サイズに整形 した X 線ビームを利用し, 微小領域の構造評価法を 提供している.主には, 第一遷移金属の化学状態を調 べる目的である.応用分野はリチウムイオン二次電 池,固体燃料電池,陶磁器釉薬の構造評価である.い ずれも第一遷移金属を中心とした酸素の配位構造を探 りたいとするニーズによる.PILATUS 100K を利用 した二次元粉末 X 線回折機能も搭載しており,同一 ステーション上で局所構造及び結晶構造の両評価が可 能である.

(4) HAXPES ステーション

産業利用の新たな活動として、マツダ株式会社と当 大学は次世代自動車材料の開発を目的とした共同研 究を開始した.排ガス浄化用触媒や軽量化向けのカー ボン・樹脂複合材料等を研究テーマとし、共同研究専 用として雰囲気制御型硬X線光電子分光装置 (NAP-HAXPES)を整備した.気相雰囲気、高温加熱条件に おける反応過程のその場観察技術や、複合材料の界 面における電子状態の評価技術等を確立し、高機能材 料のモデルベース開発を目指した材料研究を進める. 2016 年度夏期停止期間に実験ハッチ B1 の拡張工事 を実施し、チャンネルカット分光素子および K-B ミ ラー、NAP-HAXPES 装置を整備して 2016 年秋にコ ミッショニング行った [3]. 2017 年度より本格的な装 置利用研究を開始する.

4. 新規測定法の開発整備

μ-SAXS の需要にも表れているように,電子顕微鏡 では難しい材料内部の数十 ~ 数 nm サイズの階層構 造や孔構造の可視化に高いニーズがある.また,パ ワーデバイス等に応用される次世代半導体材料は開発 途上であり,高密度の転位を大面積で可視化し,迅速 にバーガースベクトルを決定する手法が希求されてい る.これら産業界のより高度なニーズに応えるべく, 大気環境下コヒーレント X 線回折イメージング法 [1] 及び明視野トポグラフ法 [2] の開発整備を行った.

4.1 大気環境下コヒーレント X 線回折イメージング 法の開発

コヒーレント X 線回折イメージング (CXDI) 法は, アンジュレーター光の空間コヒーレンスを活用したレ ンズレスイメージング法である.ミクロンサイズ程度 の非晶質試料に空間コヒーレンスの高い X 線を照射 してコヒーレント回折パターンを取得し,これに位相 回復アルゴリズムを適用して試料投影電子密度像を再 生する.像形成にレンズを用いないため,X 線結像素 子の加工技術に制限されない高い空間分解能で,試料 内部を非侵襲観察できる.

BL24XUでの構成を図3に示す. 微弱な回折パター ンを高精度に観測するために,多くの場合試料は真空 中に置かれるが,BL24XUでは比較的高エネルギー の8 keVのX線を利用し,試料前後に窒化シリコン 製の真空隔壁を置くことで大気中での測定を可能と した. ピンホール–スリット光学系により約1×10¹⁰ photons/16 μ m ϕ (FWHM)/sのX線を照射し,試料 下流約4.1 mの位置のPILATUSにより空間周波数 66 μ m⁻¹ (空間分解能15 nm)までの回折パターン を取得できる.

図3は金コロイド集合体の測定例である.大気中で の測定でも鮮明度の高いコヒーレント回折パターンを 検出器の端まで観測できた.再生された投影像の空間 分解能は29 nm と見積もられ,電子顕微鏡では観察 できない大きさ100 nm 程の内部空隙や粒子の重なり を明瞭に可視化できた.現状の適用試料はミクロンサ イズの孤立粒子に限られるが,2017年度からゾーン プレート集光光学系を利用した走査型 CXDI (タイコ グラフィー法)の開発に取り組み,非孤立試料の観察 へと拡張予定である.

4.2 明視野トポグラフィの Si ウェーハへの適用

一般にシリコン中に存在するミスフィット転位のバー
 ガースベクトルbは, a/2 < 110 > であることが知ら



図 3. BL24XU に構築した大気環境下 CXDI.

れている. このバーガースベクトルの決定は, $g \cdot b = 0$ だけでなく, $g \cdot [b \times n] = 0$ (n は転位線の方向) を 満たす回折ベクトルgで, コントラストが消失するこ とから求められる. シリコンの場合, 111 面からの回 折像だけでなく 224 面からの回折像を取得する必要が ある. これらの回折ベクトルを迅速に変更する多波回 折としては, 図 4(a) に示す組み合わせの 6 波回折が 便利である. 6 波回折の状態からわずか 0.1 度程度結 晶を所定の方向に回転すれば, 6 波回折から希望の 2 波回折の状態に調整できる. 結晶の回転角が 0.1 度程 度なので, 回折ベクトルを変更しても透過像はほとん ど変化無く, 単純にコントラストの消失だけに注意す ればよい.

図 4(b), (c) はそれぞれ, 2²4 と 2²4 のトポグラフ 像である.図 4(c) では,右下降方向の転位線のコン トラストが消失しており,この転位線のバーガースベ クトル b は a/2[110] と決定できた.

結晶中に存在するバーガースベクトルは,結晶系に より大きく異なり,今後 GaN や SiC など六方晶系へ 応用していく予定である.



図 4. 明視野トポグラフ法.

4. 今後の計画

今後も産業界ユーザーのニーズを捉え,ユーザーと 一体となって利用成果創出とそれに向けた高度化整備 を図っていく.材料開発技術の革新に伴い,より微量 な成分や微細な構造要素が分析ターゲットとなってお り,信号計数率やビームクオリティの向上が必須とな る.これを受け,2017年度にブランチBへの液体窒 素冷却型二結晶分光器の導入と輸送部光学系配置の 変更,大面積光子計数型検出器の導入等を計画して いる.現状の直接水冷方式では,8の字アンジュレー ター光であっても余剰熱負荷による第一分光結晶の湾 曲が生じていることが,2015~2016年度のビーム評 価により示唆されている[4].高度化したBL24XUと BL08B2の相補利用体制を強化し,放射光を軸とした 新たな産業利用体制の構築を進めていく.

参考文献 (References)

- [1] Y. Takayama *et al.*: submitted.
- [2] Y. Tsusaka et al.: Rev. Sci. Instrum. 87, 023701 (2016).
- [3] 横山ら: SPring-8 利用者情報 22, 30-35 (2017).
- [4] Y. Kagoshima et al.: Rev. Sci. Instrum. 88, 086110 (2017).

兵庫県立大学

1物質理学研究科

² 産学連携・研究推進機構放射光ナノテクセンター 高山裕貴^{1,2},津坂佳幸^{1,2},篭島靖^{1,2},漆原良昌², 桑本滋生²,野瀬惣市²,首藤大器²,竹内和基², 横山和司²,松井純爾²

施設運用および利用状況

大型放射光施設 SPring-8 を活用した新材料開発等 を促進するため,兵庫県では2本の県専用ビームラ インを整備し,平成25年度からは公立大学法人兵庫 県立大学産学連携・研究推進機構放射光ナノテクセン ター(以下「放射光ナノテクセンター」という.)が 兵庫県から委託を受け管理・運営を行っている.放射 光ナノテクセンターでは,兵庫県ビームラインの設置 目的である放射光の産業利用推進を図るため,企業の 研究開発へ利用提供するとともに,企業の利用支援や 共同研究,受託研究を通して産業界の利用支援を実施 している.

2本ある兵庫県ビームラインは,異なる種類の光源 を持ち,その得意とする分析手法も違っている.

まず,1本目のビームラインはアンジュレータ光源 の BL24XU である.

BL24XUはSPring-8の供用開始とともに整備を始め、1998年度に供用を開始、マイクロビームを使った各種イメージング、回折装置等を活用して、半導体材料、生体材料、高分子材料等幅広い材料分野での局所分析に対応し、具体的な研究成果を挙げてきた.

2本目のビームラインは偏向電磁石光源の BL08B2 である.

BL08B2 は 2005 年度より供用を開始した.産業界 において,より製品化に直結する技術開発段階での 材料分析ニーズが増加,また材料利用技術の高度化 に伴って,新しい機能を有する材料の開発等が盛んに なってきたことなどから,BL24XUが有する手法に 加え,小角X線散乱(SAXS),広域X線吸収微細構 造解析(XAFS),高精度粉末X線回折,単色X線ト ポグラフィ等の手法についても対応している.

2008年1月には、この2本の兵庫県ビームライン の産業利用推進拠点として、兵庫県放射光ナノテク研 究所の供用を開始した。当研究所は、多くの産業界で 実施されている新材料開発上必要な分析評価に放射光 を積極的に適用することを目的に、電界放出型走査電 子顕微鏡、走査プローブ顕微鏡、共焦点レーザーラマ ン顕微鏡などの分析装置や試料準備室を備え、利用企 業等を支援している.

また,大学や企業との共同研究を行うための共同 研究室,会議室なども備えた多機能施設であり,コー ディネーターや研究員が配置され,利用企業等から のさまざまな相談・要請に対応するとともに,兵庫県 ビームラインの利用企業等に対し,各種申請,実験準 備,分析アドバイス等を行っており,放射光利用が未 経験である企業に対しても,技術相談・トライアル的 な利用機会の提供を通じて技術的支援を行っている.

さらに、SPring-8 サイト内には同大学が保有する 軟X線放射光施設である New SUBARU があり,組 織的な連携を図ることにより,産学共同研究に対する 体制を強化し,産業界における放射光利用の裾野の拡 大にも取り組んでいる.一方,産業界における放射光 の利用が進み,また世界トップレベルのスーパーコン



図 1. 兵庫県ビームラインの利用体系



図 2. 兵庫県ビームラインの運営体制

ピュータ「京」や産業利用専用のスーパーコンピュー タである「FOCUS」が兵庫県内に設置され,放射光 の解析とスーパーコンピュータによるシミュレーショ ン技術を組み合わせた革新的な材料開発のニーズが高 まってきている.放射光ナノテクセンターでは,放射 光施設及びスーパーコンピュータの相互利用を促進す るため,企業の技術者等に材料シミュレーション技術 の習得支援を行ってきたところであり,今後も継続し て支援していきたい.

これまで以上に,利用企業等にとって使いやすい環 境を整え,産業分野における放射光の利用が円滑に進 むよう努めるとともに,技術相談・受託研究等の実施 を通じて,県内に立地する多数の中堅・中小企業や地 場産業への放射光利用が進むよう,放射光利用の裾野 の拡大にも取り組んでいく.

また,関西地域に止まらず,全国の先端的技術開発 を進める企業にも兵庫県ビームラインを積極的に提供 し,新材料の評価・開発等に多くの知見を蓄積するこ とで,利用企業等のニーズに応じた高度な技術的課題 に対応できるよう努めていく.

利用体制

兵庫県ビームラインの利用に至る過程を図1に示す.

運営体制

兵庫県ビームラインの利用に関わる運営体制を図2 に示す. 受託研究(分析サービス)

兵庫県ビームラインが備える汎用的な分析ツールを 活用し,産業界が放射光を利用しやすいシステムを提 供するとともに,産業界における潜在的ニーズの開拓 を進めるため,2009年度より,企業等からの委託を 受けて放射光ナノテクセンターの研究員が,試料の測 定・解析を行う受託研究を実施している.

分析の内容としては、当初、XAFSと小角X線散乱 の両測定法を対象としてスタートしたが、産業界の要 望を踏まえ、X線イメージング、トモグラフィなど、 順次分析サービスの測定法を充実させている.

維持管理・経費負担

兵庫県ビームラインおよび兵庫県放射光ナノテク研 究所の維持管理,機器整備,ユーザーサポートについ ては,放射光ナノテクセンターが一元的に管理を行っ ている.なお,BL24XUの技術的な管理・運営部分 に関しては,同大学大学院物質理学研究科X線光学講 座の教員が,放射光ナノテクセンターとともに担って いる.

兵庫県ビームラインの維持管理にかかる費用につい ては,設置者である兵庫県が負担しているが,実験に 必要な機器等の整備費や研究費等については,利用企 業等に負担いただいている.

なお,ビームラインの利用については,ユーザータ イムの配分に応じた利用料金(59.4 万円/日)を負担 いただいている. 兵庫県ビームラインの利用に当たって,利用申請は 随時受付けており,利用時期についても,毎月実施し ているスケジュール会議において,兵庫県ビームライ ンの効率的な運用を考慮しつつ,企業の意向をなるべ く尊重する形で日程調整を行っており,SPring-8の 全ビームタイムに対する兵庫県ビームラインの稼働率 は,ほぼ100%となっている.

兵庫県ビームラインにおける,最近3カ年の装置別 利用割合を図3に示すが,マイクロビームを用いた局 所分析や小角X線散乱(SAXS),X線吸収微細構造 (XAFS)の利用が高い割合で推移している.

また,利用分野については図4のとおりであり,兵 庫県の主たる産業である鉄鋼や金属関係の利用割合は ごく僅かで,「関西イノベーション国際戦略総合特区」 において,次世代省エネルギー関連材料の開発を最重 点課題として取り組んでいることも関係していると思 われるが,県内及び関西企業のニーズが高い電池や半 導体といった省エネ,次世代エネルギー関連分野の利 用が多い.

手法別利用割合



図 3. 兵庫県ビームラインの装置別利用割合

兵庫県立大学産学連携・研究推進機構 放射光ナノテクセンター事務局 毛利泰樹



図 4. 兵庫県ビームラインの分野別利用割合

13%

成果集

本成果集は,SPring-8 成果審査委員会において公開技術報告書の認定を受けております.

2014B3381

DSC/USAXS-SAXS-WAXS によるポリアミドナノファイバーの 高次構造解析

Higher Order Structural Analysis of a Polyamide 66 Nanofiber by DSC/USAXS-SAXS-WAXS

長谷川 利則, 高尾 直樹, 石川 大輔, 今井 英人 Toshinori Hasegawa, Naoki Takao, Daisuke Ishikawa, Hideto Imai

> 株式会社日産アーク NISSAN ARC, LID.

概要:高融点結晶を有するポリアミド 66 ナノファイバーの構造変化を調べるため,示差走査熱量測定(DSC) と小角 X 線散乱測定(SAXS)および広角 X 線散乱測定(WAXS)の同時測定を実施した.昇温過程におい て既存のラメラ構造の成長や融解によるピークの消失が DSC 曲線とともに観察された.さらに,ナノファイ バーの DSC 曲線で観測された高温の融点は既存のラメラ構造より大きな,伸びきり鎖結晶のような構造体で あることが示唆された.

キーワード: ナノファイバー, ポリアミド, DSC, SAXS, USAXS, WAXS, in-situ

背景と研究目的

高性能な LIB バッテリ用セパレータや,高強度な繊 維への応用を視野に、新規ナノファイバーの開発が進め られている. 高分子の高次構造は力学特性や熱特性等 に大きく関与するため、その詳細の把握が欠かせない. 前報告にて、CO2 レーザー超音速延伸 (CLSD) 法で作 製したポリアミド 66(PA66) ナノファイバーについて 示差走査熱量測定 (DSC) を実施したところ, ナノファ イバーには原繊維に存在しない高温の融点(279°C)が 観測された(Fig. 1). PA66の Gibbs-Thomson プ ロットから高温の融点は数百 nm サイズの構造体であ る可能性が示唆された (Fig. 2) [1,2]. また, TEM 観 察の結果 Fig. 3 に示すように厚さ 100~200 nm の構 造体が確認された.しかし、DSC 測定時の試料は熱的 に非平衡な状態にあり,高温の融点に由来する構造の 解析は昇温中に実施する必要がある.また,TEM に て観察された構造体は結晶由来かどうは判断できない ため、結晶構造と熱的挙動を同時に観察することが可 能な, DSC-SAXS-WAXS 同時測定が有効である. 一 般に SAXS は 100 nm 以上の構造体の評価は測定範囲 外となるため、本研究においては、高輝度な放射光を 用いた DSC/USAXS-WAXS 同時測定により、PA66



Fig. 1. DSC curves of (a) original fiber and (b) $nanofiber^{1}$.

ナノファイバーの結晶融解挙動の観測と 100 nm を超 える構造体の結晶性を含めた高次構造変化の解析を実 施した.



Fig. 2. Gibbs-Thomson $plot^1$.



Fig. 3. TEM observation image of nanofiber.

実験

・ナノファイバーの作成

試料には、CLSD 法で作製した PA66 ナノファイバー (平均繊維径 0.6 μm, 279°C×10 min 熱処理)と延 伸前の原繊維を用いた [1]. CLSD 法は,真空チャン バーに設置したオリフィス直下で発生する超音速の空 気ジェットと炭酸ガスレーザーを利用して,原繊維を 数万 ~ 数十万倍に超延伸させ,ナノファイバーを作製 する新規の延伸法である [3]. ナノファイバーの作製 にあたり,特別に材料を準備する必要はなく,環境や 生体への影響が懸念される薬品類は一切使用しない. 適用材料は熱可塑性樹脂全般であり、フッ素系樹脂に も適用可能である.

・DSC/SAXS 測定

DSC/SAXS 測定は, SPring-8の BL08B2 にて実施し た.X線入射側光学系は3スリットピンホール光学 系を用いた.試料部に DSC 装置を設置し,試料を Al 泊に挟んで保持した.検出器は PILATUS-100K を用 いた.X線の波長は λ =0.1 nm,試料から検出器まで のカメラ長を約2mとし,qレンジで0.0664~2.18 nm⁻¹の範囲を測定した.検出器の角度キャリブレー ションにはコラーゲンを用いた.ビームストップ兼用 の PIN-photodiode 検出にて試料の透過率を測定し, 透過率を補正後に Al 泊のみの散乱曲線にてバックグ ランを除去した.DSC の昇温速度は 10°C/min,測定 は6秒間隔にて実施したため,1°C 毎の SAXS 測定 が可能であった.また,DSC は Sn および In を用い て校正を実施した.

・DSC/USAXS-WAXS 測定

DSC/USAXS-WAXS 測定は,前述の BL08B2 にて 実施した. low-q 側まで測定するため,X線の波長は λ =0.15 nm,試料から検出器までのカメラ長を約 16 m とし, q レンジで 0.006~0.198 nm⁻¹ の範囲を測定 した. 検出器のキャリブレーションや DSC の昇温速 度などは前述の DSC/SAXS 測定と同じ方法にて実施 した. WAXS 測定は USAXS 測定と同時に実施する ため,カメラ長約 15 cm の位置に PILATUS-100K 検 出器を設置し,2 θ =15~36 deg のレンジにて実施した. WAXS 測定の際の PILATUS 検出器の角度キャリブ レーションは Si を用いて実施した.

結果および考察

ナノファイバーの測定結果を Fig. 4 に, 原線維の DSC/SAXS 曲線を Fig. 5 に示す. Fig. 5 の原線維 にはラメラ構造由来の散乱ピーク(2*θ*=0.6~0.8 deg) が確認され,昇温とともにピーク位置が低角側に移動 している.強度も増加していることから,ラメラが厚 くなり,ラメラの量が増加していると考えられ,ラメ ラの成長が確認された.融点以上(260°C)ではラメ ラ由来のピークは消失し,DSC 曲線と SAXS 曲線共 に結晶の融解が確認された.



Fig. 4 DSC/SAXS measurements of nanofiber.



Fig. 6 DSC/USAXS-WAXS measurements of nanofiber.

一方, Fig. 4のナノファイバー測定結果より, ラメ ラ構造に由来する散乱ピーク(2 θ =0.6~0.8 deg)と, さらに低角側(2 θ =0.2~0.3 deg)に散乱が確認され た.その低角度側の散乱はラメラ融解後も存在してい た(Fig. 4の※).ラメラ融解後も散乱体が存在し, 低角度側に散乱があることから, ラメラ構造より大き な散乱体の存在が示唆される.

ナノファイバーの DSC/SAXS 測定にて確認された, 大きな構造体の確認ため DSC/USAXS-WAXS 測定を 実施した.ナノファイバーの結果を Fig. 6 に,原線 維の結果を Fig. 7 に示す.

Fig. 7 の原線維では,260°C 付近のラメラ融解に よる DSC ピークより高温側においては,USAXS の 散乱強度に変化がなかった.Fig. 6 のナノファイバー においては,260°C 付近のラメラの融解ピークより 高温側でも散乱体が存在していることが確認された (Fig. 6–II).この結果は SAXS の結果と一致する. その散乱体の評価のため,280°C の散乱曲線と285°C の散乱曲線(Fig. 6 の A–B)の差をとった散乱曲線



Fig. 5 DSC/SAXS measurements of original fiber.



Fig. 7 DSC/USAXS-WAXS measurements of original fiber.

を Fig. 8 に示す. 散乱強度は q^{-2} にて減衰が見られ disk 状の散乱体であると考えられる. disk 状の散乱 体の断面の厚さの回転半径 R は式 (1) にて求めるこ とができ,回転半径より断面厚さを算出できることが 知られている [4]. Fig. 9 に $\ln(I_q^2)$ vs q^2 プロット (thickness-plot) の結果を示す. Fig. 9 の傾きより求 めた disk の厚さは約 150 nm と算出された. 前報告 中 [1] の TEM 観察により確認された構造体 (Fig. 3) の大きさとよく一致していた.

更に、同時に測定した WAXS の結果より、ピーク強 度は弱いが、結晶性のピークが確認され(Fig. 6–I)、 前述の約 150 nm 厚の disk 状散乱体は結晶を有して いることが分かった.以上より、ナノファイバーに確 認される高温側の DSC ピークは前述の報告 [1] を支 持する伸びきり鎖のような大きな散乱体である可能性 があると考えられる.

$$\ln(I(q)q^2) = \ln(I(0)q^2) - R^2 q^2, \quad t = \sqrt{12}R \qquad (1)$$



Fig. 8 Scattering curve difference of 280°C and 285°C on USAXS measurements of nanofiber.

放射光の高輝度な X 線を用いた DSC 測定中のダイ ナミックな構造解析と, USAXS による 100 nm を超 える散乱体の測定および, WAXS による結晶性の観 察により, ナノファイバーではラメラの融点以上でも 150 nm 程度のディスク状の大きな散乱体が存在し, なおかつその散乱体は結晶を有することが判明した. この散乱体は伸びきり鎖である可能性が高いことが示 唆された.

今後の課題

今回の DSC/SAXS 同時測定によって,ナノファイ バーの高次構造の一端を明らかにすることができた. また今回の測定結果は,ナノファイバーの高次構造と 熱特性の相関関係を確立する一助になると期待でき, 今後詳細に解析する予定である.

事業への貢献

今回実施した放射光 SAXS など,放射光を利用した 分析評価はなくてはならない手法となってきている. 今課題の DSC/SAXS では,実験室系評価手法では得 ることが出来ない評価結果を得ることが出来た。今後 は DSC/SAXS を新規材料開発のニーズに応用してい きたい.



謝辞

今回の研究を行うに当たり,兵庫県立大学産学連携・ 研究推進機構放射光ナノテクセンターの桑本滋生氏, 漆原良昌氏,李 雷氏をはじめ多くの方々にお世話に なりました.この場を借りてお礼を申しあげます.

本成果は SPring-8 課題番号 2012B5090/BL16XU での結果を基に, 2014B3381/BL08B2 にて実施した ものである.

参考文献

- T. Hasegawa and T. Mikuni: J. Appl. Polym. Sci.131, 40361 (2014).
- [2] B. Wunderlich: Macromolecular Physics vol.3, 161-162 (Academic Press, New York, 1980).
- [3] A. Suzuki and K. Aoki: Eur. Polym. J., 44, 2499 (2008).
- [4] O. Kratly and O. Glatter, *Small-angle X-ray Scattering*, (Academic Press, New York, 1982).

2015A3330, 2015B3330

cos α 法による半導体パッケージ封止用熱硬化性樹脂/銅界面の熱時残留応力 その場解析

In-situ residual stress analysis at the interface between semiconductor package encapsulation resins and copper during heating process by using $\cos \alpha$ method

加々良 剛志, 若林 みどり, 中井戸 宙, 長島 大, 和泉 篤士 Takeshi Kakara, Midori Wakabayashi, Hiroshi Nakaido, Dai Nagashima, Atsushi Izumi

> 住友ベークライト株式会社 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

概要:X線回折法を用いた半導体パッケージ用封止樹脂/Cu界面の残留応力評価技術について検討した.Cu 箔/封止樹脂/Cu箔の三層構造からなる試料を半導体パッケージのモデル材として用い,イメージングプレー トにより測定した Cu(331)面の2次元回折環の歪を cos α 法により解析することで,樹脂/Cu界面における 数十 MPa オーダーの残留応力評価に成功した.更に,加熱ステージを用いた熱時その場観察により,熱プロ セス過程における樹脂/Cu界面の残留応力変化は,樹脂の熱膨張,硬化収縮,樹脂と Cuの線膨張係数差など によって説明可能であった.以上より,当手法は半導体パッケージ用封止樹脂/Cu界面の残留応力評価技術と して有効であることが確認された.

 $\neq - \nabla - \kappa$: residual stress, semiconductor package, resin-copper-interface

背景と研究目的

半導体パッケージの高信頼性・薄型化・高密度実装 化を実現する上で、半導体パッケージ封止用樹脂は必 須の材料である.半導体の高性能化に伴い、その半導 体パッケージ封止用樹脂にも更なる寸法安定性、低熱 膨張率、耐熱性、電気絶縁性、熱伝導性、耐湿性など の特性が求められ、これらは半導体パッケージの長期 信頼性にも影響する重要因子である.

半導体パッケージは主に,シリカなどの無機フィラー を含有した熱硬化性樹脂と,それにより封止される配 線やリードフレームといった金属からなる複合部材で ある.半導体パッケージは,その製造工程において樹 脂成形・熱硬化・半田リフローなどの複数の加熱冷却 プロセスを経るため,樹脂と金属といった弾性率や線 膨張係数 (CTE) などの物性値が大きく異なる材料間 の界面には熱応力が残留応力として蓄積する.残留応 力は半導体パッケージの歪みや反りとなって現れ,界 面剥離という半導体パッケージにおける致命的な不良 モードの要因となる.半導体パッケージにおける配線 やリードフレームは主に Cu であるため,樹脂/Cu 界 面における残留応力の評価技術の確立,および残留応 力発生メカニズムの解明は,半導体パッケージの不良 発生を抑制し,高信頼性製品の開発において極めて重 要な課題となる.

残留応力は X 線回折角から求まる結晶格子歪と材 料の弾性率より算出可能である.平面応力状態を仮 定できる場合の解析手法としては,試料表面と Cu 結 晶格子面法線のなす角 Ψ と回折角の関係を評価する $\sin^2 \Psi$ 法が有効である [1–3].たとえば樹脂/Cu 界面 に引張応力が存在する場合の Cu 結晶格子の状態を考 えると, $\Psi = 0^{\circ}$ に対応する格子面の間隔は無歪状態 に対してポアソン比に従い小さくなり, Ψ が大きくな るつれ面間隔は広がり, $\Psi = 90^{\circ}$ で最大となる.

我々はこれまでに多軸回折計と0次元シンチレー ションカウンターを用い,sin²Ψ法による半導体パッ ケージにおける樹脂/Cu界面の残留応力評価を検討 してきた [4-6].しかしながら,複数のΨに対する回 折プロフィールをスキャンする必要があるため,1測 定に数十分間もの時間を要し,数-数十分オーダーの 熱プロセスの各工程における応力変化を詳細に解析す るためには,測定時間を数分オーダーに短縮すること が課題である.そこで,0次元検出器を用いた sin²Ψ 法に代わる短時間での応力評価手法として,2次元検 出器を用いた cosα法に注目した [1,7,8]. cosα法は 2次元検出器で得られる回折環全体の歪情報より応力 を算出する手法であり,更に1種類のX線入射角で の回折データのみで解析可能であるため,大幅な測定 時間短縮が期待される.今回, cosα法を用いた半導 体パッケージ封止用熱硬化性樹脂/Cu界面における残 観察について検討した.



Fig. 1. (a) Schematic image of semiconductor package model for residual stress analysis comprising of Cu/Resin/Cu three-layered sample. (b) Photo image of the specimen for the residual stress analysis.
(c) X-ray CT image of a semiconductor encapsulation resin containing SiO₂-fillers (pale-colored region) by using CCD detector measured at BL08B2 beamline

実験

半導体パッケージのモデル材料として,Cu 箔 (12 μ m)/半導体パッケージ封止用熱硬化性樹脂 (1.3 mm)/ Cu 箔 (12 μ m)の三層構造からなる平板状試料を 200°C での加熱圧縮成形により作製し,20 mm × 20 mm に 切出した (Fig. 1a, b).熱硬化性樹脂として樹脂 a およ び樹脂 b を用いて作製したモデル材料を各々 sample-A, sample-B とする.ここで,半導体パッケージの冷 熱衝撃試験における Cu との界面密着信頼性は樹脂 a よりも樹脂 b が優れる.また,いずれの樹脂もシリカ フィラーを約 70 wt%含み (Fig. 1c),硬化樹脂の CTE は 200°C 以下において Cu とほぼ同等の値を示すよう に設計されているが,200°C 以上においては大きく変 化し,樹脂 b は樹脂 a より大きな値を示す (Fig. 2).

測定のレイアウトを Fig. 3 に示す. 試料加熱炉には ビームライン保有の小型セラミックヒーターを用い, 入射 X 線と試料表面法線のなす角 (φ) が 30° となる ように設置した. 表面 Cu 箔からの回折 X 線は, 試 料より上流側に設置した X 線透過穴を有するイメー ジングプレート (IP)(BAS-SR2025)を用いて背面反射 配置で測定した. 続けて同じ IP に無歪回折環および ビームセンターを求めるための標準試料としてアルミ ニウム粉末の回折環を多重露光した. 測定試料と標準 試料の交換操作は自動 X 軸ステージを利用すること でハッチ外より行った.



Fig. 2. CTE of resin-a and resin-b cured at 250° C as a function of temperature obtained by TMA analyses. The value of copper (16.8 ppm/K) is from literature data.



Fig. 3. Instrumental setup for residual stress measurements with an imaging plate detector by using $\cos \alpha$ method.

測定に用いた X 線のエネルギーは 8.0 keV, ビー ムサイズは 0.4 mm × 0.4 mm とし, X 線照射時間 は測定試料 2 min,標準試料 3 min とした.加熱プ ロセスは,40°Cから 250°Cへの昇温,250°C保持, 250°Cから 40°Cへの降温のサイクルを 2 回繰り返 した.250°Cでの保持時間は,1サイクル目は半導体 パッケージ成形後の熱硬化処理を想定した1h保持, 2サイクル目は硬化処理後の熱プロセスを想定した 30 min保持とした (Fig. 7).試料全体を均一加熱するた めに,試料とヒーターをカプトンフィルムで覆い,試 料温度はシート状熱電対を用いて Cu 箔上の温度とし て計測した.

樹脂/Cu界面の残留応力 (σ) は式 (1) を用いて算出 した [5]. 応力符号が正の場合は引張応力,負の場合 は圧縮応力である.

$$\sigma = \left(\frac{\cos^2 2\theta_0 \tan 2\theta_{0,\text{std}}}{2L_{\text{std}} \tan \theta_0}\right) \cdot \left(\frac{E}{1+\nu}\right) \\ \cdot \left(\frac{1}{\sin^2(\varphi-\eta) - \sin^2(\varphi+\eta)}\right) \cdot \left(\frac{d\Delta L}{d\cos\alpha}\right) (1)$$

ここで, 2 θ_0 および 2 $\theta_{0,std}$ は測定試料 (Cu) および標 準粉末 (Al) の無歪状態の回折角, L_{std} は標準粉末回 折環半径, E および ν は Cu 箔の弾性率 (65.0 GPa) お よびポアソン比 (0.343), 2 η は測定試料の回折角 2 θ_0 の補角である. α は Fig. 3 および Fig. 4 に $-\eta$ 側とし て示した検出面における 9 時方向から時計回りの方位 角, ΔL は式 (2) で定義されるパラメータであり, 式 (2) 中の ΔL は添字で示す方位角における標準試料と 測定試料の回折ピークトップの動径距離差であり,方 位角 α における回折ピークトップは,方位角 $\alpha \pm 0.5^{\circ}$ の範囲でセクター平均して得た1次元プロフィールの ローレンツ関数フィッティングにより算出した.

$$\Delta L = \frac{(\Delta l_{\alpha} - \Delta l_{\pi+\alpha}) + (\Delta l_{-\alpha} - \Delta l_{\pi-\alpha})}{2} \qquad (2)$$

解析には Al(422) 面と Cu(331) 面の回折環を用い, 8.0 keV における無歪状態での回折角を各々139.0° および 138.0° とした. 試料–検出器間距離は, 測定試料 74 mm および標準粉末 66 mm とし,式(1)における標 準粉末の回折角 2 $\theta_{0,std}$ は,標準粉末–検出器間距離を 74 mm と仮定した見掛けの回折角 142.5° を用いた. IP データの読取りには BAS-1800II を用い,読取画像 のピクセルサイズは, IP をサイズ既知の Al 箔でマス クした状態で X 線を露光して得た画像データから算 出した校正値 (49.88 μ m/pixel × 49.49 μ m/pixel) を 使用した.

結果および考察

Fig. 4に sample-A の硬化処理後 40°C における 2 次元回折プロフィールを示す.更に, Fig. 5に Al(422) 面および Cu(331) 面からの回折プロフィールについ て 1 次元化したものを α の関数として示す. 試料は



Fig. 4. Two-dimensional diffraction profiles of Cu (cured sample-A at 40°C before second heating process) and Al-powder measured on a single imaging plate at different sample-to-detector distances of 74 and 66 mm, respectively.

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)



Fig. 5. Diffraction peak profiles of Cu(311) and Al(422) as a function of azimutial angle α for cured sample-A at 40°C before second heating process.



Fig. 6. $\Delta L - \cos \alpha$ plot for cured sample-A at 40°C before second heating process.

Cu 箔/樹脂/Cu 箔の三層構造であるが、ピーク分裂の ない明瞭な Cu の回折環が得られてることより,裏面 Cu 箔からの X 線回折の寄与はシリカフィラーを含有 する樹脂層での X 線吸収によって無視できると考え られる. Fig. 5 および式 (2) より求めた $\Delta L - \cos \alpha$ 線 図を Fig. 6 に示す. $\Delta L - \cos \alpha$ 線図は全ての方位角 α , すなわち $\cos \alpha = 0 \sim 1$ の範囲でよい直線性を示 し,線形フィッティングより求めた傾き 0.221±0.005 mm および式 (1) より残留応力は 26.1±0.6 MPa と算 出された. この結果より,樹脂/Cu 界面には引張応力 が存在することが明らかとなった. IP および $\cos \alpha$ 法 を用いた本手法により,樹脂/Cu 箔界面における数十 MPa オーダーの残留応力を数分オーダーで測定する という課題に対し,試料への X 線照射時間 2 min と いう短時間での応力解析が可能となった.



Fig. 7. Change in residual stress at the resin/Cu interface during heating process.

次に,加熱プロセス過程における sample-A および sample-B の樹脂/Cu 界面の残留応力変化の解析結果 を Fig. 7 に示す.加熱プロセス時間(t)に伴う明瞭 な応力変化が得られた.これらの挙動を,樹脂の熱膨 張,硬化収縮,CTE などの観点より以下のように考察した.

(i) $t = 0 \min ($ 加熱プロセス前): sample-A と sample-B ともに未硬化試料は圧縮応力を示した.モデル材料の成形温度 (200°C) において樹脂が熱膨張した状態で界面が形成されるため、 40° C への冷却に伴う未硬化樹脂の熱収縮が樹脂/Cu界面に圧縮応力をもたらしたと推定される.

(ii) t = 0 - 40 min (硬化温度までの昇温過程): 250°C への昇温過程において, sample-A と sample-B ともに応力が増加し, 圧縮応力から引張応力へと変化 した. これは, 加熱による未硬化樹脂の熱膨張によっ て樹脂/Cu 界面に引張方向の応力が加わったためと推 定される.

(iii) t = 40 - 100 min (硬化過程):いずれの樹脂も 250°C 到達時から保持過程において引張応力が約 10 MPa 減少し,最終的に sample-A, sample-B の応力 は各々27,24 MPa となった.樹脂の熱硬化反応進行 による硬化収縮によって,引張応力が緩和されたため と推定される.

(iv) t = 100 - 140 min (硬化終了後の冷却過程):
sample-A は 250°C から 200°C (t = 110min) への冷却過程で応力は 27 MPa から 14 MPa に減少し,その後はほぼ一定となった.一方, sample-B は 250°C から 150°C (t = 120min) への冷却過程で応力は 24

MPa から 3 MPa に減少し,その後はほぼ一定となっ た.これらの挙動は,Fig. 2 に示す硬化樹脂単独の CTE 変化から説明ができる.すなわち,250°C から の冷却過程においていずれの樹脂も CTE が低下する が,樹脂 a は 200°C 付近で,樹脂 b は 230°C 付近で それぞれ CTE が Cu と一致し,それ以下の温度では Cu と同じ CTE を維持する.更に CTE の値より,250 °C からの冷却過程においては樹脂 a よりも樹脂 b の 方が熱収縮量は大きくなると推察される.この硬化樹 脂単独の CTE 変化が樹脂/Cu 複合材料にもほぼ反映 されており,sample-A より sample-B の方が硬化処 理後の冷却過程における熱収縮量が大きく,引張応力 が大きく緩和されたと推定される.

(v) t = 140 - 250 min (硬化品の加熱冷却過程): 応 力と温度の関係は, t = 100 - 140 min における硬化終 了後の冷却過程とほぼ同様の結果が得られ,可逆的な 変化であると推定される.硬化処理後のモデル材料の 樹脂/Cu 界面の応力変化は,硬化樹脂と Cu の CTE 差 (CTE ミスマッチ)の温度依存性によって説明が可 能であることが確認された.

以上より,今回検討した半導体パッケージ用封止樹 脂における樹脂/Cu界面の応力発生メカニズムは硬 化樹脂と Cuの CTE ミスマッチが要因のひとつとし て推定される.また,sample-A は常に引張応力が掛 かっている状態であり,sample-B は室温付近では引 張応力が緩和された状態となることが明らかとなり, これらが半導体パッケージの熱サイクル信頼性に影響 を及ぼしている可能性が示唆された.

今後の課題

今回得られた応力の妥当性は,同様に X 線回折法を 用いた評価手法である sin² Ψ 法による解析や有限要素 法によるシミュレーションなど他の評価手法による結 果との比較検証が必要である.また,本検討では室温 から 250°C からにおける熱時の加熱プロセスに関して 評価を行ったが,半導体パッケージの冷熱衝撃試験で は −40°C での評価も実施されるため,−40 ~+250°C での冷熱測定が可能な試料ステージ開発,および冷熱 時の残留応力その場観察技術開発が今後の課題であ る.更に,今後は冷熱衝撃試験を 100,500,1000 サイ クルなど実施した後のモデル材料を用い,樹脂/Cu 界 面の密着信頼性と応力変化の相関解明を目指す.

事業への貢献

今回検討した cos α 法による残留応力評価技術は, 半導体パッケージ用封止樹脂/Cu 界面の状態を非破壊 で解析することが可能な極めて有効な手法である.更 に数分オーダーという短時間計測が可能であるため, 本検討によって半導体パッケージの密着信頼性に大き く影響すると推定される熱衝撃下の応力変化を迅速に 捉える技術目処が立った.今後,本評価技術を当社の 半導体パッケージ用樹脂材料開発に広く展開していく 予定である.

謝辞

本測定を行うにあたり,兵庫県立大学放射光ナノテ クセンターの桑本滋生博士,漆原良昌博士,李雷博士, その他関係者の皆様より多数の技術協力とご助言をい ただきました.また,残留応力解析にあたり,神戸大 学・西野孝教授にご指導いただきました.感謝申し上 げます.

参考文献

- [1] 田中啓介 他:「放射光による応力とひずみの評価」 養賢堂, 東京 (2009).
- [2] K. Nakamae et al.: J. Appl. Polym. Sci. 40, 2231 (1990).
- [3] T. Nishino *et al.*: J. Appl. Polym. Sci. 45, 1239 (1992).
- [4] 若林みどり 他: SPring-8/SACLA 利用研究成果集 3, 589 (2015).
- [5] 若林みどり 他: SPring-8/SACLA 利用研究成果集 4, 275 (2016).
- [6] 若林みどり 他: SPring-8/SACLA 利用研究成果集 4, 294 (2016).
- [7] 佐々木敏彦他:材料 44, 1138 (1995).
- [8] 王他:日立評論 95, 454 (2013).
2015B3231

Liイオン電池正極材断面のX線マイクロビームによる反応分布解析

Reaction Distribution Analysis of Cathode Material of Lithium Ion Battery by X-ray Micro-Beam Imaging Method

三根生 晋¹, 首藤 大器², 竹田 晋吾², 横山 和司², 住田 弘祐¹, Susumu Mineoi¹, Motoki Sudo², Shingo Takeda², Kazushi Yokoyama², Hirosuke Sumida¹

¹マツダ株式会社 技術研究所,² 兵庫県立大学放射光ナノテクセンター ¹Mazda Motor Corporation Technical Research Center, ²Synchrotron Radiation Nanotechnology Laboratory, University of Hyogo

概要:サイクル試験前および試験後のリチウムイオン電池から採取した正極を用いて,充放電過程における合 剤断面の反応分布をX線マイクロビームにより評価した.充放電レートを0.5 Cとした場合,試験後試料で はシグナル強度変化の程度はセパレータと接する表面と集電箔と接する内部で異なっていた.一方,試験前試 料では表面と内部のシグナル強度変化が同程度に生じた.サイクル試験後試料は,合剤内部でのリチウムイオ ン吸蔵・放出の反応が阻害されていると分かった

キーワード:X線マイクロビーム,イメージング分析, XAFS

背景と研究目的

リチウムイオン電池(Lithium Ion Battery: LIB) はエネルギー密度と入出力特性をバランスさせること により,小型機器から大型移動体まで幅広く適用が進 められている.LIBを用いた製品が,お客様のもとで 必要とされる機能を維持するためには,各製品で特徴 的なLIBの使い方とそれによる性能変化の原因を十 分に理解して製品設計することが求められる.著者ら は,2014B期にサイクル試験後の18650サイズ LIB から採取した正極を用い,分析セルを充放電しながら 正極合剤断面をX線マイクロビームでイメージング分 析して,活物質が状態変化する様子を報告した[1,2]. 本取組みでは,サイクル試験前後のLIBから採取し た正極を用いてX線マイクロビームでの分析を行い, 合剤断面での反応分布について比較解析することを目 的とした.

実験

正極は,露点管理されたグローブボックス内で LIB (18650 サイズ)を解体して採取し,ジメチルカーボ ネートでの洗浄,乾燥を行った.分析対象とする合剤 断面は,切り出した正極表面に対して垂直方向へ鋭利 な刃物で切断する方法で作製した.分析セルは切断加 工後の正極材を作用極,金属Li箔を対極としてグロー ブボックス内で組み立て,実験に用いた.

実験は SPring-8 兵庫県ビームライン BL24XUにて 実施した.実験時のビーム条件は、ビーム強度 5×10^9 photons/sec. (at 8333 eV)、ビームサイズは鉛直方向 1.6 μ m,水平方向 4.2 μ m であった.検出器には Lytle 検出器を使用し、蛍光法 (Ar ガスフロー)で測定を 行った.イメージング分析は、試料ステージを 1 μ m ステップで作動させて X 線マイクロビームの照射位 置を制御しながら電極厚さ方向に 80 μ m,面内方向 に 32 μ m のイメージング像を得た.このとき各点の acquisition タイムは 0.1 秒,1 画像の取得時間は約7 分であった.画像データの規格化処理方法は前報 [2] の通りである.

結果および考察

サイクル試験前の試料について,0.5 C で充放電し た場合の充放電曲線と規格化処理後のイメージング分 析結果を Fig. 1 に示す.なお, Fig. 1 中の添字 1~10 は分析を実施したタイミング, Fig. 1(C) は電極合剤



Fig. 1. Imaging results of cathode cross section at 0.5 C : (A) sample setting, (B) voltage curve and (C) normalized images.

部分のみを切り出した画像である.充電を開始すると, 先ずセパレータ側でシグナル強度が低下した.充電を 継続すると,電極材のセパレータ側から Al 集電箔側 に掛けて全体的にシグナル強度の低下していく様子が 確認された.充電停止後の開回路保持中,シグナル強 度の分布には顕著な変化が見られなかった.次いで放 電を開始すると,シグナル強度が全体的に上昇した.

サイクル試験前試料と試験後試料の充放電過程での 反応分布を解析するため、イメージング分析により取 得したデータをラインプロファイル化して、その形状 変化を比較した.サイクル試験後試料を 0.5 C で充 放電した場合の充放電曲線を Fig. 2 に示す. Fig. 2 中の添字 11~20 はイメージング分析データを取得し



Fig. 2. Voltage curve of cycle tested cathode at 0.5 C.

たタイミングである. ラインプロファイル化の詳細は Fig. 3 に示すようにセパレータ側から集電箔側に掛 けてデータを読み取り,これを平均化した.

サイクル試験前試料および試験後試料のラインプロ ファイルを Fig. 4 に示す. 充電を開始すると,サイ クル試験前,試験後どちらの試料も先ずセパレータ側 でシグナル強度が低下している.



Fig. 3. Line profiling from imaging results.



Fig. 4. Line profiles of imaging results at 0.5 C : (A) new cathode during charging, (B) new cathode during discharging, (C) cycled cathode during charging and (D)cycled cathode during discharging.

充電を継続すると試験前試料はシグナル強度が全体 的に低下する様子が確認された.一方,試験後試料で は電極材表面のシグナル強度が低下し,電極材内部の シグナル強度低下は小さい.次いで放電を開始すると, 試験前試料および試験後試料ともシグナル強度が充電 前の状態まで上昇した.このラインプロファイル比較 から,サイクル試験後の正極合剤では,集電箔に近い 合剤内部でリチウムイオンの吸蔵・放出反応が阻害さ れていると考えられる.また,サイクル試験前試料の ラインプロファイル形状をほぼ保ったままシグナル 強度変化しているが,充電時はやや電極合剤内部のシ グナル強度変化が小さい.本取組みで用いた正極は充 電時に反応分布が発生し,表面側に存在する活物質に 負荷が掛かる可能性が考えられる.

まとめと今後の課題

LIB から採取した正極合剤内部での反応分布を解析 するために、X線マイクロビームによるイメージング 分析を適用することで、合剤内部でのリチウムイオン 吸蔵・放出の反応が阻害されていると分かった。更に 高レートにおいても、データの精度を確保しつつ分析 可能とすることで、電池材料の変質や状態評価を詳細 に検証可能となることが期待される。

事業への貢献

本研究から得られた技術により,リチウムイオンニ 次電池の電極合剤内部における反応分布を解析するこ とができる.車両から求められる幅広い入出力条件下 での反応挙動を解析し,制御因子の明確化やメカニズ ム解明に利用する予定である.

- [1] 住田弘祐: SPring-8 利用課題実験報告書 2014B3231.
- [2] 三根生晋 : 兵庫県ビームライン年報・成果集 4, 18 (2015).

2013B3320, 2014A3320,2014B3320,2015A3320

BL08B2

In-situ XAFS/SAXS 同時測定による Au ナノ粒子生成過程解析

Formulation Process Analysis of Au Nano-particle by Coupled In-situ XAFS and SAXS

東口 光晴,坂本 直紀 Mitsuharu Higashiguchi, Naoki Sakamoto

¹ 旭化成株式会社 Asashi Kasei Corporation

概要:液相からのナノ粒子の生成過程を評価する手法として,価数変化と粒子成長過程を XAFS/SAXS 同時 測定にて観察する手法確立を目指した.HAuCl₄ 溶液の還元による Au ナノ粒子生成を例として,金属への価 数変化,粒子生成,溶液の見た目の変化が対応した一連の解析結果を取得することができ,ナノ粒子の生成過 程を俯瞰する測定技術の確立を達成した.

キーワード:ナノ粒子, XAFS, SAXS, in-situ

背景と研究目的

金属ナノ粒子は、比表面積が極めて大きいことや、 電子の閉じ込めに由来した量子効果により通常の材料 とは異なる光学特性等を示すことから、触媒、塗料、 構造改質剤、電子材料等様々な分野で用いられてい る [1]. 金属ナノ粒子の特徴として、粒径や分布、モ ルフォロジーの違いが物性に直結するため、これら粒 子特性の精密制御が工業的に重要な課題となる.

金属ナノ粒子は液相法や気相法で作られるが[1],液 相法は大量生産に適しており,また濃度や温度の管理 が容易であるため広く用いられている.液相法の中 でも還元剤を用いて,金属イオンを再析出させる還元 法は,手法の簡便さから工業的にも利用しやすい.金 属ナノ粒子の生成は,金属イオン溶液へ還元剤を投入 後すぐには起こらず,誘導期間を経て粒子の生成が生 じる.誘導期には,金属イオンの還元と核の生成が起 こっていると考えられるが,製造での評価は,生成後 の金属ナノ粒子で行うため,誘導期に関する知見は少 ない.そのため,新規の粒子特性を持つ,金属ナノ粒 子を製造する際には,その都度,製造条件の見直しが 必要となる.誘導期を理解し,粒子の生成,成長がど のようなタイミングで起こっているか知ることができ れば,試作時間の短縮に寄与できると期待される. 今回,金属ナノ粒子の中でも、多くの報告例がある Auナノ粒子の生成過程を利用し、XAFS/SAXS 同時 測定により、ナノ粒子の生成過程に重要な還元と粒子 成長過程を同時に観察する手法の確立を目指した.本 手法は、Au以外のナノ粒子への展開や、価数変化と 構造変化が起こる触媒反応にも展開が見込まれるた め、多くの製品開発に寄与できると期待している.

実験

Au ナノ粒子の作成は,一般的に用いられている, HAuCl₄ 溶液にクエン酸ナトリウムを加え,還元によ り析出させる方法を選択した.HAuCl₄ 溶液とクエン 酸溶液の濃度は,過去の類似の測定の文献を参考にそ れぞれ,0.25 mmol/L と 2.5 mmol/L とした [2]. 試 料の調整は,放射光ハッチ外で行い,両溶液をバイア ル瓶中で良く混合させた後, φ2mmの石英キャピラ リーに入れ測定に供した.試薬類は,混合直前まで冷 蔵しておき,混合は室温で行っている.

XAFS/SAXS 同時測定は,兵庫県ビームライン BL08B2の第2ハッチにて実施した.Fig.1に測定の セットアップ図を示す.試料温度は室温(25°C)とし た.XAFS測定は,Si(111)-2結晶分光器を使用し,Au-L_{III}端(11920 eV)にて蛍光法の Q-XAFS を行った. 蛍光 X 線の検出器には Lytle 検出器を用いた.SAXS

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)



Fig. 1. Schematic view of coupled *in-situ* XAFS and SAXS experimental set-up.

測定は, 試料からのカメラ長 1940 mm とし, 検出器 には PILATUS-100k を利用した. Au 吸収端の影響 を避けるため, 測定は吸収端よりエネルギーの低い 11810 eV (波長:0.105 nm)とした. 得られた2次 元 SAXS パターンは透過率, 空セル散乱補正をおこな うとともに, 円環平均により1次元化して解析に供し た. 空セル散乱としては未反応の液の散乱を用いた. 本実験では金ナノ粒子生成に伴い, 溶液が濃い赤色を 呈してくる. そこで, 石英キャピラリーに試料をセッ トした後にバイアルビンに残った溶液についてビデオ 撮影を行い, 目視で着色する時間を計測した. また, XAFS/SAXS 同時測定に供した石英キャピラリー中 の溶液の色の変化についてもカメラによりモニター した.

本時分割 XAFS/SAXS 同時測定における測定サイ クルは、3.5 分である.下記に各サイクルでは以下の 順に試料の外観、SAXS、XAFS 測定を実施した.

① 溶液の画像撮影

- ② XAFS 開始エネルギーにて SAXS を 10 秒露光で 測定
- ③ Q-XAFS 測定

混合から測定までのタイムラグが発生するため,別途 時刻を計測し結果に反映させている.

結果および考察

Fig. 2に Au ナノ粒子生成過程の Au- L_{III} 端 XAFS スペクトルの重ね書きを示す.赤から青へと時間が経 過している.矢印で示した,11923 eV 付近の Au- L_{III} 吸収端スペクトルピークが,時間と共に減少してい く様子が観測されている.参照試料 (HAuCl₄(Au³⁺), AuCl(Au¹⁺), Au 箔 (Au⁰⁺))の測定から,Au- L_{III} 吸 収端スペクトルピークは,高価数ほど鋭く,一方で金 属になると消失する傾向が見られた.そのため,Fig. 1 の変化は,還元過程を見ていると考えられる.また, 経時変化の最終スペクトルは,Au 箔とほぼ一致して



Fig. 2. Normalized $Au-L_{III}$ -edge X-ray absorption spectra during formulation process of Au nanoparticle.

おり金属まで還元が進んでいると推測された. 還元過 程をさらに詳しく見るために,吸収端の経時変化を導 出した.吸収端の位置は、スペクトル規格化後のエッ ジジャンプの強度 0.5 となるエネルギーで定義した. Fig. 3に Fig. 2のスペクトルから導出した吸収端エネ ルギーの経時変化を示す. 横軸は溶液を混合した時か らの時刻としている.最終的に金属まで還元が進むと して、価数変化が一定となったところを+0価、AuCl 標準試料の吸収端位置を+1 価として図に示した. 混 合からの時間をゼロに外装して,およそ1価分,価数 変化していると推測された.また,混合から 50-60 分 後以降は、吸収端位置はほぼ一定で、それ以上還元が 進行していないと推測される. 原料の HAuCl₄は, +3 価であるため,混合後すぐに+1価まで急激に還元が 進み、その後緩やかに+0価に向け還元が進むのでは ないかと推測される.

Fig. 4 に Au ナノ粒子生成過程における SAXS プ ロフィール変化を示す. 横軸は式1 で表される散乱ベ クトルの絶対値である. なお, θ は Bragg 角, λ は X 線波長である.

$$q = 4\pi \sin \theta / \lambda \tag{1}$$

反応開始後,40分程度まではほとんど散乱が観測され ておらず,SAXSで捉えられるようなナノ構造は形成 されていないと考えらえる.一方,40分以降Auナノ 粒子由来の散乱強度の増大が観測されている.なお,



Fig. 3. Time-dependent absorption-edge energy of Au- $L_{\rm III}$, in which energy of Au-foil(+0) and AuCl(+1) are also represented as references.

より詳しく SAXS プロフィール変化を見ると 40 分以 降47分程度まで小角領域の散乱が増加した後,54分 程度まで一度散乱強度が減少している. さらに, その 後再び散乱強度は増加に転じるが、散乱ショルダーの 位置は 40-51 分のものよりも広角に存在している.形 成される Au ナノ粒子のサイズを定量的に考察するた めに, Fig. 4の40分以降のSAXSプロフィールを 式2で表される半径分布を考慮したランダム配向シリ ンダー構造を持つ孤立粒子の理論散乱式でフィッティ ングし,各種パラメータを得た.半径の分布は体積分 率が Schultz-Zimm 分布に従っていると仮定した.な お、 $\Delta \rho_e$ は溶媒と金粒子の電子密度差、N は粒子の 数密度, r, l はシリンダー(ひも)状構造の半径と長 さ、 σ は半径 rの標準偏差、 J_1 は1次のベッセル関 数、Si(x) は積分正弦関数である. $l \gg r$ を仮定して いる.



Fig. 4. SAXS profiles during formulation process of Au nano-particle.

なお, Fig. 4の SAXS プロフィールは球状粒子を仮定 した理論散乱式ではうまくフィッティングできず,ひ も状構造を仮定したほうがよく実測 SAXS プロフィー ルを再現できた. Fig. 4には式 (2) により行ったフィッ ティングの結果についても合わせて示している. 実際 の粒子形状について電子顕微鏡による確認は行ってい ないが,文献ではひも状の構造が形成される例も報告 されており [3],ここではひも状構造を仮定して解析 を行った.また,Auナノ粒子の量(体積)の指標と して,式(3)で表される Invariant Q を計算した.な お,積分範囲は $0.07 < q < 1.2 \text{ nm}^{-1}$ とした.特に 小角領域の積分範囲が不十分だが,生成したAuナノ 粒子の量(体積)の傾向は追えると考えられる.

こうして計算されたひも状構造の平均直径 *d*,及び Invariant *Q*の時間変化を Fig. 5 に示す.反応後 40

$$I(q) = \Delta \rho_e^2 N \int_0^\infty P(r) F^2(q, r, l) dr$$

$$F^2(q, r, l) = \frac{8(\pi r^2 l)^2}{ql} \left[\operatorname{Si}(ql) - \frac{1 - \cos(ql)}{ql} \right] \left[\frac{J_1(qr)}{qr} \right]^2$$

$$P(r) = \frac{P'(r)/V(r)}{\int P'(r)/V(r) dr}$$

$$P'(r) = \frac{M^M}{\Gamma(M) r_0^M} r^{M-1} \exp\left(-\frac{M}{r_0}r\right)$$

$$M = \sigma^{-0.5}$$

$$(2)$$



Fig. 5. Time-dependent diameter of particles (left axis) and Invariant Q (right axis), assume that shape of nano-particle is wire.

分の SAXS プロフィールについてはうまく式 (2) で フィッティングできておらず,得られた平均直径 *d* の 精度が低いと考えられることに注意して欲しい.

$$Q = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty I(q) q^2 dq \tag{3}$$

Fig. 2~5を見ると,まず,XAFSから得られるAu 元素の価数変化とSAXSから得られるナノ粒子成長 とで時間変化が異なることがわかる.Fig. 3,5より, Au 原子の還元は反応開始直後から進行するが,ナノ 粒子の形成はかなりAu 原子の還元が進行した後に初 めて開始することがわかる.さらに,Fig.5のdとQ の変化を見てみると,dは一度15nm程度まで増加し た後,一度8nm程度まで小さくなった後,再び増加 に転じている.一方,Qについては同様に途中で一度 減少しているが,その減少の程度は小さい.Invariant を求める際の小角側の積分範囲が不十分であることを 考慮するとInvariantについてはほぼ時間と共に単調 増加している可能性もある. *d*と*Q*の時間変化は,40 分以降に形成されたナノ粒子は凝集構造を形成してお り,それが一度,分裂した後,再び成長するという過 程を示しているのかもしれない.40分以降は,価数 変化がほぼ金属として一定になっていることから,金 属状態の核が溶液全体に生成したのち,徐々にそれら が結合してナノ粒子として成長する過程を見ている可 能性が推測される.なお,今回,SAXSの解析ではひ も状の構造が形成されると仮定して行ったが,Fig.4 のSAXSプロフィールの形状変化から考えて,仮に 実際のAu粒子の形状が別のモルフォロジーであった としても Fig. 5の*d*の変化は定性的には正しいと考 えらえる.

最後に,バイアルビンに残った溶液についてビデオ 撮影結果について言及する.Fig.6にビデオからキャ プチャーした画像を示した.数字は混合からの時間を 示している.およそ30分後程度から溶液の色が変化 し始め,45分程度には,ほぼ液全体が黒く変色し,ナ ノ粒子が析出したことが推測される.この色の変化が 起こるタイミングは,XAFSの価数変化がほぼ一定値 に落ち着き,SAXSの散乱が観測され始める時刻とお よそ一致する.以上の事から,溶液の見た目の変化, 価数変化,粒子生成を対応付けることができ,本手法 が目的通り還元と粒子成長過程を同時に観察する手法 として確立されたとした.

今後の課題

今回,XAFS/SAXS 同時測定手法の確立を目的に 実験を行い,数十分程度で起こる粒子生成過程の観察 が可能であることを確認した.一方で,希釈溶液のた め XAFS 測定の感度が小さく,それが時間分解能の 律速になっている事や,放射光ハッチ外での事前の均 一混合が必要なことから,価数変化の初期からの測定



Fig. 6. Time-dependent color of residue in a vial container (Numbers show time from mixing).

は現状できないことが課題として挙げられる.工業的 な応用を念頭にした場合,プロセス上,迅速な粒子成 長過程や混合タイミングが課題となるような系が存 在する.今回の測定で,ナノ粒子生成過程を観察する のに適切な手法であることが分かったため,今後は, XAFS 感度を高める方法や放射光ハッチ内での溶液混 合手法を開発することも念頭に手法の開発を進めたい.

事業への貢献

弊社では,経営多角化に伴い,様々な商品を取り 扱っている.今回解析対象とした液中の粒子生成過程 を用いる工業製品も触媒,塗料,構造改質剤,電子材 料等多岐にわたる為,それらの製品開発を加速するた め,生成メカニズムの提供という形で貢献できると考 えている.

謝辞

今回の研究を行うに当たり,兵庫県立大学産学連携・ 研究推進機構放射光ナノテクセンターの桑本滋生氏, 野瀬惣市氏,李雷氏をはじめ多くの方々にお世話にな りました.この場を借りてお礼を申しあげます.

- [1] 小石眞純,石井文由著:「ナノ粒子のはなし」初版 第1刷,日刊工業新聞社 (2006).
- [2] J. Polte et al.: J. Am. Chem. Soc. 132, 1296-1301 (2010).
- [3] X. Ji et al.: J. Am. Chem. Soc. 129, 13939-13948 (2007).

2014A3264, 2015A3264, 2015B3264, 2016A3264, 2016B3264

BL24XU

X線CTを用いた各国女性毛髪の観察

Observation of Hairs in Various Countries Using X-ray CT method

伊藤 廉、渡邉 紘介、前田 貴章、鈴田 和之 Len Ito, Kousuke Watanabe, Takaaki Maeda, Kazuyuki Suzuta

> 株式会社ミルボン 中央研究所 Central Research Institute, Milbon Co. Ltd.,

概要: 文化や生活習慣の違う各国女性毛髪に生じるダメージ現象を明らかにすることは重要である.本研究 では、毛髪内密度の測定と、その内部を非破壊でかつ高分解能で観察するために放射光を用いた X 線 CT 測定 を行い、文化や生活習慣の違う各国女性の共通のダメージを探索することを目的として実験を行った.各国女 性毛髪は、根元に比べて毛先の毛髪内密度が減少していることを確認するとともに、密度減少した毛髪は、繊 維方向に向かって棒状の空洞が生じていることを共通現象として確認した.更に、この共通現象を解消すべく、 原料の探索を行ったところシルク由来のペプチドが有効であることが分かった.

キーワード: X線 CT,毛髪,毛髪内密度,化粧品

背景と研究目的

毛髪にハリ・コシ,うるおい,ツヤ感などの風合い を与えることは,頭髪化粧品に対して消費者から要望 される機能の1つである.従って,これらの風合いを 科学的なパラメーターで忠実に表現するための様々な 研究がなされている.各化粧品メーカーでは,グロー バル化を想定した様々な基礎科学的アプローチから毛 髪研究が進められてきた.その代表的な例として,各 国間における毛髪径や楕円率の違い [1],メデュラの 違い [2],及び毛髪表面を覆うキューティクルの枚数 の違い [3] などが挙げられる.このような中,我々は 様々な実験視点から各国女性の毛髪解析を行ってきた.

毛髪内の密度に関しては、1970年代に行われたパー マネントウェーブ処理やブリーチ処理による密度変化 に関する研究から [4,5],これらの美容処理では毛髪 密度はほとんど変化しないと考えられてきた.しかし 最近,筆者らによって精度良い毛髪内密度の測定法が 見出されたことで [6,7],毛髪内の密度変化に着眼し た新たな商品に向けた研究が進められてきた [8].ま た,一般的には、毛髪内部の変化を見る方法として透 過型電子顕微鏡などを用いた毛髪断面観察も行われ ているが、これらは毛髪内部を非破壊的に見ることが 出来ない欠点もある.本報告では,まず根元や毛先といった毛髪部位と毛髪内密度の関係を明らかにし,その後,密度が減少している毛髪内部を非破壊的に測定することが出来る SPring-8 兵庫県ビームライン X 線CT 測定にて観察した結果を詳説する.

実験

相対湿度 50%, 25°C において 1 晩調湿された各国 女性の根元部分(新生部分)と毛先部分(根元より 約 30cm 部分)の毛髪内密度(単位体積当たりの質量: g/cm³)を測定した.毛髪内密度を回復させるケラチ ンの探索としては,1%ケラチンを調整し,その溶液 に毛髪を浸漬,洗浄,乾燥後,相対湿度 50%,25°C に おいて 1 晩調湿し,密度測定を行った [9].

密度測定より有意に密度減少をとらえた毛髪を 0.2 mm ϕ のカプトンキャピラリーに約 4 本入れ,室温, 大気圧下で SPring-8 ビームライン BL24XU にて測定 を行った.測定に用いた X 線は 7.0 keV の単色光で あり,投影数約 1000 枚の画像データより CT 再構成 を行い,3次元構造を求めた [10].



Fig. 1. Density of root and tip hairs of each region. Root, the proximal root part of hair; Tip, at about 30 cm from the proximal root part of hair.

結果および考察

(i) 各国毛髪の密度変化

Fig. 1に各国における根元部分(新生部分)と毛

先部分の毛髪内密度を示した.毛髪の伸長は一日で約 0.4 mm という報告から [11],根元より 30 cm 先の毛 先部分とは,約2年間(約0.4 mm ×約730日 =約 292 mm)になされた美容施術や生活習慣によって生 じたダメージを蓄積したものと考えられ,その毛先部 分は,どの国においても根元部分より密度が低くなっ ていることが明らかになった.これら密度が減少する ことによって,毛髪内部がどのように変化したのか可 視化を試みた.

(ii) 毛髪内部構造の評価 ~ X 線 CT を用いた検討(SPring-8 BL24XU) ~

毛髪内密度変化が何に起因しているか考察するた めに,透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて毛髪の横 断面切片の観察を行った [12].その結果,密度を失っ た毛髪内部の空隙数が増加していることが判明した (data not shown).しかし,横断面切片を作成する 際のカッティング影響など,破壊操作時における損傷 の可能性を拭い去ることができなかったため,非破壊 法である X 線 CT 法を用い毛髪の内部構造を観察し た.毛髪の内部構造を得るためには高い空間分解能を



Fig. 2. 3D images of root and tip hairs of each region using X-ray CT method at SPring-8 (BL24XU). The Root, for the most similar image in each region, showed one typical example. At 0 and 15 degree angle to fiber axis including cuticles layer. At 90 degrees angle to fiber axis. The Stick Shaped shadows in the hair are voids.

必要とするため, SPring-8 BL24XU (兵庫県 ID) で 利用可能な放射光結像X線 CT 装置を用いた.本 CT 装置は光学系にフレネルゾーンプレートによる拡大結 像顕微鏡を採用しており,デフォーカス測定によりソ フトマテリアル試料をサブミクロンの空間分解能で観 察することができる.その結果,各国女性の毛先部分 の毛髪はその根元部分に比べ,空隙の増加傾向を観測 した (Fig. 2).空隙は,繊維方向に棒状の形を有し ており,我々はこの現象を Stick Shape Voids (SSV) と呼んでいる.このように毛先部分で棒状の形をして いることにより,毛先部分で枝毛が起こりやすかった り,空隙の影響でツヤなどの低下が起こると考えてい る.現在のところ,損傷部位の同定には至っていない が,分解能を更に向上することで,損傷メカニズムを 明らかにしていきたいと考えている.

(iii) SSV を回復できる成分の検討

これまで, 我々は SSV の主要な原因が毛髪タンパ ク質の流出によって起こることを報告している [13]. この SSV を回復させるべく, 1%ケラチンを用いて密 度を回復することのできるケラチンを探索したとこ ろ,シルク由来のペプチドが唯一密度を回復させるこ とができることを確認した (Fig. 3).また,このよ うに毛髪内密度が回復した毛髪を用いて X 線 CT 測 定で観察したところ,毛髪内に生じていた空隙の減少 を捉えることができた (Fig. 4).このように,シル ク由来のペプチドはあらゆるダメージによって毛髪内 に生じた空隙を埋めることできる成分であることを確 認した.

まとめと今後の課題

本稿では、20ヶ国の女性毛髪の共通のダメージ現象 を捉えることを目的に実験を行った.その結果、毛髪 内密度が低下した毛髪(毛先部分)の毛髪をX線CT により内部構造を観察した結果、空隙数の増加を確認 した.更に、この空隙を埋めるための探索として密度 測定、X線CTを用いて確認を行った結果、シルク由 来のペプチドが有効であることを確認した.多様化し た顧客のニーズに応えるべく、最先端の分析や計測技 術を駆使することで新たな現象を解明し、製品の開発 に応用していきたい.



Fig. 3. Hair density enhancing component screening. Results of the density measurement after treating each of the components. A-C are various kinds of peptides. D is a peptide derived from silk.



Before treatment

After treatment

Fig. 4. 3D images of 0.01% Silk-derived peptide treated hair before and after using X-ray CT method at SPring-8 (BL24XU).

事業への貢献

本研究成果によって見出されたシルク由来のペプチ ドは、弊社主力ブランド"milbon"の共通成分として 配合され、世界 8 か国で現在発売をされている [14]. 本研究より見出された棒状空洞化は国内のメディア露 出 [15,16],更に最先端の技術によって可視化した画像 は、海外の美容師ないし一般顧客に対し、視覚的で分 かりやすいと好評で、国内外で注目を集めた研究内容 となっており、商品価値の向上につながったと考えて いる.

謝辞

今回の研究を遂行するにあたり,兵庫県立大学産学 連携・研究推進機構放射光ナノテクセンターの漆原良 昌研究員,東北大学 高野秀和准教授には測定に関し て多大なる支援をいただきました.この場を借りて御 礼申し上げます.

- H. Otsuka and T. Nemoto: Koshokaishi 12, 192-197 (1988).
- [2] B. M. Das: Morph. Anthorop. 63, 102-109 (1971).
- [3] S. Hayashi et al.: Biology and disease of the Hair, 555-561 (1976).

- [4] N. Yin et al.: J. Soc. Cosmet. Chem. 28, 132 (1977).
- [5] C. R. Robbins: Chemical and Physical Behavior of Human Hair p.482 (2006).
- [6] L. Ito et al.: J. Hair Sci. 115, 3-6 (2015).
- [7] L. Ito et al.: Fragrance J. **41**(11), 18-22 (2013).
- [8] L. Ito et al.: SPring-8 Research Frontiers 2014, 94-95 (2015).
- [9] 特開 2016-61664.
- [10] H. Takano et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 52, 040204 (2013).
- [11] C. Saint Olive Baque et al.: Int. J. Cosmetic Sci. 34, 111-116 (2012).
- [12] I. J. Kaplin et al.: Cosmet. Toil. 97(8), 22-26 (1982).
- [13] 渡邉紘介 他: 日本放射光学会誌 28, 210-213 (2015).
- [14] ミルボンホームページ: http://www.milbon.co.jp/brand/detail/48
- [15] 2016.2.1 化学工業日報「世界ブランド立ち上げ」
- [16] 2016.4.19 日本経済新聞「ミルボン,毛髪内の密 度高める成分配合 ヘアケア剤発売」

2015B3389

小角 X線散乱法によるナノフィラーの分散状態解析

Distribution Analysis of Nano Size Hollow Particles Dispersed in Polymer Matrix by Small-Angle X-ray Scattering

三根生 晋¹, 石津 嘉子¹, 古賀 広之¹, 角島 信司¹, 桑本 滋生², 漆原 良昌², 李 雷², 野瀬 惣市², 横山 和司², 住田 弘祐¹

Susumu Mineoi¹, Yoshiko Ishizu¹, Hiroyuki Koga¹, Shinji Kadoshima¹, Shigeo Kuwamoto² Yoshimasa Urushihara², Lei Li², Souichi Nose², Kazushi Yokoyama², Hirosuke Sumida¹

1マツダ株式会社 技術研究所,2 兵庫県立大学放射光ナノテクセンター

¹Mazda Motor Corporation Technical Research Center, ²Synchrotron Radiation Nanotechnology Laboratory, University of Hyogo

概要:中空ナノフィラーを樹脂に添加した複合材料を用いて、フィラーの分散状態を小角 X 線散乱法により評価した。散乱曲線の解析に中空ナノフィラーの形状を反映させるため、透過電子顕微鏡(TEM)観察を行って 形状を確認し、中空ナノフィラーの特徴的な形状を表現するため円板モデルを適用した。円板モデルを用いた 解析により、良好なフィッティングと分散状態に関するパラメータが得られた。小角 X 線散乱手法は、散乱体 が特異な構造をもつ中空ナノフィラーの分散状態解析において有効であることが分かった。

キーワード:小角 X 線散乱,中空ナノフィラー,複合材料,透過電子顕微鏡観察

背景と研究目的

持続可能な社会の実現に向けて自動車ではエネル ギー利用効率向上が必要である.動力機関の性能向 上, 電動デバイス搭載によるエネルギーロス低減など に加えて、車体の軽量化は必須である.近年、自動車 を含むさまざまな製品で炭素繊維やガラス繊維を分散 させた樹脂複合材料を金属部品に置き換え, 強度や剛 性を維持しつつ軽量化が図られている.樹脂複合材料 の機械的特性に着目すると、繊維や粒子の分散配置が 特性向上のために重要な制御要因であり、更に添加さ れる繊維や粒子サイズがマイクロからナノスケールへ と微細化している.しかしながら、単純に添加材の微 細化のみを行って混合した場合、樹脂母材中で凝集し て塊状態となり易く、均一もしくは狙った分散状態が 得られず部材特性としても狙った特性が得られない. そのため、ナノサイズの添加材の分散状態を評価し、 樹脂複合材料の特性とモルフォロジーを結び付けた研 究,検証が必要である.本件では、ナノサイズの粒子 を樹脂に分散させた試料を小角 X 線散乱手法で分析 し、粒子形状を考慮したモデルを散乱曲線の解析 [1,2] に適用することで、小角 X 線散乱手法によるナノ粒 子分散状態評価の有効性を検討した.

実験

ナノサイズ粒子として中空ナノフィラー(材質:シ リカ,メーカーカタログ平均径:100 nm)を用い,複 合材料は中空ナノフィラーを樹脂(含トルエン溶媒) に,10vol%添加して撹拌・混合した後,金属板上に成 膜し,熱処理を行うことで作製した.なお,熱処理後 の試料厚さは約0.5 mmであり,約10 mm×10 mm に切り出して測定試料とした.比較のため,熱処理ま で複合材料と同じ工程を経た樹脂単体,ポリイミド フィルムで挟みこんだ中空ナノフィラーを測定試料と した.

実験は SPring-8 兵庫県ビームライン BL08B2 にお いて二次元半導体検出器 PILATUS を用い,X線エネ ルギー:8 keV(波長:0.155 nm),カメラ長:6 m お よび 0.5 m の条件で測定を行った.

取得した 2 次元データは解析ソフト Fit2D [3] を用 いて円周方向積分と散乱強度-散乱角 (20) または散乱 ベクトル (q) の出力を行い,カメラ長 6 m の散乱強度 を補正し,カメラ長 0.5 m のデータと連結した.カメ ラ長 6 m と 0.5 m の連結した散乱曲線について解析 ソフト NanoSolver (リガク製)を用いてフィッティン グを行った.

中空ナノフィラーの形状観察は,透過電子顕微鏡 JEM-3000F(日本電子製)を用いて行った.

結果および考察

Fig.1 に, TEM を用いて中空ナノフィラーの形状観 察した結果を示す.ナノフィラーの形状は球形ではな く,角張った立方体に近い形状であることを確認した.



Fig. 1. TEM image of nanoparticles.

複数視野の観察から,粒子外径は 50~150 nm であ り単分散ではないが,粒子壁厚さは約 10nm で粒子に 寄らず比較的均一であった.

Fig.2 に中空ナノフィラー単体の小角 X 線散乱測定 により得られた散乱曲線を示す.なお,Fig.2 の散乱 曲線は,中空ナノフィラー粉末を挟み込むために使用 したポリイミドフィルムの測定データを用いてバック グラウンド処理を行っている.

この散乱曲線では、 $\log(q) = -1.2$ 付近に肩が認め られる. 散乱ベクトル qと構造の大きさ(もしくは構 造の繰り返し間隔 d)の関係式 (1) より d = 100 nm が 得られる.

$$q = 2\pi/d \tag{1}$$

この値と TEM 観察の結果から,立法体形状の中空ナ ノフィラーで向かい合った壁面の大きさが散乱体の構 造特徴として現れていると考える.そこで,中空ナ



Fig. 2. SAXS profile of nanoparticles.

ノフィラーの壁面を円板モデルで表現し,散乱曲線を log(q) = $-1.3 \sim 0.4$ の範囲でフィッティングした.円 板モデルフィッティングにより得られた曲線を Fig. 2 の測定データに重ねて示し,円板直径サイズおよびサ イズ分布の標準偏差を Table. 1 に示す.なお,サイズ 分布には Γ 関数を適用し,アスペクト比は 0.1 を設定 している.モデルフィッティングから得られた円板直径 サイズは 90 nm であり,TEM 観察で確認された中空 ナノフィラーサイズと対応する結果が得られた.なお, 中空ナノフィラーの散乱曲線に対して log(q) = -1.3より低 q 側は円板モデルでフィッティングできず,散 乱曲線が立ち上がっていることから中空ナノフィラー は凝集していると考えられる.

Table 1. Particle size and size distribution of nanoparticles.

円板直径サイズ (nm)	90
サイズ標準偏差 (nm) ※	11
※分布は Γ 関数を適用	

次に,中空ナノフィラー分散複合材料と,比較のために中空ナノフィラーのみの散乱曲線をFig.3に示す. なお,複合材料の散乱曲線は樹脂単体フィルムのデー タを用いバックグラウンド処理している.

複合材料と中空ナノフィラー単体の測定試料内で中 空ナノフィラー(散乱体)の存在量が異なるため,散 乱強度の絶対値比較は困難であるため行わない.両散 乱曲線の $\log(q) = -1.2 \sim 0.3$ の範囲で肩の出現位置 (散乱ベクトル値)を比較すると,複合材料の肩は高q側にあり,散乱体の大きさなどに変化が生じていると



Fig. 3. SAXS profile of composite material.

分かる. これらの形状変化が生じる可能性として, 撹 拌・混合時の機械的な外力による中空ナノフィラーの 破損が考えられる. この影響を確認するため, 中空ナ ノフィラーをトルエン(溶媒)に加えて複合材料調製 と同じ時間の撹拌・混合を行い, 乾燥させた後に TEM 観察を行った. 観察写真を Fig.4 に示す. Fig.1 と比 較して, 壁面の破損している中空ナノフィラーが散見 された.



Fig. 4. TEM image of nanoparticles after stirring processing.

TEM 観察の結果から,破損した中空ナノフィラー の破片が複合材料内に存在していると仮定し,中空ナ ノフィラー単体の解析に用いた成分1(円板モデル) と破片を想定した成分2(円板モデル)を適用して, log(q) = -1.3 ~ 0.4 の範囲で散乱曲線のフィッティ ングを行った.なお,成分1については,中空ナノ フィラー単体と同様の相対標準偏差に固定している. フィッティングの結果を Fig.5 に,得られたパラメー タを Table 2 に示す.複合材料中の中空ナノフィラー 壁面を表現させている成分 1 の平均サイズは,フィ ラー単体の値よりも小さくなっており,サイズの大き なものが破損している可能性が考えられる.また,破 損により生じた小片を TEM 観察では明確に捉えられ ていないが,散乱曲線の解析結果から分散体のサイズ は 10 nm 程度と推察される.

また,複合材料の散乱曲線も log(q) = -1.3 より低 q 側において,中空ナノフィラー単体の散乱曲線と同 様に散乱曲線が立ち上がっているため,凝集構造が存 在していると考える.



Fig. 5. SAXS profile fitting of composite material.

Table 2. Particle size and size distribution of nanoparticles dispersed in matrix.

	成分1	成分 2
円板直径サイズ (nm)	78	10
サイズ標準偏差 (nm)	9	2

まとめと今後の課題

中空ナノフィラー分散複合材料をモデル材料として 小角 X 線散乱手法により分析解析を行った.本複合材 料では,ナノフィラーの一部は凝集し,またフィラー の割れが発生していると推察される結果が得られた. 複合材料中のフィラー凝集体などの更に大きな構造を 検討するため,超小角 X 線散乱手法の適用,サイズ や形状の異なるフィラーが混在する系の解析技術確立 が必要である.また,異なるプロセスで作製された複 合材料やその耐久試験後試料についても分析解析を 進めることで,複合材料の特性発現メカニズムや変質 に伴う特性変化を詳細に検証可能となることが期待さ れる.

事業への貢献

本研究から得られた技術により,樹脂に添加された ナノフィラーの分散状態や構造変化を解析するができ る.車両から求められる軽量且つ高機能を実現してい くために材料構造を詳細に解析し,材料制御因子の明 確化や機能発現メカニズムの解明に利用する予定で ある.

- [1] 雨宮慶幸他:放射光 19,338 (2006).
- [2] 松岡秀樹:日本結晶学会誌 41, 213 (1999).
- [3] http://www.esrf.eu/computing/scientific/FIT2D/

2016A3330, 2016B3330

BL08B2

cos α 法による半導体パッケージ用熱硬化性封止樹脂/銅界面の 冷熱時残留応力その場解析

In-situ residual stress analysis at the interface between semiconductor package encapsulation resins and copper during heating and cooling process by using $\cos \alpha$ method

> 加々良 剛志,長島大,和泉 篤士 Takeshi Kakara, Dai Nagashima, Atsushi Izumi

> > 住友ベークライト株式会社 Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

概要: X 線回折法を用いた半導体パッケージ用封止樹脂/Cu 界面の残留応力評価技術について検討した. Cu 箔/封止樹脂/Cu 箔の三層構造からなる試料を半導体パッケージのモデル材として用い,イメージングプレー トにより測定した Cu(331) 面の 2 次元回折環の歪みを cos α 法により解析した. また,加熱冷却ステージを用 いた冷熱時その場観察により,冷熱プロセス過程 (-40 ~ 250°C) における樹脂/Cu 界面の残留応力変化挙動 の明確化に成功し,冷却時に応力増大することを確認した. 更には,樹脂と Cu の密着信頼性が冷却時応力と よい相関を示し,残留応力の存在が密着信頼性に影響していることが示唆された.

 $\neq - \nabla - \mathcal{F}$: residual stress, *in-situ* analysis, semiconductor package, resin-copper-interface

背景と研究目的

半導体パッケージの高信頼性・薄型化・高密度実装 化を実現する上で、半導体パッケージ用封止樹脂は必 須の材料である.半導体の高性能化に伴い、その半導 体パッケージ用封止樹脂にもさらなる寸法安定性、低 熱膨張率、耐熱性、電気絶縁性、熱伝導性、耐湿性な どの特性が求められ、これらは半導体パッケージの長 期信頼性にも影響する重要因子である.

半導体パッケージは主に,シリカなどの無機フィラー を含有した熱硬化性樹脂と,それにより封止される配 線やリードフレームといった金属からなる複合部材で ある.半導体パッケージは,その製造工程において樹 脂成形・熱硬化・半田リフローなどの複数の加熱冷却 プロセスを経るため,樹脂と金属といった弾性率や線 膨張係数 (CTE) などの物性値が大きく異なる材料間 の界面には熱応力が残留応力として蓄積する.残留応 力は半導体パッケージの歪みや反りとなって現れ,界 面剥離という半導体パッケージにおける致命的な不良 モードの要因となる.半導体パッケージにおける配線 やリードフレームは主に Cu であるため,樹脂/Cu 界 面における残留応力の評価技術の確立,および残留応 力発生メカニズムの解明は,半導体パッケージの不良 発生を抑制し,高信頼性製品の開発において極めて重 要な課題となる.

我々はこれまでに多軸回折計と0次元シンチレー ションカウンターを用い, sin² Ψ 法による半導体パッ ケージにおける樹脂/Cu 界面の残留応力評価を検討 してきた. sin² Ψ 法は, 試料表面と Cu 結晶格子面法 線のなす角 Ψ と X 線回折角の関係を解析する評価手 法である [1-3]. しかしながら,複数のΨに対する回 折プロフィールをスキャンする必要があるため,1測 定に数十分間もの時間を要し、数-数十分オーダーの 熱プロセスの各工程における応力変化を詳細に解析す るためには、測定時間を数分オーダーに短縮すること が課題である.そこで,0 次元検出器を用いた $\sin^2 \Psi$ 法に代わる短時間での応力評価手法として,2次元検 出器を用いた cos α 法に注目した [4,5]. cos α 法は 2 次元検出器で得られる回折環全体の歪み情報より応力 を算出する手法であり、更に1種類のX線入射角で の回折データのみで解析可能であるため、大幅な測定 時間短縮が可能である.課題ナンバー 2015A3330 お よび 2015B3330 の実験において,Cu 箔/半導体パッ ケージ用熱硬化性封止樹脂/Cu 箔の三層構造からなる 半導体パッケージモデル材料を用いて評価技術検証を 行い,試料へのX線露光時間2分という短時間での 残留応力評価に成功した.更に加熱試料ステージを用 いた40~250°Cの熱プロセス過程における残留応力 変化その場観察により,樹脂の高次構造変化と残留応 力の相関解析に成功した[6].しかしながら,半導体 パッケージの冷熱衝撃試験では –40°C ほどの低温環 境下での評価も実施されるため,本検討では cos α 法 を用いた –40~250°C での冷熱プロセスの残留応力 その場観察技術について検討した.

実験

半導体パッケージのモデル材料として、Cu箔(12 μm)/半導体パッケージ用熱硬化性封止樹脂 (1.3 mm)/ Cu箔(12 μm)の三層構造からなる平板状試料を200°C での加熱圧縮成形により作製し, 20 mm × 20 mm に 切り出した (Fig. 1). 熱硬化性封止用樹脂はシリカ フィラーを含有しており、本検討ではシリカフィラー 含有率の異なる3水準の樹脂を使用した. それぞれを シリカフィラー含有率ごとに樹脂-a (含有率 88 wt%), 樹脂-b (84 wt%), 樹脂-c (80 wt%) とし, それを用 いて作製したモデル材料を各々sample-A, sample-B, sample-Cとする.ここで、半導体パッケージの冷熱 衝撃試験における Cu との密着信頼性は、樹脂-a<樹 脂-b<樹脂-cの順で樹脂-cが最も良好である.また各 樹脂の 250°C 硬化物の CTE は, -50°C から 150°C 付近まではおおよそ一定値を示し、200°Cから大き く上昇し, ガラス転移温度 (Tg) は 250°C 付近と見積 もった. 各温度における硬化物の CTE の大きさは樹 脂-a<樹脂-b<樹脂-cの順である (Fig. 2).

測定のレイアウトを Fig. 3に示す. 試料加熱炉には ビームライン保有の小型セラミックヒーターを用い, 入射 X 線と試料表面法線のなす角 (φ) が 30° となる ように設置した. 試料加熱炉には液体窒素タンクを接 続し,液体窒素による冷却とヒーターによる加熱によ り,連続的な温度変化が可能となるよう設計した. 試 料表面 Cu 箔からの回折 X 線は, 試料より上流側に 設置した X 線透過穴を有するイメージングプレート (IP)(BAS-SR2025)を用いて背面反射配置で測定した. 続けて同じ IP に無歪回折環およびビームセンターを 求めるための標準試料としてアルミニウム粉末の回折 環を多重露光した.測定試料と標準試料の交換操作は 自動 X 軸ステージを利用することでハッチ外より行っ た.測定に用いた X 線のエネルギーは 8.0 keV,ビー ムサイズは 0.3 mm × 0.4 mm とし,X 線照射時間は 測定試料 2 min,標準試料 3 min とした.

測定温度は冷熱衝撃試験を想定し、40°Cから250°C



Fig. 1. (a) Schematic image of Semiconductor package model for residual stress analysis comprising of Cu/Resin/Cu three-layered sample. (b) Photo image of the specimen for the residual stress analysis.



Fig. 2. CTE of resin-a, resin-b and resin-c cured at 250°C as a function of temperature obtained by TMA analyses. The value of copper (16.8 ppm/K) is from literature data.



Fig. 3. Instrumental setup for residual stress measurements with an imaging plate detector by using $\cos \alpha$ method.

への昇温,250°Cから-40°Cへの降温,-40°Cから 40°Cへの昇温という流れで温度変化させた.試料全 体を均一加熱するために,試料とヒーターをカプトン フィルムで覆い,試料温度はシート状熱電対を用いて Cu 箔上の温度として計測した.

樹脂/Cu 箔界面の残留応力 (σ) は式 (1) を用いて算 出した [5]. 応力符号が正の場合は引張応力,負の場 合は圧縮応力である.

$$\sigma = \left(\frac{\cos^2 2\theta_0 \tan 2\theta_{0,\text{std}}}{2L_{\text{std}} \tan \theta_0}\right) \cdot \left(\frac{E}{1+\nu}\right) \\ \cdot \left(\frac{1}{\sin^2(\varphi - \eta) - \sin^2(\varphi + \eta)}\right) \cdot \left(\frac{d\Delta L}{d\cos\alpha}\right) (1)$$

ここで, 2 θ_0 および 2 $\theta_{0,std}$ は測定試料 (Cu) および標 準粉末 (Al) の無歪状態の回折角, L_{std} は標準粉末回 折環半径, E および ν は Cu 箔の弾性率 (65.0 GPa) お よびポアソン比 (0.343), 2 η は測定試料の回折角 2 θ_0 の補角である. α は Fig. 3 および Fig. 4 に $-\eta$ 側とし て示した検出面における 9 時方向から時計回りの方位 角, ΔL は式 (2) で定義されるパラメータであり, 式 (2) 中の ΔL は添字で示す方位角における標準試料と 測定試料の回折ピークトップの動径距離差であり, 方 位角 α における回折ピークトップは, 方位角 $\alpha \pm 0.5^{\circ}$ の範囲でセクター平均して得た 1 次元プロフィールの ローレンツ関数フィッティングにより算出した.

$$\Delta L = \frac{(\Delta l_{\alpha} - \Delta l_{\pi+\alpha}) + (\Delta l_{-\alpha} - \Delta l_{\pi-\alpha})}{2} \qquad (2)$$

解析には Al(422) 面と Cu(331) 面の回折環を用い, 8.0 keV における 25°C 無歪状態での回折角を各々139.3° および 138.2°とした.試料ー検出器間距離は,測定 試料 83 mm および標準粉末 77 mm とし,式 (1) に おける標準粉末の回折角 2 $\theta_{0,std}$ は,標準粉末一検出 器間距離を 77 mm と仮定した見掛けの回折角 141.4° を用いた. IP データの読取りには BAS-1800II を用 い,読取画像のピクセルサイズは, IP をサイズ既知 の Al 箔でマスクした状態で X 線を露光して得た画像 データから算出した校正値 (49.95 μ m/pixel × 49.56 μ m/pixel) を使用した.

結果および考察

Fig. 4 に sample-A の -40° C における 2 次元回折 プロフィールを示す.更に,Fig. 5 に Al(422) 面およ び Cu(331) 面からの回折プロフィールについて 1 次 元化したものを α の関数として示す.試料は Cu 箔/ 樹脂/Cu 箔の三層構造であるが,ピーク分裂のない明 瞭な Cu の回折環が得られていることより,裏面 Cu 箔からの X 線回折の寄与はシリカフィラーを含有す る樹脂層での X 線吸収によって無視できると考えら れる.Fig. 5 および式 (2) より求めた $\Delta L - \cos \alpha$ 線 図を Fig. 6 に示す. $\Delta L - \cos \alpha$ 線図は全ての方位角 α , すなわち $\cos \alpha = 0 \sim 1$ の範囲でよい直線性を示 し,線形フィッティングより求めた傾き 0.95 ± 0.01 mm および式 (1) より残留応力は 95.9 ± 0.8 MPa と



Fig. 4. Two-dimensional diffraction profiles of Cu (sample-A at -40° C) and Al-powder measured on a single imaging plate at different sample-to-detector distances of 83 and 77 mm, respectively.



Fig. 5. Diffraction peak profiles of Cu(311) and Al(422) as a function of azimutial angle α for sample-A at -40° C.



Fig. 6. $\Delta L - \cos \alpha$ plot for cured sample-A at -40° C.

算出された. この結果より, -40°Cの低温環境下に おいても, 樹脂/Cu 箔界面には引張応力が存在するこ とが明らかとなった. IP および cos α 法を用い, 更に は加熱冷却ステージによる測定温度制御により, 低温 環境下での樹脂/Cu 箔界面における残留応力を, 試料 への X 線照射時間 2 min という短時間で解析可能と なった.

次に冷熱プロセス過程における各 sampleの樹脂/Cu 箔界面の残留応力変化の解析結果を Fig. 7 に示す. 各 sample とも測定温度により応力変化が生じる結果を 得た. 測定開始時の 40°C では 40~60 MPa の引張応 力を示し,その後の 250°C の加熱時には 25~30 MPa にまで応力緩和することが確認された. また -40°C



Fig. 7. Change in residual stress at the resin/Cu interface during heating and cooling processes.



Fig. 8. Strain quantity at the resin/Cu interface.

の低温時には sample-A が 95.9 ± 0.8 MPa, sample-B が 78.8 ± 0.6 MPa, sample-C が 64.6 ± 0.5 MPa と なり,測定温度下において最も sample 間の応力差が 大きくなる結果となった.また,再度 40°C に昇温す ると,測定開始時の応力値とは 2~8 MPa ほど変化し ているが,おおよそ同じ応力値に戻ることを確認した. この温度に対する応力挙動について,硬化後の各樹脂 の CTE より歪み量を算出した結果を Fig. 8 に示す. 測定の熱処理プロセスに従い,各温度における樹脂と Cu 箔の歪み量をそれぞれ算出し,その差を求めるこ とにより,樹脂/Cu 箔界面に生じる歪み量とした.な お,符合が正の場合は Cu 箔に引張歪みが,負の場合 は圧縮歪みが生じていることを意味する.250°C の場 合,いずれの sample も歪み量は小さいことが伺える. 一方で, -40°C の場合には, sample-A が 2660 ppm,



Fig. 9. Residual stress analysis results for sample-A (sample size: $15 \text{ mm} \times 15 \text{ mm}$).

sample-B が 2050 ppm, sample-C が 1500 ppm と, Cu 箔には引張方向の歪みが生じていることが示唆さ れ,解析した応力値の大小関係とも一致した.このこ とからも cos α 法により算出された残留応力解析値は 妥当な結果であると考えられる.

また sample-A については、より詳細な応力評価を 実施した (Fig. 9). 40°C 以上の高温条件下では 50°C ごとに、0°C以下の低温条件下では20°Cごとに測定 を行った. 測定に用いたモデル材は上記方法と同様に 成形し、切り出しサイズは 15 mm × 15 mm として 作製した.応力解析の結果, -40~200°Cの温度範 囲では、応力は温度に対し直線的に変化し、250°Cで はやや応力増大することが明らかとなった. これは樹 脂の Tg 付近で CTE が大きく変化しているために生 じたと考察している.また冷熱プロセス下において, 最も応力緩和する温度が200°C,最大応力値を示す温 度が -40°C であることも明らかとなった. 以上の結 果より,冷熱プロセス下において樹脂/Cu 箔界面に 最も応力が生じるのは sample-A であり、その温度は -40°C であることが明らかとなった. また各 sample の -40°C における応力値は、樹脂の Cu との密着信 頼性ともよく一致しており,残留応力の存在が密着信 頼性に影響していることが示唆された.

今後の課題

本検討により, -40 ~ 250°Cの冷熱プロセス下にお ける残留応力を評価することが可能となり, 各温度で の応力挙動を明確化することに成功した.また, CTE から求めた歪み量からも,同様の応力挙動を示すこと が支持された.しかしながら 250°C 時の結果ように, 応力解析結果では引張方向の,歪み量計算からは圧縮 方向の応力値が見積もられ,応力の絶対値が対応して いないという課題が残っている.今後は sin²Ψ 法な どの他手法評価による, cos α 法の応力絶対値の確認 や,応力値の信頼性を検討することが課題である.

事業への貢献

今回検討した cos α 法による残留応力評価技術は, 半導体パッケージ用熱硬化性封止樹脂/Cu 箔界面の 歪み状態を非破壊で解析することが可能な極めて有 効な手法である.更に数分オーダーという短時間での 測定が可能であるため,冷熱衝撃試験のような温度環 境下でも半導体パッケージの構造変化を迅速に捉える ことが可能である.今後,弊社の半導体パッケージ用 封止樹脂材料開発に本評価技術を展開していく予定で ある.

謝辞

本測定を行うにあたり兵庫県立大学放射光ナノテク センターの桑本滋生博士,漆原良昌博士,李雷博士, その他関係者の皆様より多数の技術協力とご助言をい ただきました.感謝申し上げます.

- [1] 田中啓介 他:「放射光による応力とひずみの評価」養賢堂,東京 (2009).
- [2] K. Nakamae et al.: J. Appl. Polym. Sci. 40, 2231 (1990).
- [3] T. Nishino *et al.*: J. Appl. Polym. Sci. 45, 1239 (1992).
- [4] 佐々木敏彦 他:材料 44, 1138 (1995).
- [5] 王他:日立評論 95, 454 (2013).
- [6] 加々良剛志 他:兵庫県ビームライン年報・成果集 5,7 (2017).

2016A3271, 2016B3271

BL24XU

樹脂射出成形品の板厚断面方向の結晶化度分布解析

Distribution of Crystallinity for Injection Molded Resin in the Thickness Direction

舟本 三恵¹, 松永 拓郎², 横田 万里亜² Mie Funamoto¹, Takuro Matsunaga², Maria Yokota²

> ¹ アイシン精機²豊田中央研究所 ¹AISIN SEIKI Co., Ltd. ²Toyota Central R&D Labs., Inc.

概要:ポリアセタール射出成形品の板厚断面方向の結晶化度分布を,X線マイクロビームを用いて解析した. 断面を観察するために,成形品中心部分を短冊状に切削し,板厚方向に試料を走査しながら広角X線散乱測定 を行った.各測定位置で得られた散乱スペクトルをピーク分離することにより相対結晶化度を算出し,板厚方 向の分布を得た.その結果,樹脂表面100-400μm(金型側)に低結晶化領域が観測され,その内側はほぼ 一定の結晶化度であることがわかった.また,今回の測定対象である40-90°C金型温度範囲で得られた成 形品について,低結晶化領域は金型温度に対し線形に減少する傾向が見られた.

キーワード:射出成形,マイクロビーム,広角 X 線散乱,結晶化度

背景と研究目的

近年,地球温暖化対策による CO₂ 排出量削減のた めの規制強化への対応として,自動車業界では排ガス を抑制し CO₂ の削減に貢献する車両重量の軽量化に 取り組んでいる [1,2]. これまで使用していた金属材料 から比重が軽い材料への置換が進められている中で, 樹脂材料は今後一層適用範囲の拡大が見込まれ,高精 度・低コスト・高生産性などの要求が高まる傾向にあ る.特に製品品質に大きく関係する形状・寸法精度の 問題は,解決すべき課題の一つである.現在樹脂材料 の製造方法として一般的に用いられている射出成形に おいても,形状・寸法精度の向上が求められている.

樹脂材料の成形において,射出成形は,複雑形状の 成形が可能であることと,生産性が高いことから今後 も広く活用が見込まれる.射出成形のプロセスにおい て樹脂材料は,溶融状態で射出によるせん断力を受け ながら,金型表面より急速に冷却されるため,結晶化 と非晶領域の固化が同時に進行する [3].非平衡状態 での構造形成を伴うため,成形品の物性や品質の正確 な予測は難しい.実際に,クラック・ボイド・反り・ヒ ケ等といった成形品外観も射出成形条件に大きく依存 する.従って,射出成形条件の最適化が不可欠である が,その多くの場合は経験的・暫定的に行われるとい うのが現状である.

射出成形品の寸法精度や外観向上のメカニズムを 理解するためには、樹脂表面層(スキン層)を解析す ることが重要である.スキン層は、せん断力や冷却時 の温度勾配に強く影響を受けるため、射出成形条件の 影響が強く反映されている.しかし、スキン層は表層 100 μm 程度であるため、その構造を観察・評価する ことは難しく、これまで偏光顕微鏡などを用いた定性 的な観察手法が主であった.ところが第三世代放射光 施設が建設され、マイクロビーム X 線を用いた構造解 析手法が確立されてからは、定量的に構造情報(例え ば、結晶化度や配向度など)を評価できるようになっ てきた [4-6].

本実験では,射出成形条件と成形品の外観品質の関 係性を明確化することを目的として,マイクロビーム X線を用いた構造解析を行った.特に金型温度がスキ ン層構造に与える影響を捉えるため,板厚方向の結晶 化度の分布と金型温度に対する系統的な実験を行った. 実験

供試材:非強化ポリアセタールコポリマー (POM: polyoxymethylene)を射出成形することにより試験片 を作製した.射出成形には,200×50×2(*t*)mmの平 板形状用金型を用い,固定・可動金型の温度を変えて 試験片を作製した.広角X線散乱(WAXS)実験は, Fig.1 に示す Through 方向と Edge 方向から行った. Through 方向観察用には,金型温度45,55,65,75,85°C (固定・可動金型ともに)で射出成形した成形品の中心 部を用いた.Edge 方向観察用には,金型温度による 影響を観察するために,固定-可動金型間で温度差をつ けた.固定金型温度と可動金型温度がそれぞれ40°C :90°C,45°C:85°C,50°C:80°C,55°C:75°C, 60°C:70°C,65°C:65°Cの条件で試験片を作製し た.金型温度以外の射出、保持圧力などの射出成形条 件は一定とした.

Through 方向観察: Through 方向の WAXS 実験 は, SPring-8 BL33XU (豊田ビームライン)にて実 施した. 検出器は, PILATUS-300K, X 線エネルギー は 15 keV, ビームサイズは,約 300 µm 角を用いた. 試料検出器間距離は, 157.5 mm とした.

Edge 方向(板厚断面)観察: SPring-8 BL24XU にてマイクロビーム広角 X 線散乱(µB-WAXS)測定 を行った.Fig.1に示すように X 線ビーム透過厚みが 0.5 mmとなるよう成形品中央部を短冊状に切削し,板 厚方向の断面を固定金型側から可動金型側まで10 µm ステップで走査し,µB-WAXS 測定を行った.検出器 はフラットパネルディテクター,X線エネルギーは10 keV,ビームサイズは,5.0(W)×4.6(H)µmを用いた. ナイフエッジスキャンによる半値全幅をビームサイズ とした.試料-検出器間距離は,45.6 mmとした.得 られた散乱像を樹脂流動方向と水平方向に±5°で扇 形平均散乱強度を算出し,得られたスペクトルをピー ク分離することにより相対結晶化度を評価した.

結果および考察

Fig.2(A), (B) に Through 方向から X 線を入射し 測定した WAXS の二次元像を示す. (A) と (B) はそ れぞれ固定・可動金型温度が同一の 45°C, 85°C で 作製した試料の結果であるが,両者とも等方的な散 乱像であり,ピーク強度にも違いは見られなかった. Fig.2(C) に,金型温度 45 - 85°C の円環平均により算



Fig. 1. Schematic image of a cut-out position of injection molded samples and a measurement position for μ B-WAXS.

出した WAXS スペクトルを示す.全てのスペクトル が重なっており,Through 方向での観察では金型温度 による違いは見られなかった.

Fig.3 に固定金型:40°C,可動金型:90°C で作製した 成形品板厚方向断面の (a) 金型近傍位置(スキン層: 可動金型側)および (b)中心位置(コア層)における μB-WAXS 散乱像を示す.コア層は等方的な散乱像で あるのに対し,金型表面近傍のスキン層では異方性を 有する散乱像が得られた.Fig.2 に示したように,平 板形状成形品に対し Through 方向に X 線を透過させ た場合には,異方性のある像は得られなかった.その 理由として,金型近傍の分子配向層が非常に薄いこと が考えられ,マイクロビーム X 線を用いた断面方向 の局所構造観察を行うことで初めてその存在を確認す ることができた.

次に, Edge 方向の結晶化度の分布を求めた. 散乱 像は異方性が存在するため,樹脂流動方向に対し水平 方向 $\pm 5^{\circ}$ の範囲で扇形平均散乱強度スペクトルを求 め用いた. Fig.4 にコア層の μ B-WAXS スペクトルの ピーク分離結果を示す. ピーク分離のフィッティング 範囲は, 1 – 2 Å⁻¹ とした. 散乱ベクトル 1.6 Å⁻¹ 付近 のピークを Voigt 関数(結晶由来のピーク)と Gauss 関数(非晶由来のハロー)を用いてフィッティングを 行い,全散乱強度と結晶由来のピーク面積の比から相 対結晶化度を算出した.

Fig.4と同様の解析を固定金型40°C,可動金型90°C の条件で作製した試料の断面方向すべての測定点で実施し,得られた相対結晶化度の厚み方向の分布をFig.5 に示す.金型近傍では,結晶化度の低いスキン層領域



Fig. 2. WAXS 2D images and 1D spectra of injection molded POM plate from through direction.



Fig. 3. μ B-WAXS patterns of injection molded POM in the (a) surface layer and (b) core layer

が観測されており、金型温度によって、スキン層厚み に違いがあることがわかった. Fig.5 よりスキン層厚 さを定量化するにあたり,結晶化度は連続的に変化す るため、スキン層とコア層を明確に区別することがで きないため、金型表面位置から約1mm(試料中心位 置)の範囲をSigmoid 関数でフィッティングし、関数の 半値距離×2をスキン層厚みとして数値化した.固定 金型 40°C,可動金型 90°C の条件で作製した試料は, 40°C 固定金型側に約 410 µm, 90°C 可動金型側に約 170 µm のスキン層が存在することがわかった. コア 層領域(内側の約1.4 mm)では,金型温度が40°C, 90°Cの違いによらず、結晶化度はほぼ一定であるこ とがわかった. 2 mm 厚の試料の場合,約 70% が等方 的なコア層であり、また分子配向のあるスキン層は結 晶性が低いために, Through 方向の観察ではコア層 の結晶由来のピークが強調されて観測され、金型温度



Fig. 4. Scattering intensity vs. scattering vector for core layer of POM, and the peak fitting result.

による違いが観測されなかったと考えられる.また, 金型温度 40°C と 90°C の金型表面側から内部方向へ の結晶化度の分布を比較すると,40°C の方が結晶化 度の上昇がなだらかであった. POM は,ガラス転移 温度が約 –50°C,結晶融点が約 180°C であり,その 中間の温度である 65°C 近傍で結晶化速度が高くなる と考えられる.40°C と 90°C では,結晶化速度にほ とんど差はないが,低温側では核生成速度が上昇する ため 40°C では,多くの結晶核が発生し,最終的な結 晶化度が高くならず,内部方向への結晶化度の上昇が なだらかになったと考えられる.



Fig. 5. Distribution of crystallinity in the platethickness cross section.

上記解析により得られた金型温度とスキン層厚みの 関係を Fig.6 に示す.測定を行った 40°C から 90°C の 範囲では,金型温度が上昇するとスキン層厚みは線形 に減少することが捉えられた. POM はガラス転移温 度が約 –50°C であり,室温においても結晶化が進行 すると考えられる.しかし,金型から取り出した成形 品のスキン層厚みは成形時の金型温度に依存した変化 がみられた.これは,金型内部で受ける冷却時の温度 勾配により形成された結晶構造(結晶分布)が,その 後の結晶化度の進行にも影響を及ぼしていることを示 している.今回得られた平板試験片形状での知見をも とにすることで,より複雑な形状(製品形状)におい ても,スキン層厚みをμB-WAXS 手法から求め,そ こから実際の冷却(金型)温度を見積もることができ ると考えられる.



Fig. 6. Mold temperature dependence of skin layer thickness for POM.

今後の課題

成形品の結晶構造分布と射出成形条件との相関を解 明することで,射出成形条件の最適化に有効な指針が 得られることがわかった.今後,金型温度だけでなく, 射出速度(プランジャー),さらには金型部位や成形品 厚みを変えて試験片を作製し,基礎データを収集する ことにより,実製品における複雑な形状への解析技術 への展開が期待される.

事業への貢献

本研究で得られた成果は,射出成形品の外観品質の 向上に繋がるだけではなく,最適な成形条件を予測す ることで成形サイクル短縮や二次加工における不良率 の低減などプロセス全体の改善・向上への貢献が期待 される.

- JETRO ユーロトレンド 2007 年 4 月号 3. 自動 車の CO₂ 排出規制.
- [2] 中村守: 産総研 TODAY 2006.1 VOL.6-1.
- [3] 黒崎晏夫,佐藤勲,石井浩一郎:日本機械学会論 文集 C 編, 56 巻 522 号, 504-511 (1990).
- [4] N. E. Zaheiropoulos, R. J. Davies, S. V. Roth, M. Burghammer, K. Schneider and C. Stamm: *Macromol. Rapid Commun.*, 26, 1547-1551 (2005).
- [5] 野末佳伸,雨宮慶幸:放射光 Nov. 2006 Vol.19, No.6, 356-363.
- [6] Y. Shinohara, K. Yamazoe, T. Sakurai, S. Kimata, T. Maruyama, and Y. Amemiya: *Macro*molecules, 45, 1398-1407 (2012).

2014B3256, 2016A3352

BL08B2, BL24XU

放射光を利用したゴム階層構造追跡(4)

Analysis of hierarchical structure of rubber using ultra small angle X-ray scattering

城出 健佑, 大江 裕彰, 鷺谷 智, 菱川 靖浩, 三浦 聡一郎, 西川 由真 Kensuke Shirode, Hiroaki Oe, Satoshi Sagitani, Yasuhiro Hishikawa, Souichiro Miura, Yuma Nishikawa

> 東洋ゴム工業株式会社 TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.

概要:放射光を光源とした X 線小角散乱法と X 線ラミノグラフィーを組合わせ,タイヤ用ゴム材料中補強剤の階層構造を評価した.異なる測定スケールを持つ手法の組合わせによって,分散処理方法による補強剤階層 構造の違いを見出すことができ,ゴム物性との相関考察を行うことが可能となった.

キーワード:小角散乱, ラミノグラフィー法, CT, ゴム, フィラー, 凝集, 分散, 階層構造

背景と研究目的

ゴム材料は,各種ゴム製品に求められる性能を満足 させるために多数の異なる添加剤を混合するがゆえ, 種々の相から形成される構造を持った複雑材料である. その様々な挙動や現象は,近年の分析・解析技術の進 歩にもかかわらず,材料が不均一かつ3次元の階層構 造を有しているため,いまだブラックボックス的な要 素が多い.一方でゴム製品の環境・安全に対するニー ズは高まり,材料の高性能化・高機能化に向けた開発 が急務であることから,より精密な分析・解析技術が 必要不可欠である.

これまでに,放射光小角 X 線散乱法(SAXS)を用 いて,ゴム物性に大きく影響を及ぼす因子の一つであ る補強剤(カーボンブラック,シリカ等)に関して, 力学的試験下における,分散・凝集構造評価を行って きた [1].しかし,補強剤はナノ~マイクロメートル オーダーで階層構造を形成しているが,これまでの SAXS 評価では動的条件下での構造解析に主眼をおい ていたため,マイクロメートルオーダーの構造評価が 十分にできていなかった.そこで,本研究では SAXS に加えて,X線ラミノグラフィーによるシリカ直接観 察を行い,実/逆空間の両面からマルチスケールでの 補強剤構造評価を行い,機械特性との相関から高性能 タイヤ開発に繋がる新知見を得ることを目的とした.

実験

SAXS 測定は, BL08B2 で行った. 測定条件は, X 線の波長を1.5 Å, カメラ長を6182 mm, 露光時間を 1 s, ディテクターには Pilatus-100K を使用した. 取 得した 2 次元散乱像から水平方向に幅 40°の範囲で円 環平均し 1 次元データに変換, 散乱曲線を得た. 本条 件での *q* レンジは 0.015~0.3 nm⁻¹ であった.

X 線ラミノグラフィー測定は, BL24XU-B2 ハッ チで行った. 照射 X 線エネルギー 10 keV、カメラ長 42 mm とし, ゴムサンプルは回転ステージに固定, シンチレータは GAGG; Ce(Ce 添加 Gd₃(Al,Ga)₅O₁₂ 単結晶)を使用した. 画像のピクセル数は 1920×1440 pixels, 撮影ピクセルサイズは 0.65 µm であった. 得ら れた投影データは専用ソフトを用いて再構成を行った.

ゴムサンプルは,スチレンブタジエンゴムに,補強 剤(フィラー)としてシリカ20 vol%添加を基本とし た.ゴムとシリカは水と油の関係にあり,そのまま混 ぜても均一に分散させることは困難なため,分散処理 を施すことが一般的である.1つ目はポリマーとシリ カの間を取り持つ分散剤(シランカップリング剤)を 添加する方法(Silane coupling agent),2つ目はポ リマー鎖末端にシリカと相性の良い官能基を変性する 方法(End modified polymer)である.これら分散処 理の有無を組み合わせた4種類のサンプルを用意し た. Table. 1 に示す. nn はシランカップリング剤と 末端変性ポリマー不使用, sn はシランカップリング剤 のみ使用, ne は末端変性ポリマーのみ使用, se はシ ランカップリング剤と末端変性ポリマー使用である. サンプル作製は,密閉式混合機によってゴムと配合 剤を混練し,金型モールドでプレス加工することで, SAXS 測定用に 1.0 mm 厚, CT 測定用に 0.5 mm 厚

Table 1. Measurement samples.

	nn	sn	ne	se
Silane coupling agent	×	0	×	0
End modified polymer	×	×	0	0

結果および考察

のシート状に成型した.

ー般にタイヤの転がり抵抗はゴム配合物のヒステリ シスロスとの関係が強く、ヒステリシスロスにはフィ ラー分散状態が影響を及ぼす.ゴム中フィラー分散を 見積もる方法として、動的弾性率の振幅依存性(ペイ ン効果)を測定する方法がある.ある範囲での振幅増 加により、フィラー凝集体間の物理結合が切断され弾 性率が減少する.この凝集体の崩れによる弾性率の減 少幅を比較することでゴム中フィラーの分散性を議論 することができる.Fig.1にペイン効果のイメージ図 を示す.

sample 1 は, 歪領域内の最大弾性率と最小弾性率の 差が大きく,凝集体の割合が多いと言える. 逆にペイ ン効果の小さい sample 2 は,分散状態が良好である ことを示し, ヒステリシスロスの少ない材料となる. Table. 2 に今回測定に用いたサンプルのヒステリシス ロスとペイン効果を示す. (nn の値を 100 として index 表示としている.)

Table 2. Viscoelastic properties of measurement samples.

	nn	sn	ne	se
Hysteresys loss	100	93	84	67
Payne effect	100	33	51	11

シリカ分散処理を施していない nn がヒステリシス ロス,ペイン効果ともに大きく,シリカ分散が悪いと 考えられる.次にシランカップリング剤処理した sn ではヒステリシスロス,ペイン効果ともに低減され効 果が確認できる.末端変性ポリマーを使用した ne,シ ランカップリング剤と末端変性ポリマーともに使用し た se においても, ヒステリシスロスとペイン効果の 低減を確認した.低減効果は、ヒステリシスロスにお いては sn>ne>se,ペイン効果においては ne>sn>se となり、両者は異なる低減順序となった. つまり、ヒ ステリシスロス低減には末端変性ポリマーの寄与が大 きく,ペイン効果の低減にはシランカップリング剤処 理の寄与が大きい.ペイン効果はフィラー分散を見積 もる方法ではあるが、しばしばヒステリシスロスと相 関が取れない場合が見受けられる.この結果から、シ リカ分散効果が期待される2つの手法だが、メカニズ ムの違いによって得られる分散状態が異なるために, ヒステリシスロスとペイン効果の逆転現象が起きたと



Fig. 1. Image of Payne effect.



Fig. 2. SAXS profiles of silica compounded rubbers.

	nn	sn	ne	se
R / nm	98.7	76.5	73.7	64.3
N_r / The number of aggregates	$5.11{\times}10^{10}$	$6.16{\times}10^{10}$	$6.15{\times}10^{10}$	$8.09{\times}10^{10}$
$V_r \ / \ { m nm}^{-3}$	$1.46{\times}10^6$	$6.62{\times}10^5$	$7.21{\times}10^5$	$4.39{\times}10^5$

Table 3. Filler dispersion parameters obtained from SAXS profiles.

推測した.そこで, SAXS と X 線ラミノグラフィー を組合わせたフィラーの階層構造解析を行った. Fig. 2 に一次元化した SAXS プロファイルを示す.

 $q > 0.1 \text{ nm}^{-1}$ においてプロファイルに大きな差は 見られない. $q < 0.1 \text{ nm}^{-1}$ においてはショルダー位 置に違いが見られ,シリカ分散処理していない nn は $q = 0.04 \text{ nm}^{-1}$ 付近にショルダーを示し,分散処理 した sn, ne ではショルダーが高 qレンジ側へとシフ ト, se においてはさらに高 qレンジ側へシフトし,一 次凝集体サイズが低減されたと考えられる.しかし, sn と ne でショルダー位置に大きな違いは見られず, 両者の一次凝集体サイズは同程度と考えられる.ただ し, $q < 0.3 \text{ nm}^{-1}$ においてプロファイルに差が見ら れ,高次構造に差があることが示唆される.構造情報 をより定量的に評価するため,Unified function [2,3] を利用して解析した結果を Table. 3 に示す.

一次凝集体サイズ R は, nn>sn≃ne>se となり,分 散処理によって一次凝集体サイズは減少した.また, 一次凝集体サイズの低減に伴って,一次凝集体数 N_r は増加し,一次凝集体が占める体積 V_r は減少した. 以上の結果より,シリカ分散処理により一次凝集体サ イズ R が小さくなり,分散性が向上したことが確認で きた.ただし,分散処理方法が異なる sn と ne に構造 差が見られなかったにも関わらず,ヒステリシスロス とペイン効果に差があり,物性差を説明するには至ら なかった.しかし,SAXS プロファイルの低 q レンジ 領域にわずかな差があることから高次構造に違いがあ ることが示唆された.そこで,X 線ラミノグラフィー 法を用いて,マイクロオーダーでのシリカ分散評価を 行った.

Fig. 3にX線ラミノグラフィー測定で得られた断面像を示す.測定条件は,1投影の露光時間=0.15 s,投影数=3000枚,サンプリング数=1920×1440 pixelsであった.

黒く写っている部分がゴム層,白い粒がシリカ凝集 塊である.nn, sn, ne,にはところどころに大きな粒 が見られるが, se には大きな粒は見られず,分散状態 が良好だと考えられる.シランカップリング剤と,末 端変性ポリマーを併用することで,マイクロオーダー の粒子低減に大きな効果があり,ヒステリシスロス, ペイン効果にも好影響している.分散処理していない mと,分散処理している sn と ne では,見た目には明 確な差は確認できなった.そこで,フリーソフトであ る「ImageJ」を用いて,粒度分布解析を行った.手順 として,画像を二値化した後に,analyze particle 機 能を利用して粒子の面積を算出した.そして,粒子を 真円と仮定して,粒子面積を粒子直径へ変換した.な お,撮影ピクセルサイズと,二値化した際のノイズを 鑑みて,直径 3.5 µm 以上を粒子として見なした.ま た複数枚の断面像を解析し,平均値を算出した.粒子



Fig. 3. Cross-sectional images of silica compounded rubbers using X-ray Laminography.

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)



Fig. 4. Particle size distribution of silica in rubbers.

分布を, Fig. 4 に示す. また Fig. 5 に 7.5 µm 以上の 粒子数の合計を示す.

分散処理していない nn に対して,その他分散処理 サンプルは、すべての直径で粒子数が減少している. これは分散処理によって、シリカ凝集塊が小さくなり、 撮影ピクセルサイズ以下の凝集塊が増加したためだと 考えられる.続いて、分散処理したサンプル内で比較 すると、4 µm 以下の粒子に大きな差が見られ、粒子 数は sn>ne>se となり、末端変性ポリマーの効果が大 きいことがわかった.また測定分解能の関係から3.5 μm 以下の粒子は評価できないが、粒度分布の傾向か ら予測すると、数百 nm~ 数 μm の粒子数減少に、シ ランカップリング剤と比較して末端変性ポリマーの方 が効果は大きいと示唆される. 7.5 µm 以上の粒子数 を見ると, ne>sn>se となり、シランカップリング剤 による効果が大きいことがわかった.よって、分散処 理方法によらず数百 nm~ 数十 μm のスケールで粒子 数の減少が見られるが,分散処理方法によって効果が ある粒子径には差があり、シランカップリング剤処理 は、7.5 µm 以上の粒子に効果が大きく、末端変性ポ リマーは数百 nm~ 数 µm の粒子に効果が大きいと考 えられる.またゴム物性と照らし合わせて考えると, 7.5 µm 以上の粒子を減少させるとペイン効果が低減 され,数百 nm~数 µm の粒子を減少させることはヒ ステリシスロスの低減につながることが示唆される. ただし、ヒステリシスロスの低減は単にシリカ分散 の改善だけでなく、ポリマー末端変性によって、ポリ マー末端の運動が抑制された効果も考えられる.より 深い議論へ発展させるためには,フィラー分散評価の みならず多角的な評価が必要となってくる.



Fig. 5. The total number of particles with a diameter larger than 7.5 μ m.

今後の課題

SAXSとラミノグラフィーを組合わせてフィラー階 層構造解析を行った.フィラー分散処理方法による階 層構造の違いを明らかにするとともに,物性との相関 考察までつなげることができた.今後は,SAXS,ラ ミノグラフィーのみならず,多角的な構造評価を行い 材料構造と物性との相関関係を解明し,高性能タイヤ 開発へと展開したい.

事業への貢献

本研究成果は、ゴム物性と構造の相関理解に資する ものであり、タイヤ用ゴム材料開発への貢献があった.

- 大江裕彰,城出健佑,菱川靖浩,三浦聡一郎:兵 庫県ビームライン年報・成果集 4,24-26 (2015).
- [2] G. Beaucage, J. Appl. Cryst. 28, 717-728 (1995).
- [3] T. Koga *et al.*, Macromolecules **41**, 453-464 (2008).

2017A3277, 2017A3393, 2017B3277

BL08B2, BL24XU

兵庫県ビームライン研修会実施報告

Report of Trial Use Projects at Hyogo Prefectural Beamlines

漆原 良昌, 桑本 滋生, 津坂 佳幸, 松井 純爾

¹Yoshimasa Urushihara, ¹Shigeo Kuwamoto, ²Yoshiyuki Tsusaka, ¹Junji Matsui

兵庫県立大学¹放射光ナノテクセンター,²物質理学研究科

¹Synchrotron Radiation Nanotechnology Laboratory & ²Graduate School of Material Science, University of Hyogo

概要:兵庫県ビームライン BL24XU/BL08B2 において,座学と実習で構成した研修会を開催した.BL24XU では,サブミクロンスケールで3次元構造を可視化できる「結像型 X 線顕微 CT 測定」,ミクロンスケールの 位置分解能を有し,局所領域で材料の長周期構造を評価できる「マイクロビーム小角 X 線散乱測定」,そして 新規な高空間分解能トポグラフィ法として開発した「明視野 X 線トポグラフィ測定」の3 手法について実施 した.BL08B2 では,材料開発において重要な実環境下における構造評価(その場観察)を目的とした整備が 進められており,近年導入した冷却加熱炉を利用した「小角 X 線散乱『その場観察』測定」を実施した.

キーワード:研修会,結像型 X 線顕微 CT,マイクロビーム X 線,小角 X 線散乱,明視野 X 線トポグラフィ, その場観察

背景と研究目的

放射光利用の分析手法は,環境エネルギー,電子デバ イス, 高機能素材, 食品など様々な産業分野で活用され ており, 産業界にとって研究開発する上で必須ツール となっている.兵庫県ビームラインBL08B2/BL24XU では多種多様な測定手法を取り揃え利用展開されてい る. これまで新規の産業界企業ユーザーへの利用拡大 を図るために,無償のトライアル測定を実施してきた. しかしながら、トライアル測定は原則として「各企業 1回限り」であり、既にユーザーとなっている企業で は,利用したことない手法を「お試し」する機会は無 い. このような状況は、企業ユーザーへの利用拡大, 利用手法の多様化を積極的に進める上で支障となって いる.そこで現在展開している測定手法について,企 業ユーザーにトライアル利用相当の広宣の機会を提供 することを目的として研修会の開催を企画した. また 研修会を通じて参加ユーザーとコミュニケーションを 図り、その結果を測定手法の改善にフィードバックす ることも目的とした.研修会は、ビームラインの概要 および測定手法の説明を行う座学と各参加企業グルー プが持参した試料を測定する実習の2部構成とした. 2017 年度は, BL24XU にて,「結像型 X 線顕微 CT」, 「マイクロビーム小角 X 線散乱測定」,「明視野 X 線ト ポグラフィ」, BL08B2 にて「小角 X 線散乱「その場 観察」測定」,の研修会を開催したので,詳細を個別 に報告する.

BL24XU 結像型X線顕微CT研修会

(1) はじめに

結像型 X 線顕微 CT は,非常に高い空間分解能を 有する CT (Computed Tomography)であり,通常 の投影型 X 線 CT では不可能なサブミクロンスケー ルの構造を 3 次元的に可視化できる.研修会では,結 像型 X 線顕微 CT の測定に関する基礎知識の習得を 目的とした座学と,参加ユーザーの持込試料に対して 試料セッティング,測定,CT 再構成までの一連の実 習を行った.研修会は 2017 年度 A 期 6 月に開催し, 参加企業グループは,株式会社 コベルコ科研,株式 会社 住化分析センター,株式会社 東レリサーチセン ター,株式会社 豊田中央研究所,トヨタ自動車株式 会社,株式会社 日産アーク,株式会社 MORESCO の 7 グループであった. Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

(2) 実験条件·装置

図1には、結像型X線顕微鏡の外観を示した。 BL24XUでは、広視野を確保できる平行照明型を採 用しており、フレネルゾーンプレート (FZP) を対物 レンズとした結像光学系を構築し,CT 測定を行って いる [1]. 使用した FZP (NTT-AT 製) は, 吸収体材 料:Ta, 直径:416 µm, 最外輪帯幅:86.7 nm, 厚 さ:700 nm である. X 線光子エネルギーを 8 keV, 試 料-X 線画像検出器間距離を約 5600 mm とすること で,視野:100 µmH × 164 µmW,実効ピクセルサイ ズ:80 nmの光学系を構築した.空間分解能評価用に Siemens チャート(NTT-AT 製: XRESO-50HC)を 撮影した結果(図2)より、本装置光学系は150 nm のライン-スペースが解像できる性能を有することが 確認できた. CT 測定の条件は露光時間: 0.5 秒, 投 影像:1200枚/180°を基本とし、研修会参加企業各 グループの持込試料の測定を行った. 持込試料は各グ ループ2 試料であり、アルミニウムやセラミック等の 金属・無機系試料から高分子系の有機系試料まで多岐 に渡っていた.



Fig. 1. Overview of full-field X-ray micro-CT station.

(3) 実験結果

金属・無機系試料の測定例として,アルミニウム ロッドの CT 像を図3に示した.アルミニウムロッド は圧延後に焼きなまして再結晶化したものである.不 純物成分である Si が析出し圧延方向に延びている様 子が明瞭に観察できた.その他,ロッド中に存在する 1 µm 以下の空隙も観察できていた.一方,一部の有 機系試料においては,高強度 X 線照射の影響と思わ れる試料変形が確認された.そこで露光時間を 0.25 秒,投影枚数を 900 枚/180° とし,X 線の全照射時間



Fig. 2. X-ray image of Siemens chart.

を半分以下した結果,シグナル/ノイズ比は低下する ものの CT 再構成が可能となった.このように測定で は試料に依存して実験計画を検討する必要があること を確認した.この点に関しては,ユーザがマシンタイ ムを最大限効率よく活用し,成果を創出できるよう, 実験計画の検討システムづくりも必要であると考えら れる.従来は,経験的な判断を頼りとして適当に測定 パラメータをその場で選択する場合が多かったが,こ れに対して実験計画の段階で試料に応じた最適な測定 条件の導出を導き出す方法や(機械学習の応用など), データベースを活用した実験予想のシミュレーターの 導入を検討したい.

測定例として,ナノダイヤを分散した高分子樹脂試料のCT結果を図4に示した.画像は一軸延伸・破断前後の断層像である.破断後の試料ではナノダイヤに



Fig. 3. Volume renderings of reconstructed aluminum rod.



Fig. 4. Cross sectional images of reconstructed nanodiamond-dispersed polymer resign before and after the tensile test.

接して空隙が生成しており,界面破壊を生じている様 子が観察できた.

(4) まとめ

2017 年度最初の研修会として結像型 X 線顕微 CT の研修会を行った.参加ユーザーのほとんどが未経験 であり,測定試料の調整法,測定条件の設定の重要性 等を重点的に講習した.特に有機系物質を測定する際 には,低コントラストならびに放射線ダメージの問題 が顕著であり,屈折コントラストの利用,ドーズ量の 低減化などの対処法について理解を得た.今後,結像 型 X 線顕微 CT が企業の研究・開発において有用な ツールとして認識され,ビームライン利用拡大に繋が るとともに,測定結果が実空間の3次元画像であると いう PR 力を活かした利用も期待される.

ユーザーから装置の高度化に対する意見を聞くこと ができた.複数のユーザーから試料交換装置(サンプ ルチェンジャー)の導入を切望された.理由として, 近年の装置高度化により測定時間の短縮し,試料交換 作業,特に実験ハッチの開閉作業が最も非効率的な作 業の1つとなっていることが挙げられていた.また長 時間の実験において,単純な人為的ミスが主に試料交 換作業で生じる指摘もあった.以上のことから,効率 的かつ安定的な測定環境を実現するため,CT測定用 の自動交換装置の早期導入を目指し検討を始めている.

BL24XU マイクロビーム小角 X 線散乱測定研修会

BL24XU-A2 実験ハッチにて企業ユーザーを対象と したマイクロビーム小角 X 線散乱(μ-SAXS) 測定研 修会を 2017 年度 B 期 10 月に開催した. 数ミクロンサ イズのマイクロビーム X 線を利用した μ-SAXS 測定 を行うことで、測定試料局所位置の周期構造や粒子・ 空孔サイズ,配向性等のナノ構造を評価することがで きる. さらにスキャニング測定を行うことで, 不均一 構造試料のナノ構造分布評価が可能となる. 今回の研 修会では、顕微鏡を用いて試料へのビーム照射位置を 調整し、ピンポイント測定あるいはスキャニング測定 を行い試料局所のナノ構造から生じる散乱を観察する 実習を行った.参加企業は、株式会社コベルコ科研, 株式会社住化分析センター、昭和電工株式会社、住友 電気工業株式会社、日鐵住金テクノロジー株式会社の 5社であり、実習をとおして μ-SAXS 測定の基礎なら びに測定手順の講習を行うことを目的とした.

(2) 実験条件·装置

実験は兵庫県ビームライン BL24XU-A2 実験ハッチ 内の μ -SAXS 装置を利用して行った.利用 X 線エネ ルギーは 10 keV, SAXS カメラ長は 0.6 m,検出器 は PILATUS3-X-300K を利用した.マイクロビーム 形成は集光素子として屈折レンズを利用し,ビームサ イズは試料位置(ビーム照射位置)で 3 × 3 μ m,フォ トン数は 3 × 10⁹ photons/sec.である.この条件で の測定レンジは,散乱ベクトルにして $q = 0.10 \sim 5.0$ nm⁻¹ であった.ビーム照射位置の調整は,マイクロ ステップ試料自動ステージと小型ズーム顕微鏡を利用 し,モニター画面上で調整することができる.実験装 置の外観を図 5 に示す.



Fig. 5. Overview of μ -SAXS station.

(1) はじめに

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

(3) 実験結果

実習実験としてポリエステル繊維、ブリーチ処理毛 髪のμ-SAXS 測定を実施した.最初にデンタルフロス で利用されるポリエステル繊維を用いてマイクロビー ム照射位置調整の実習を行った.図6(a)にポリエステ ル繊維の顕微鏡画像を示す. 画像上の白線の交差位置 がビーム照射位置である. 自動ステージを用いてビー ム照射位置を直径約 40 µm の繊維中心へ調整し測定 を実施した. 露光時間 10 秒にて図 6(b) のポリエステ ル繊維の SAXS 散乱像が得られた.繊維軸方向に散 乱ベクトル $q = 0.53 \text{ nm}^{-1}$, d = 12 nm の位置に特 徴的な回折ピークが観察された. これは繊維中のマイ クロフィブリル内の微結晶ドメイン間隔に由来してい る. このように μ-SAXS 測定では繊維 1 本で解析可 能なデータを得ることができる.また、繊維径に対し てビームサイズが十分小さいため, スキャニング測定 を行うことで繊維の局所構造分析も可能である.

次にブリーチ処理した毛髪の測定を実施した.1本 の毛髪に繊維軸と垂直な方向からビーム照射し、直径 約80 µm の毛髪に対して2µm ステップにて水平方向 100 µm 範囲のスキャニング測定を行った. 1ショット の露光時間は10秒で、このスキャニング測定に要す る時間は10分弱であった。図7はスキャニング測定 から得られた毛髪中心(a)とキューティクル層(b) の散乱像である.図7(a)中の矢印1は毛髪軸に沿って 配列するケラチン繊維からの回折 $(q = 0.7 \text{ nm}^{-1})$, 矢印2は毛髪中心メデュラを満たしている脂質回折 $(q = 1.5 \text{ nm}^{-1})$ である.また,図 7(b) 中の矢印 3 は、キューティクル中の CMC 脂質層からの回折であ る. 今回の試料はブリーチ処理した毛髪を用いてお り、ブリーチ処理の有無でケラチン繊維やキューティ クル CMC 構造に変化は観察されなかったが、キュー ティクル層に矢印4の回折 ($q = 1.1 \text{ nm}^{-1}$)が観察さ れた.これはブリーチ処理によりキューティクル層に 入り込んだ乳化剤や薬剤の可能性がある.このように μ-SAXS スキャン測定を利用することで毛髪中の局所 構造に由来した散乱像を取得することができる.

(4) まとめ

今回の µ-SAXS 研修会では,µ-SAXS 測定の基礎 と測定手順に加えて,マイクロビーム実験に適した試 料調整方法や大きな問題となる放射線ダメージにつ いての講習も行った.また実習実験から,微小試料や 不均一局所構造試料の評価・分析技術として µ-SAXS



Fig. 6. (a) Microscopic view and (b) SAXS pattern of polyester fiber.



Fig. 7. SAXS patterns of bleached human hair.

測定が有効な技術であることを確認した.今後,企業 の材料開発や研究において, μ-SAXS 測定が材料分析 手法の一部としてビームライン利用拡大に繋がると考 える.

兵庫県ビームライン年報・成果集

BL24XU 明視野X線トポグラフィ測定研修会

(1) はじめに

通常, X線トポグラフィは回折像を撮影するが, 明 視野 X線トポグラフィは, 回折を起こさせながらそ の透過像を撮影する. そのため, 検出器を回折ビーム の位置に移動させる必要が無い. また, 多波回折条件 近傍で撮影すると, 回折ベクトルの変更を迅速に行え る. 研修会は, 実習を通して明視野 X線トポグラフィ に関する基礎知識ならびに実際の結晶の欠陥像が「ど のくらい見えるのか」, また「取得像の理解」を体験 することを目的として実施した. 研修会は 2017 年度 B期 11 月に開催した. 参加企業は, 株式会社 東レリ サーチセンター, 日鉄住金テクノロジー株式会社の 2 社であった.

(2) 測定系および観察結果

ビームラインモノクロメータから 15 keV のX線を 取り出し,試料に照射後その透過像を可視光変換型 CMOS カメラで撮像する(図 8) [2].空間分解能評価 用に Siemens チャート (NTT-AT 製: XRESO-50HC) を撮影した結果より,可視光変換型 CMOS カメラは 1 μ m のライン-スペースが解像できる性能を有する ことが確認できた.1ショットの露光時間は数10 ~ 数 100 msec とした.



Fig. 8. Experimental setup.

測定例として c 面サファイア結晶を用い,6 波近似 条件として,0000,4-2-20,3-300,30-30,1 -210,11-20の回折波を同時に励起し,その近傍 で結晶を0.1°程度回転して,それぞれの回折を励起 した状態での透過像を撮像した(図9).その透過像 の一部を図10に示す.図10(b)では,OB方向に伸 びた転位線のコントラストが消失していることから, この転位線のバーガースベクトルが,[11-20]に平 行であることが分かる. 研修会への持込試料は、両グループとも *c* 軸から 4° off の SiC 結晶であった.サファイアとの結晶構造因 子の違いから、6 波近似条件として、0000,20-2 0、2-1-10、11-20、01-10、1-100の回折波を 同時励起した.サファイア結晶同様それぞれの回折を 励起した状態での透過像を撮像し、いくつかの転位線 についてそのバーガースベクトルを決定できた.



Fig. 9. Brilliant diffraction spots on a fluorescence sheet by multiple x-ray diffractions under (a) the six-wave and (b) the two-wave approximation conditions, where the 0000- and $3\overline{3}00$ -reflection images are similar to a bright-field TEM image. Spots A, B, C, D, and E in Fig. 9 (a) correspond to the $4\overline{2}\overline{2}0$ -, $3\overline{3}00$ -, $30\overline{3}0$ -, $1\overline{2}10$ -, and $11\overline{2}0$ -reflections, respectively. Spot O correspond to the direct xray beam (0000-reflection) transmitting through the crystal at point P.



Fig. 10. Bright field topographs imaged under (a) the six-wave and (b) the two-wave approximation conditions (similar to a bright-field TEM image), which correspond to the activated diffractions shown in Figs. 9(a) and 9(b), respectively.

(3) まとめ

研修会に参加したユーザーの一部は通常の X 線ト ポグラフィの経験はあるが、多波近似条件近傍での明 視野 X 線トポグラフィの経験はなく、測定試料の調整 法、測定条件の設定の重要性等を重点的に講習した. 特にどの組み合わせの多波回折条件を選ぶかは、転位 のバーガースベクトル,結晶構造因子に依存し,迅速 なバーガースベクトル決定の際の重要性について理解 を得た.

研修会はユーザーの声を直接聞くことのできる貴重 な機会であった.装置の高度化において最も要望の声 が高かったものは、トポグラフ像の高コントラスト化 であった.特に結晶構造因子が小さい回折では、回折 で失われる X 線が少ないため、透過像に現れる欠陥 像のコントラストが低くなる.これを解決するために は、入射ビームの角度発散や、エネルギー幅をその回 折のダーウィン幅程度に小さくする必要がある.それ は、ビームラインモノクロメータの下流にさらにチャ ンネルカット結晶を導入することで解決できると考え ている.また、モノクロメータの熱ひずみや、ビーム ライン上の Be 窓が透過像バックグラウンドになって いる.これらは、それぞれのコンポーネントの交換や、 拡散板の導入などで対応していきたいと考えている.

BL08B2小角 X線散乱「その場観察」測定研修会

(1) はじめに

企業ユーザーを対象に小角 X 線散乱その場観察測 定の研修会を 2017 年 7 月に開催した. 放射光を利用 した小角 X 線散乱 (SAXS) 測定は,材料中の周期構 造や配向性,微粒子や空孔の粒度分布等を数ナノメー トルから数百ナノメートルのスケールで評価するこ とができる.そして加熱炉や引張機等の実験装置と組 み合わせることで,動的な構造変化の評価,すなわち 「その場観察」測定が可能となる.研修会では,冷却 加熱炉を利用した SAXS その場観察測定を実施し,試 料の温度変化に伴う構造変化の観察を行う実習を行っ た.参加企業は,株式会社住化分析センター,マツダ 株式会社,住友電気工業株式会社の3社があり,この 実習をとおして,SAXS 測定の基礎ならびに測定手順 や基本的なデータ処理方法の講習を行うことを目的と した.

(2) 実験条件·装置

実験は兵庫県ビームライン BL08B2 実験ハッチ 2 内 の小角 X 線散乱装置を利用して行った.エネルギーは 8 keV, SAXS カメラ長は 6 m,検出器は二次元半導 体検出器 PILATUS3-300K を利用した.ビームサイ ズは試料位置で $0.3 \times 0.3 \text{ mm}^2$,集光位置である検出 器面上で $0.1 \times 0.2 \text{ mm}^2$ である.この実験条件にて, 測定レンジは散乱ベクトル $q = 0.0156 \sim 0.450 \text{ nm}^{-1}$ である.入射光強度 I_0 は試料直前のマイクロイオン チャンバーにて計測し,透過光強度 I_1 は検出器真空 パイプ内のビームストッパー内蔵強度モニターにて計 測した. $I_0 \ge I_1$ から透過率を算出し散乱強度の補正 に用いている.

利用した冷却加熱炉は、リンカム社製冷却加熱ス テージ10033Lである.この冷却加熱炉はビームライ ン整備ユーティリティであるため、ユーザーはいつ でも利用可能である.制御可能な温度範囲は-190~ 600°C,試料サイズは φ15 mm,厚さ1 mm まで利用 可能である.透過配置時のX線透過穴(ヒーターブ ロックの穴)サイズは φ2 mm である.上流・下流側の 窓はカプトン薄膜あるいは合成石英薄膜を利用可能で あり、低エネルギーでも十分な透過率が確保できる. 今回の実験ではカプトン薄膜を使用した.

冷却加熱炉を利用した SAXS 測定は自動化されて いる.冷却加熱炉の温度変化チャートに合わせて等時 間間隔での SAXS 測定や決められた温度での SAXS 測定が可能である.また,冷却加熱炉には試料表面温 度を計測し出力可能な改良を行っており,これにより SAXS 測定時に X 線透過率と同時に試料温度を自動 的に記録できるシステムを構築している.冷却加熱炉 の退避機構も設けており,試料交換時に実験ホール側 へ冷却加熱炉を退避することでユーザーは容易に試料 交換が可能である.実験装置の外観を図 11 に示す.



Fig. 11. Instrumental setup for *in-situ* SAXS measurements with a freezing-heating stage.

(3) 実験結果

実習実験として構造配向性ポリエチレン(PE)フィ ルムの加熱測定を実施した.加熱温度は融点近傍の 125°Cまでとし,階段状に昇温しながらSAXS測定 を実施した.露光時間10秒で十分な散乱強度が得ら れた.実験結果を図12に示す.昇温に伴い図12(a) の二次元散乱像の変化と図12(b)の散乱曲線の変化が 観察された.図12(b)の散乱曲線で特徴的なピーク・ショルダーは、PE 階層構造中の結晶ラメラ構造(主 にラメラ間距離)と考えられる.昇温に伴いこのピー クは低角側へシフトしラメラ間距離の長周期化が観 察された.今回の実験条件ではPE 階層構造中の結晶 フィブリル構造(ミクロンオーダー)の変化はカメラ 長不足のため観察することができなかった.更に小角 領域を観察するためには、カメラ長を更に長くした Ultra-SAXS 測定が必要である.また,階層構造を形 成する試料では、幅広い角度範囲の散乱曲線を得るた めに複数のカメラ長での SAXS 測定が必要であるこ とを再確認した.



Fig. 12. (a) SAXS patterns and (b) profiles observed during the heating of PE film.

(4) まとめ

SAXS実験経験の浅い企業ユーザーを対象に SAXS 研修会を実施した.今回の SAXS 研修会では,SAXS 測定の基礎に加えて,十分な散乱強度を得るための試 料条件や観察目的の構造サイズに合わせたカメラ長選 択の重要性等の実験技術面での講習も行った.また, その場観察測定の実習から,試料の物性と構造との相 関性を理解する上で,その場観察測定が有効であるこ との理解を深めることができた.今回は兵庫県ビーム ラインでの研修会であったが,参加企業が他の SAXS ビームラインを利用する場合においても,実験条件・ 計画の立案に役立つと考える.

今後の展開

2017 年度は BL24XU, BL08B2 合わせて計 4 回の 研修会を開催した.2017 年 5 月に企画し,6 月から 実行したため準備不足感は否めなかったものの,述べ 17 企業グループ,34 名(見学者含む)の参加があり, いずれの研修会も参加ユーザーから高い評価を得た. すでに研修会から利用につながったユーザーもあり, 実施効果が現れている.

研修会では、ユーザーと積極的に意見交換を行った. 研修会の開催は好意的に受け止められており、継続的 かつ定期的な開催が望まれている.本年度の研修会 では、日程の都合がつかず不参加となったユーザーも あり、募集から開催までの日程、開催間隔・回数など 検討すべき課題がある.内容に関しては、X線回折、 X線吸収分光など兵庫県ビームラインで供与してい る他の測定手法に加えて、新しく導入されたユーティ リティ設備や検出器を利用した測定の実施要望があっ た.また一部のユーザーより、研修会をトライアル測 定の機会だけではなく、放射光利用業務の新人教育の 機会としての期待の声があった.今後もユーザーの声 を反映し、問題点を改善しつつ、引続き研修会を開催 していく予定である.

- H. Takano, Y. Urushihara and J. Matsui: SPring-8 Research Frontiers 2010, 140 (2011).
- [2] Y. Tsusaka, S. Takeda, H. Takano, K. Yokoyama, K. Kagoshima and J. Matsui: *Rev. Sci. Instrum.* 87, 023701 (2016).
兵庫県ビームライン成果発表一覧

(JASRI研究成果番号:21221以降,2018年1月末現在登録済み)

発表形式

- 原著論文 : 原著論文/博士論文/査読付プロシーディングス
- 公開技報 : 公開技術報告書
- 総説 : 総説
- 査読無 : 査読なしプロシーディングス
- 招待講演 : 招待講演
- 口頭/ポ : 口頭/ポスター発表

JASRI No.: JASRI 研究成果番号

論文発表等登録済みリスト(JASRI研究成果番号降順)

※塗りつぶしの成果は、成果公開の基準を満たす成果(査読付き論文または研究成果集)

JASRI No.	課題	播号	BL	実験責任者 所属機関	発表形式	発表先(出版)	タイトル
35211	15B	3388	08B2	犬飼 潤治 山梨大学	原著論文	Catalysis Science & Technology 巻 7 号 24 発行年 2017 頁 6124- 6131	Weakened CO Adsorption and Enhanced Structural Integrity of a Stabilized Pt Skin/PtCo Hydrogen Oxidation Catalyst Analysed by in situ X-ray Adsorption Spectroscopy
35171	14B 16A	3256 3352	24XU 08B2	城出 健佑 東洋ゴム工業(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5,6 号 発行年 2017 頁 37-40	放射光を利用したゴム階層構造追跡(4)
35170	16A 16B	3271	24XU	舟本 三恵 アイシン精機(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5,6 号 発行年 2017 頁 33-36	樹脂射出成形品の板厚断面方向の結晶化度分布解析
35169	16A 16B	3330	08B2	和泉 篤士 住友ベークライト (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5,6 号 発行年 2017 頁 28-32	cos α法による半導体パッケージ用熱硬化性封止樹脂/ 銅界面の冷熱時残留応力その場解析
35167	15B	3389	08B2	横山 和司 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5,6 号 発行年 2017 頁 24-27	小角X線散乱法によるナノフィラーの分散状態解析
35075	14B 15A 15B 16A	3366	08B2	岸本 浩通 住友ゴム工業(株)	原著論文	Hyperfine Interactions 巻 238 号 発行年 2017 頁 99	Effect of Silica Nanoparticle Filler on Microscopic Polymer α -Relaxation Dynamics
34493	15A 15B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	原著論文	Review of Scientific Instruments 巻 88 号 8 発行年 2017 頁 086110	Measurement of Synchrotron Radiation Phase- Space Beam Properties to Verify Astigmatism
34846	16B	3273	24XU	高尾 直樹 (株)日産アーク	口頭/ポ	プラスチック成形加工学会 第28回 年次 大会 開催日 2017.06.14-06.15 東京	ポリフェニレンサルファイド溶着試験片の界面構造と機 械強度の相関
34447	13A 13B	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気(株)	口頭/ポ	第55回 電池討論会 2014.11.19-11.21、京都	Li過剰層状正極0.2LiFeO2·0.2LiNiO2·0.6L2MnO3の 劣化解析
34422	13B 14A 14B	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気(株)	原著論文	Journal of Power Sources 巻 365 号 発行年 2017 頁 117-125	Structural and Electrochemical Properties of Iron- and Nickel-Substituted Li2MnO3 Cathodes in Charged and Discharged States
34256	13B 14A	3202	24XU	津坂 佳幸 兵庫県立大学	原著論文	Crystal Growth & Design 巻 17 号 7 発行年 2017 頁 3806- 3811	Homoeiptaxial Hydride Vapor Phase Epitaxy Growth on GaN Wafers Manufactured by the Na- Flux Method
34041	14A 15A 15B 16A 16B	3264	24XU	伊藤 廉 (株) ミルボン	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5&6 号 発行年 2017 頁 20-23	X線CTを用いた各国女性毛髪の観察
34035	14A 14B 14A 14B	3200 3203	24XU	 篭島 靖 兵庫県立大学 高野 秀和 丘庫県立大学 	原著論文	J. of Physics: Conference Series 巻 849 号 発行年 2017 頁 012052	Hard X-ray Multilayer Zone Plate with 25-nm Outermost Zone Width
33986	14B 15B	3326	08B2	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	原著論文	Molecular Crystals and Liquid Crystals 巻 648 号 1 発行年 2017 頁 162-167	Direct Structural Observation of the Alignment and Elongation in Lyotropic Chromonic Liquid Crystals under Shear Flow
33985	13B 14B	3326	08B2	鈴木 拓也 (株)三菱化学 科技術研究センター	原著論文	Molecular Crystals and Liquid Crystals 巻 648 号 1 発行年 2017 頁 29-34	Structural Evolution during Drying Process in Lyotropic Chromonic Liquid Crystal
33432	15B	3330	08B2	和泉 篤士 住友ベークライト (株)	口頭/ポ	11th International Gel Symposium 開催日 2017.03.07-03.09 Narashino	Structure-Mechanical Property Relationships in Crosslinked Phenolic Resins
33430	15B	3330	08B2	和泉 篤士 住友ベークライト (株)	口頭/ポ	第66回 ネットワークポリマー講演討論 会 開催日 2016.10.19-10.21 千葉	分子動力学シミュレーションによる架橋フェノール樹脂 の機械物性予測
33429	15B	3330	08B2	和泉 篤士 住友ベークライト (株)	口頭/ポ	高分子基礎物性研究会 · 計算機科学研究 会 合同討論会 開催日 2016.03.07-03.08 大阪	フェノール樹脂架橋構造の大規模全原子分子動力学モデ ル解析
33199	13B 14A 14B	3306	08B2	今泉 公夫 旭化成(株)	原著論文	Cement and Concrete Research 巻 91 号 発行年 2017 頁 24-32	Microstructural Changes in White Portland Cement Paste under the First Drying Process Evaluated by WAXS, SAXS, and USAXS
33176	13B 14A 14B 15A	3320	08B2	東口 光晴 旭化成(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5 号 発行年 2016 頁 15-19	In-situ XAFS/SAXS同時測定によるAuナノ粒子生成過 程解析
33013	02B	5054	24XU	安藤 正海 高エネルギー 加速器研究機構	原著論文	Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A 巻 548 号 1-2 発行年 2005 頁 1-16	Clinical Step Onward with X-ray Dark-Field Imaging and Perspective View of Medical Applications of Synchrotron Radiation in Japan
32821	15B	3325	08B2	末広 省吾 (株) 住化分析 センター	原著論文	Catalysis Communications 巻 90 号 発行年 2017 頁 1-4	Three-Way Catalytic Performance and Change in the Valence State of Rh in Y- and Pr-doped Rh/ZrO2 under Lean/Rich Perturbation Conditions

		-	-				
32490	14A 15B 16A	3265	24XU	堀川 智之 グローバルウェーハ ブ・ジャパン(株)	口頭/ポ	秋季応用物理学会学術講演会 2015.09.13-09.16、名古屋	高平行度X線散漫散乱法による酸素析出物解析
32483	14B	3202	24XU	2 2 2 7 7 2 (4) 津坂 佳幸 兵庫県立大学	招待講演	第13回 X線結像光学シンポジウム 2015 11 17-11 18、名古屋	多波近似条件近傍での高位置分解能X線トポグラフィ
32482	15B	3202	24XU	津坂佳幸	口頭/ポ	秋季応用物理学会学術講演会	転位バーガースベクトル決定のための等価な面からの同
	16A	OLOL	2 1/10	兵庫県立大学		2015.09.13-09.16、名古屋	時回折による放射光X線トポグラフィ
32481	14B 15A	3202	24XU	年 城 住辛 兵庫県立大学	口頭/ポ	秋季心用彻理子云子响调演云 2015.09.13-09.16、名古屋	多波回加米什トにのける高位直力所能へ称トホクラフィ Ⅱ. 応用と展開
32480	14B	3202	24XU	津坂 佳幸	ロ頭/ポ	秋季応用物理学会学術講演会	多波回折条件下における高位置分解能X線トポグラフィ
	15A 11B			兵庫県立大学 津坂 住幸		2015.09.13-09.16、名古屋 秋季広田物理学会学術講演会	I. 原理と特長 放射光X線によるNaフラックフ注CaNI単結具其板の結果
32479	13A	3202	24XU	兵庫県立大学	口頭/ポ	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	性評価
32272	15B	3231	24XU	三根生 晋	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	Li イオン電池正極材断面のX線マイクロビームによる反
	164			マツダ (株) 和良 笹士		巻 5 号 発行年 2016 頁 12-15	応分布解析
32271	15A	3330	08B2	1170 点 住友ベークライト (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 5 号 発行年 2016 頁 7-11	cos α 法による半導体パッケージ封止用熱硬化性樹脂/ 銅界面の熱時残留応力その場解析
32270	14B	3381	08B2	久保渕 啓	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	DSC/USAXS-SAXS-WAXS によるポリアミドナノ
	12A	3371	08B2	(休)日産アーク		を 5 亏 先行年 2016 貝 3-6	
32183	12A	3258	24 XII	半岩 美央里 丘庫県立大学	原著論文	Doctor Thesis (University of Hyogo)	放射光X線を用いた窒化カリウム結晶中の格子欠陥に関 する研究
	12B	5250	2470				
32139	15B	3330	0882	札泉 馬士 住友ベークライト	原摵論文	Polymer	Large-Scale Molecular Dynamics Simulation of Crosslinked Phenolic Resins using Pseudo-Reaction
52100			0002	(株)		巻 103 号 発行年 2016 頁 261-276	Model
32064	12A	3203	24XU	高野 秀和	原著論文	Japanese Journal of Applied Physics	Development of Hard X-ray Dark-Field Microscope
	12B	2250	0000	兵庫県立大学		巻 55 号 10 発行年 2016 頁 102401	using Full-Field Optics
31411	12B	3359	0862	鈴木 賢紀	原著論文	Society	Formation and Local Structure Analysis of High-
	13B	3248	24XU	入限入子		巻 99 号 9 発行年 2016 頁 3151-	Valence Chromium ion in Dicalcium Silicate
	11B 12A						
01154	12A	2201	0000		医苯酚去	Materials Science Forum	Dislocation Analysis of 4H-SiC Crystals Obtained at
31154	13A	3321	0882	(一射)電力中央 研究所	原者論义	巻 778-780 号 発行年 2014 頁 59-62	Fast Growth Rate by the High-Temperature Gas
13B				0,12,0,71			
	11A						
	12A						
31153	12B	3321	08B2	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	原著論文	Applied Physics Express 巻 7 号 12 発行年 2014 頁 121303	Three-Dimensional Imaging and Tilt-Angle Analysis of Dislocations in 4H-SiC by Two-Photon-Excited
01100	13B						Band-Edge Photoluminescence
	14A						
	14B 12B			横山 和司			
	13A	2210		兵庫県立大学			
	13B	5519	08B2	津坂 佳幸			
30662	14B 13B	3377			原著論文	Review of Scientific Instruments	X-ray Topography using the Forward Transmitted
	13A	0077				巻 87 号 2 発行年 2016 頁 023701	Beam under Multiple-Beam Diffraction Conditions
	13B	3202	24XU	津坂 佳幸			
	14B 15A			兴厚宗立入字			
	11A			高野 委和		AIP Conference Proceedings	Hard X-ray Nanofocusing using Total-Reflection
30488	11B	3203	24XU	兵庫県立大学	原著論文	巻 1696 号 発行年 2016 頁 020039	Zone Plates
	12A 12B						
30486	13A	3200	24XU	篭島 靖 丘庫県立大学	原著論文	AIP Conference Proceedings 券 1696 号 發行在 2016 百 020017	Upgrading Multilayer Zone Plate Technology for
	13B					2 1030 5 201 2010 2 020017	
30391	12B	3345	08B2	尾身 博雄 NTT日本雷信雷話	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	Energy Migrations and Transfers between Er3+
	.20	55 10		(株)		巻 4 号 発行年 2016 頁 31-35	lons in Er2SiO5 Films on SiO2/Si Substrate
20000	14A	2000 f	0.02	伊藤 廉		The 3rd Asia-Pacific Conference on	3D Images of South-Eastern Asian Hair using X-rav
30269	14B 154	3264	24XU	(株) ミルボン	□頭/ボ	Lite Science and Engineering	CT Method
20207	144	2064	24211	伊藤 廉	切注謙守	第6回毛髮科学技術者協会研究発表会報告	白影と田影にわけて見立の知日について
30267	14A	3204	24XU	(株) ミルボン	泊付調測	2015.02.04、東京	
30266	14A 154	3264	24XU	伊滕 廉 (株) ミルボン	招待講演		加射光を利用した頭髪用化粧品の開発 - 頭髪と頭皮の基 礎研究
	14A			伊薩 廣		山口市古大学工学部第200回コロナウム	ンー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30265	15A	3264	24XU	^{げ膝 康} (株) ミルボン	招待講演	山山宋永八子上子部第298回コロキワム 2015.09.11、山口	ルスオリルでかけしに 現差円10社回の用光 - 現差と 現皮の基礎研究 -
1	15B						

30264	14A 15A	3264	24XU	伊藤 廉 (株)ミルボン	総説	放射光 巻 28 号 5 発行年 2015 頁 210-213	放射光イメージングを用いた華麗と共に変化する毛髪内 構造評価
30256	13A	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気(株)	原著論文	Electrochimica Acta 巻 189 号 発行年 2016 頁 166-174	Charge Compensation Mechanism during Cycles in Fe-Containing Li ₂ MnO ₃ Cathode for High Energy Density and Low-Cost Lithium-Ion Batteries
30203	12B	3368	08B2	漆原 良昌 兵庫県立大学	原著論文	Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 巻 475 号 発行年 2016 頁 124-128	X-ray Micro-CT Observation of the Apical Skeleton of Japanese White Coral <i>Corallium konojoi</i>
30150	10B	3337	08B2	桑本 滋生 兵庫県立大学	原著論文	Cellulose 巻 22 号 5 発行年 2015 頁 2971- 2982	Mechanism of Structure Formation and Dissolution of Regenerated Cellulose from Cellulose/Aqueous Sodium Hydroxide Solution and Formation of Molecular Sheets Deduced from the Mechanism
30083	13A 13B	3375	08B2	北原 周 (株) コベルコ科研	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 27-30	Cr異常分散小角散乱法を用いたCu-Cr合金中析出物の評価
30082	13A 13B 14A 14B	3352	08B2	大江 裕彰 東洋ゴム工業(株) 城出 健佑 東洋ゴム工業(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 24-26	放射光を利用したゴム階層構造追跡(3)
30081	12B	3352	08B2	大江 裕彰 東洋ゴム工業(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 21-23	放射光を利用したゴム階層構造追跡(2)
30074	14B	3231	24XU	住田 弘祐 マツダ (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 18-20	Li イオン電池正極材断面のX線マイクロビームによる充 放電挙動解析
30073	14A 14B	3330	08B2	首藤 靖幸 住友ベークライト (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 15-17	SAXS/WAXD/XAFS同時測定による銅ナノ粒子焼結過 程のその場観察
29763	14B	3381	08B2	久保渕 啓 (株)日産アーク	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2015.01.10-01.12、草津	DSC/SAXSによるポリアミドの高次構造解析
29655	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	原著論文	Materials Science Forum 巻 778-780 号 発行年 2014 頁 366- 369	Characterization of Threading Edge Dislocation in 4H-SiC by X-ray Topography and Transmission Electron Microscopy
29651	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	口頭/ポ	日本顕微鏡学会 第70回 記念学術講演会 2014.05.11-05.13、千葉	LACBED法を用いた4H-SiC中の貫通混合転位の同定
29650	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	原著論文	AMTC Letters 巻 4 号 発行年 2014 頁 178-179	Characterization of Dissociated Threading Edge Dislocation Formed in 4H-SiC by Transmission Electron Microscopy
29305	11B 12B	3209	24XU	菅野 宏明 三井化学(株)	ロ頭/ポ	第62回 レオロジー討論会 開催日 2014.10.15-10.17、福井	結晶化度分布の予測と実測
29304	11B 12B	3209	24XU	菅野 宏明 三井化学(株)	口頭/ポ	Asian Workshop on Polymer Processing 2014.11.17-11.20, Kenting, Taiwan	Construction of the Prediction Model for Relative Crystallinity Distribution of the Cast Film with Induction Time
29303	11B 12B	3209	24XU	菅野 宏明 三井化学(株)	口頭/ポ	成形加エシンポジア'14 2014.11.14-11.15、新潟	押出フィルムの相対結晶化度分布の予測と実測
29294	13A 13B	3247	24XU	中野 真也	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	4 次元X線CTを用いたポリマーフォームの気泡形成挙動
	14A 12A	3380	08B2			答 4 亏 先11年 2015 頁 12-14	観奈
28944	12B 13B 14A	3329	08B2	立石 純一郎 (株)アシックス	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 8-11	X線CTを用いた圧縮変形下におけるポリマーフォームの セル構造観察
28696	12B	3261	24XU	三浦 靖史 (一財)電力中央 研究所	公開技報	サンビーム年報・成果集 巻 4 号 発行年 2015 頁 42-45	オーステナイト系ステンレス鋼の微小部応力測定手法の 基礎検討
28690	12A 12B 12B 13A	3318 3320	08B2	東口 光晴 旭化成(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 4 号 1 発行年 2015 頁 3-7	In-situ XRDによるFe2Mo3O12の焼成過程解析
28663	13B	3379	08B2	高柳 篤史 日本ゼオン(株)	原著論文	高分子論文集 (Japanese Journal of Polymer Science and Technology) 巻 72 号 3 発行年 2015 頁 104-109	Relationship between Microphase Separation Structure and Physical Property of Thermoplastic Elastomer Mixtures
28535	13A 13B 14A	3102	24XU	尾身 博雄 NTT日本電信電話 (株)	原著論文	Optics Express 巻 23 号 6 発行年 2015 頁 7021	Effect of Structure and Composition on Optical Properties of Er-Sc Silicates Prepared from Multi- Nanolayer Films
28448	12A 12B	3202	24XU	津坂 佳幸 兵庫県立大学	原著論文	Japanese Journal of Applied Physics 巻 53 号 5S 発行年 2014 頁 05FA06	Growth of Bulk GaN Crystals by the Na-flux Point Seed Technique
28383	12B	3255	24XU	小寺 賢 神戸大学	原著論文	Proceedings of the ADHESION '13 巻 号 発行年 2013 頁 71	Synchrotron Structural Analysis of Isotactic Polypropylene / Adhesive Interface
28160	10B	3241	24XU	久米 卓志 花王(株)	招待講演	第2回コロイド実用技術講座「分散・凝 集技術のすべて」 2014.11.19-11.20、東京	放射光・中性子線を用いた溶液分散系や生体組織の評価 の最前線

28157	10B	3241	24XU	久米 卓志 花王(株)	招待講演	日本化学会 春季年会 2014.03.27-03.30、名古屋	放射光小角X線散乱解析を用いた化粧品開発研究
28149	11B	3356	08B2	河辺 雅義 (株) 日東分析セン ター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 64-66	ネオジウム磁石の水素吸蔵脱離反応の解明
28147	12A 12B 12B	3258 3371	24XU 08B2	平岩 美央里 パナソニック(株)	原著論文	Japanese Journal of Applied Physics 巻 54 号 2 発行年 2015 頁 025503	Evaluation of a-type Screw Dislocations in m-GaN Film by Means of X-ray Diffractometry
28057	13B 14A	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気(株)	ロ頭/ポ	第55回 電池討論会 2014.11.19-11.21、京都	Li過剰層状正極0.2LiFeO2・0.2LiNiO2・0.6Li2MnO3の劣 化解析
28032	11B	3238	24XU	末広 省吾 (株)住化分析 センター	原著論文	Electrochemistry 巻 83 号 1 発行年 2015 頁 2-6	Analysis of Three-dimensional Porous Network Structure of Li-ion Battery Electrodes
28018	11A 12B	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	招待講演	SiC及び関連半導体研究 第22回講演会 2013.12.09-12.10、埼玉	X線3Dトポグラフィーおよび非線形光学的手法による 4H-SiC拡張欠陥のイメージング
28017	12B	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	ロ頭/ポ	2013 International Conference on Solid State Devices and Materials 2013.09.24-09.27、福岡	Characterization of a Basal-Plane Dislocation in 4H-SiC by X-Ray Three-Dimensional Topography and Transmission Electron Microscopy
28015	11B 12A	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	口頭/ポ	SiC及び関連ワイドギャップ半導体 研究会 第21回講演会 2012.11.19-11.20、大阪	X線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および 貫通刃状転位の解析
28014	10B 11A	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 1 号 発行年 2012 頁 83-85	X線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および 貫通刃状転位のイメージング
28013	11B 12A	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	口頭/ポ	2012 International Conference on Solid State Devices and Materials 2012.09.25-09.27、京都	X-Ray Three-Dimensional Topography Analysis of Basal-Plane Dislocations and Threading Edge Dislocations in 4H-SiC
27993	13A 13B 14A	3373	08B2	高原達夫 (株)住化分析 センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 61-63	放射光 XRD による機能性材料の精密構造解析
27991	12B 13A 13B 14A	3325	08B2	中津 和弘 高原達夫 (株) 住化分析 センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 59-60	XAFS によるエネルギーデバイス材料の局所構造解析
27989	12B 13A	3220	24XU	未広省吾・高原達夫 (株)住化分析 センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 56-58	各種材料の X 線イメージングによる機構の解明
27988	12A	3365	08B2	中前 勝彦 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 54-55	天然ゴム結晶の応力下での変形挙動の解析
27987	11B	3360	08B2	荻野 千秋 神戸大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 51-53	イオン液体前処理セルロースの微細構造解析
27779	11B	3324	08B2	中津 和弘 (株) 住化分析 センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 48-50	小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス材料のナノ 構造解析
27778	11B	3238	24XU	末広 省吾 (株)住化分析 センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 46-47	活物質特性に及ぼす電極構造の影響の解明
27777	11B	3363	08B2	上野 勝之 参天製薬(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 43-45	水中での眼内レンズの分子構造解析
27776	11B	3326	08B2	伊村 宏之 (株) MCHC R&D シナジーセンター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 39-42	放射光を用いた X 線回折測定によるリチウムイオン二次 電池のサイクル劣化解析
27775	12B 13A 13B	3204	24XU	戸田 昭夫 日本電気(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 36-38	リチウムイオン二次電池負極断面のマイクロビームXRF 法による元素マッピング
27774	11B 12B	3340	08B2	菅野 宏明 三井化学(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 1 発行年 2014 頁 33-35	融点以上で流動結晶化させたアイソタクチックポリプロ ピレンの構造と物性の解析
27770	11B	3357	08B2	田中 智子 江崎グリコ(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 36-38	エナメル質に形成された初期むし歯(初期う蝕)の再石 灰化過程におけるその微細構造回復に与えるリン酸化オ リゴ糖カルシウムの影響の時空間的解析
27667	11B 12A	3250	24XU	嶺重 温 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 16-21	アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価
27666	11B 12B	3209	24	菅野 宏明 三井化学(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 13-15	マイクロビーム広角X線散乱法を用いたポリプロピレン のフィルムキャスティング計算機シミュレーションの評 価
27665	12A 12B	3102	24XU	尾身 博雄 NTT日本電信電話 (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2013 頁 44-48	Mixture Formation of $Er_xYb_{2-x}Si_2O_7$ and $Er_xYb_{2-x}O_3$ on Si for Broadening the C-band in an Optical Amplifier

27641	11B 12B	3209	24XU	菅野 宏明 三井化学(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 13-15	マイクロビーム広角X線散乱法を用いたポリプロピレン のフィルムキャスティング計算機シミュレーションの評 価
27619	12B 13B	3331	08B2	山本 友之 日本合成化学工業 (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 22-25	ポリビニルアルコールを用いたアクリル系エマルション 皮膜の小角X線散乱(SAXS)による構造解析
27618	13A 13B	3330	08B2	首藤 靖幸 住友ベークライト (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 26-28	<i>In-situ</i> Quick-XANES測定による金属ナノ粒子焼結過程 における銅価数変化の観察
27605	12A 12B 13A	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気(株)	原著論文	J. of the Electrochemical Society 巻 161 号 14 発行年 2014 頁 A2237- A2242	Remarkable Charge-Discharge Mechanism for a Large Capacity in Fe-containing Li ₂ MnO ₃ Cathodes
27531	14A	3264	24XU	伊藤 廉 (株) ミルボン	招待講演	第11回産業利用報告会 2014.09.05、姫路	加齢に伴う毛髪内密度の変化とX線CTによる観察
27474	12B 13B	3331	08B2	山本 友之 日本合成化学工業 (株)	口頭/ポ	高分子討論会 2014.09.24-09.26、長崎	選択溶媒によるナノマトリックス構造を有するポリビニ ルアルコール保護コロイド皮膜のモルフォロジー変化
27405	11B 12B	3230	24XU	澤部 孝史 (一財)電力中央 研究所	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 7-12	マイクロビームX線を利用した燃料被覆管材の酸化膜の 局所応力解析手法の検討
27404	11B	3318	08B2	山崎 輝昌 旭化成(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 3 号 発行年 2014 頁 3-6	粉末X線回折における無機化合物の評価–Feの異常散乱–
27328	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	原著論文	ECS Journal of Solid State Science and Technology 巻 2 号 8 発行年 2013 頁 N3092- N3097	Dislocation Conversion in 4H-SiC Crystals Grown by Metastable Solvent Epitaxy
27184	12A	3102	24XU	尾身 博雄 NTT日本電信電話 (株)	原著論文	Optical Materials Express 巻 4 号 9 発行年 2014 頁 1747-1755	Simultaneous Light Emissions from Erbium-Thulium Silicates and Oxides on Silicon in the Second and Third Telecommunications Bands
27165	13A 13B	3102	24XU	尾身 博雄 NTT日本電信電話 (株)	原著論文	Nano Research Letters 巻 9 号 1 発行年 2014 頁 356	Scandium Effect on the Luminescence of Er-Sc Silicates Prepared from Multi-Nanolayer Films
26754	12A 12B 13A 13B	3366	08B2	岸本 浩通 住友ゴム工業(株)	原著論文	Doctor Thesis (The University of Tokyo)	Study on Hierarchical Spatio-Temporal Structure of Rubber Composite with Synchrotron X-rays and Neutron
26020	13A	3326	08B2	鈴木 拓也 (株)三菱化学 科技術研究センター	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 25-27	有機薄膜材料のX線散乱構造解析
25945	10B 11A 11B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2013 頁 35-43	Inclined-incidence Microprism-array Optical Device for Prefocusing Hard X-ray Beams
25902	10A 10B 11A 11B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	原著論文	Journal of Synchrotron Radiation 巻 21 号 2 発行年 2014 頁 446-448	Point Spread Function Measurement of an X-ray Beam Focused by a Multilayer Zone Plate with Narrow Annular Aperture
25864	11B 11B	3248 3359	24XU 08B2	鈴木 賢紀 大阪大学大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 53-57	Crを含む酸化鉱物相におけるCrイオン近傍の局所微細構 造の解析
25762	12B	3302	08B2	李 雷 (公財)ひょうご 科学技術協会	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 21-24	BL08B2における空間分解XAFS整備現状
25755	11B 11B 12A	3353 3233 3253	08B2 24XU	横山 和司 (公財)ひょうご 科学技術協会	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 58-62	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ
25753	12A 12B 12B	3229 3330	24XU 08B2		公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2013 頁 31-34	小角X線散乱法と逆モンテカルロ法を用いた構造発色 フィルムの構造解析
25750	12B 13A	3306	08B2	松下 忠史 旭化成(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 49-52	高立体規則性ポリブタジエン系材料の構造と特性 – X線 散乱解析による一軸伸長結晶化挙動の観察 –
25749	11B 12A 12B	3247	24XU	中野 真也 日東電工(株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 2 号 発行年 2014 頁 28-30	4 次元X線CTを用いたポリマーフォームの気泡形成挙動 観察
25650	11A	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	原著論文	Applied Physics Letters 巻 104 号 2 発行年 2014 頁 023108	Hard X-ray Nanoimaging Method Local Diffraction from Metal Wire
25255	13A 12B 12A	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	招待講演	The 12th Symposium on X-ray Imaging Optics 2013.11.18-11.20、大阪	Development of Total Reflection Zone Plate for Hard X-ray Focusing

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

	12A	2047		中野 真也			
25254	11B	3247	04711	日東電工(株)	厉莱泠女	Journal of Physics: Conference	Development of Real-Time X-ray Microtomography
25254	12A	2202	24XU	高野 秀和	原者論义	Series ※ 462 号 發行在 2012 百 012025	System
	11B	3203		兵庫県立大学		各 403 亏 光11年 2013 頁 012023	
				首藤 靖幸		The 5th RMC Conference	Structures of Colloidal Silica in Acrulic Network
25030	11B	3330	08B2	住友ベークライト	口頭/ポ	2012.09.20-09.22, Budapest,	Films
				(株)		Hungary	
	11A			佐藤 健太			
	10B			妹尾 政宣		15th International Small-Angle	Elucidation of Correlation between Structure and
25029	10A	3330	08B2	住友ベークライト	口頭/ポ	Scattering Conference	Optical Properties in Nanoslilica Composite
	09B			(株)		2012.11.18-11.23, Sydney, Australia	
	09A			CPIO			
	11B						
25006	10B	3329	08B2	立石 純一郎	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	X線CTによるポリマーフォームのセル構造観察
	10A			(株)アシックス		巻 1 号 発行年 2012 貞 41-43	
	09B						
				山口 聡		The International Conference on	Observation of Dissociated Threading Dislocation
24997	09B	3322	08B2	(株)豊田中央	ロ頭/ポ	Silicon Carbide and Related Materials	Formed in 4H-SiC by Transmission Electron
				研究所		2013 (ICSCRM2013)	Microscopy
						2013.09.29-10.04、宮崎	
24947	13A	3202	24XU	津坂 佳幸	ロ頭/ポ	秋季応用物理学会学術講演会	高平行度X線マイクロビームによる光導波路用Ge結晶の
	12B			兵庫県立大学		2013.09.16-09.20、京田辺	結晶性評価
24936	12B	3200	24XU	篭島 靖	ロ頭/ポ	22nd International Congress on X-	Development of Linear and Circular Type MoSi ₂ /Si
	09B			兵庫県立大学		ray Optics and Microanalysis	Multilayer Laue Lenses
	12B			鈴木 拓也		丘庫倶ビームライン年報・成果集	
24899		3326	08B2	(株)三菱化学	公開技報	※単果と エットシー報 成本果 巻1 号 発行在 2012 百 30-40	有機半導体材料のX線散乱構造解析
	12A			科技術研究センター		215元11年2012頁35-40	
				山口 聡		第13回サンビーム研究発表会/第10回	
24895	09B	3322	08B2	(株)豊田中央	ロ頭/ポ	SPring-8產業利用報告会	放射光トホクラフィによるSiCエヒタキシャル腺甲の転
				研究所		2013.09.05-09.06、神戸	位の観察
	12B			横山 和司			
24885	12A	3253	24XU	(公財) ひょうご	公開技報		マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ
	11B			科学技術協会		巻 号 発行年 2012 貝 /5-82	
	12A	3220	24XU	中津 和弘			
24881	12A			(株) 住化分析	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所構造解析
	11B	3325	08B2	センター		巻 1 号 発行年 2012 頁 51-53	
	12A			坂本 直紀		兵庫県ビームライン年報・成果集	合成ゴムの構造と特性との相関性 — X線散乱解析によ
24879	11B	3306	08B5	旭化成(株)	公開技報	巻1号発行年2012頁102-104	る一軸伸長結晶化挙動の観察―
04010	110	3249	24XU	曽根 卓男	医苯酚土	日本ゴム協会誌	小角X線散乱を用いた配合物中での充てん剤凝集構造の
24812	ПВ	3355	08B2	JSR(株)	原者論义	巻 86 号 8 発行年 2013 頁 249-255	解析-溶液重合SBR末端に導入した官能基の効果
24525	110			尾身 博雄			Light Emission from Lithium Silicates and Oxides
24525	110	3102	24XU	NTT日本電信電話	原著論文	AIP Advances	for Optical Amplifiers on Silicon in the Extended
	11A			(株)		巻 3 号 7 発行年 2013 貞 072122	Optical Communications Band
	12B						
	120	3321	08B2				
	12R			土田 秀一		Journal of Applied Physics	X-ray Microbeam Three-Dimensional Topography
24494	120			(一財)電力中央	原著論文	券 114 号 2 発行年 2013 百 023511	for Dislocation Strain-Field Analysis of 4H-SiC
	11R	3237	24XU	研究所			
	114						
	118						
24360	104	3200	24XU	篭島靖	総説	光学	ナノファブリケーション技術によるX 線光学素子開発
	09R	5200		兵庫県立大学	100.070	巻 42 号 6 発行年 2013 頁 289-295	―フレネルゾーンプレート系X 線集光素子について―
	105						Constant-Pitch Microprism-Array Optical Dovice
23055	TOB	3200	2480	篭島 靖	佰 莱論 立	Journal of Applied Physics	for Beam Condensers in Hard Y, roy Synchrotron
23355	114	5200	2470	兵庫県立大学	小白洲人	巻 113 号 21 発行年 2013 頁 214314	Radiation Reamlines
	100						
23797	12B	3202	24XU	軍収 住辛 ら 度 月 古 上 尚	口頭/ポ	春李応用物理学関係連合講演会	放射光X線によるNa ノフックス法GaN単結晶基板の結晶
	12A			兵庫県立大学		2013.03.27-03.30、厚木	1953年1曲
	118						
	IIA						
23769	TOR	3202	24XU	「「「「「「「」」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 」 」 「」 」 」 「」 」 」 」 一 二 一 一 二 一 一 二 一 一 二 一 一 一 二 一 一 一 一	公開技報		高平行度X線マイクロビームの形成とその応用研究
	10A			兵庫県立大学		を 1 亏 光行牛 2012 貝 57-60	
	09B						
	09A						
23768	11B	3205	24XU	甲川 武志	公開技報		リナワムイオン電池止極材の放電過程における局所構造 ホル
	104						
23764	12A	3204	24XU		公開技報		ッテンム1 イノー水電池の貝樫におけるMN分布のマイ
	118	2050	2411	口平電丸(株)		② 「 亏 元17年 2012 貝 98-101	フロビームARF法による評価
	12A	3250	24XU	十江 公部		6度周ビールラインケセ・00月年	
23760	12A	3252	0282	八八 宿野 南洋ゴム工業(姓)	公開技報		放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡
	118	5552	0002	ホイコムエ米(休)		ビーラ元11年2012 頁 40-30	

Status Report of Hyogo-Beamlines with Research Results, Vol. 5, 6 (2016, 2017)

23759	11B	3255	24XU	西野 孝 神戸大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 1 号 発行年 2012 頁 67-70	微小角入射X線回折法によるポリ-α-オレフィン/接着剤 界面の微細構造
	10B 10A 09B	3229	24XU	佐藤 健太		ら度順ビ ルニノンケセ・ポ田住	ナノフィニー ついポンジット せの接法 と物理性性 との 石間
23756	10B 10A 09B 09A	3330	08B2	住友ベークライト (株)	公開技報	共庫県ビーム クイク イ 秋・成未美 巻 1 号 発行年 2012 頁 44-47	アファイ フーコンパシット初の構造と初述付任との指則 解明
23723	11B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2013.01.12-01.14、名古屋	軽元素試料観察のための走査型硬 X 線顕微鏡の開発
23468	08A 07B 07A	3222	24XU	向井 孝志 日亜化学工業(株)	招待講演	第131回 結晶工学分科会研究会 2009.07.17、京都	放射光を利用した窒化物光半導体の評価
23451	12A 11B	3102	24XU	尾身 博雄 NTT日本電信電話 (株)	原著論文	AIP Advances 巻 3 号 4 発行年 2013 頁 042107	Mixture Formation of $Er_xYb_{2-x}Si_2O_7$ and $Er_xYb_{2-x}O_3$ on Si for Broadening the C-band in an Optical Amplifier
23340	11B 10B	3331	08B2	山本 友之 日本合成化学工業 (株)	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 1 号 発行年 2012 頁 33	小角X線散乱(SAXS)によるアクリル系エマルション粒子 および皮膜の構造解析
23323	11A 10B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	原著論文	Japanese Journal of Applied Physics 巻 52 号 4 発行年 2013 頁 040204	Simple Scanning Phase-Contrast X-ray Tomography Using Intensity Detectors
23322	11B 11A 10B 10A 09B 09A	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 1 号 発行年 2012 頁 61-66	BL24XUにおけるマイクロビーム、マイクロイメージン グの高度化
23320	12A 11B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム	リアルタイム4次元マイクロトモグラフィ法の開発
23319	12A 11B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	International Conference on X-ray Microscopy (XRM) 2012.08.05-08.10, Shanghai, China	Development of Real-Time X-Ray Micro-CT System
23318	11A	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2012.01.06-01.09、鳥栖	X線ナノ集光用全反射ゾーンプレートの開発
23149	10B 10A 09B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	公開技報	兵庫県ビームライン年報・成果集 巻 1 号 発行年 2012 頁 54-56	硬X線ナノ集光用円形多層膜ゾーンプレートの製作と性 能評価
23052	11B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2013.01.12-01.14、名古屋	硬X線集光ビームを用いたリソグラフィ法の研究
23031	12B	3202	24XU	津坂 佳幸 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンボジウム 2013.01.12-01.14、名古屋	ラウエゾーン型X線導波路の開発
22967	12B	3203	24XU	高野 秀和 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2013.01.12-01.14、名古屋	高感度硬X線結像顕微鏡光学系の開発
22862	12B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	口頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム 2013.01.12-01.14、名古屋	高エネルギー用高アスペクト比多層膜ゾーンプレートの 設計
22810	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	口頭/ポ	SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究 会第21回講演会 2012.11.19-11.21、大阪市	4H-SiC中のc+aバーガースベクトルを有する貫通転位の 同定
22424	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	口頭/ポ	2012 International Conference on Solid State Devices and Materials 2012.09.25-09.27、京都	LACBED Analysis of Threading Dislocation with c+a Burgers Vector in 4H-SiC
22312	09B 10B	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	原著論文	Applied Physics Letters 巻 101 号 16 発行年 2012 頁 163102	Inclined-Incidence Quasi-Fresnel Lens for Prefocusing of Synchrotron Radiation X-ray Beams
22076	11B 11A	3346	08B2	戸田 昭夫 日本電気 (株)	原著論文	Journal of the Electrochemical Society 巻 159 号 9 発行年 2012 頁 A1398- A1404	Drastically Improved Performances of Graphite/Li _{1.26} Mn _{0.52} Fe _{0.22} O ₂ Cell with Stepwise Pre-Cycling Treatment that Causes Peroxide Forming
22055	09B	3322	08B2	山口 聡 (株)豊田中央 研究所	原著論文	Applied Physics Express 巻 5 号 8 発行年 2012 頁 081301	Transmission Electron Microscopy Analysis of Threading Dislocation with c + a Burgers Vector in 4H-SiC
21825	11B	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	口頭/ポ	第20回 シリコンカーバイド(SiC)及び関 連ワイドギャップ半導体研究会 2011.12.08-12.09、名古屋	X線3Dトポグラフィーによる4H-SiC基底面転位および 貫通刃状転位のイメージング

21824	11A	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	口頭/ポ	14th International Conference on Defects-Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors 2011.09.25-09.29、宮崎	Imaging and Strain Analysis of Threading-Edge and Basal-Plane Dislocations in 4H-SiC Using X-Ray Three-Dimensional Topography
21823	10B	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	口頭/ポ	International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 開催日 2011.09.11-09.16, Cleveland, USA	X-Ray Three-Dimensional Topography Imaging of Basal-Plane and Threading-Edge Dislocations in 4H-SiC
21822	10В 11А	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	原著論文	Materials Science Forum 巻 725 号 発行年 2012 頁 3-6	Imaging and Strain Analysis of Threading-Edge and Basal-Plane Dislocations in 4H-SiC Using X-ray Three-Dimensional Topography
21821	10В 11А	3237	24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	原著論文	Materials Science Forum 巻 717-720 号 発行年 2012 頁 323- 326	X-Ray Three-Dimensional Topography Imaging of Basal-Plane and Threading-Edge Dislocations in 4H-SiC
21814	08A	3222	24XU	向井 孝志 日亜化学工業(株)	原著論文	Journal of Crystal Growth 巻 311 号 10 発行年 2009 頁 3015- 3018	Bulk Ammonothermal GaN
21813	07A	3222	24XU	向井 孝志 日亜化学工業(株)	原著論文	Journal of Crystal Growth 巻 310 号 17 発行年 2008 頁 3911- 3916	Excellent Crystallinity of Truly Bulk Ammonothermal GaN
21784	10B 10A	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	原著論文	Review of Scientific Instruments 巻 83 号 1 発行年 2012 頁 013705	Circular Multilayer Zone Plate for High-Energy X- ray Nano-Imaging
21466	11B 11A 11B 11A 10B	3321 3237	08B2 24XU	土田 秀一 (一財)電力中央 研究所	原著論文	Applied Physics Express 巻 5 号 6 発行年 2012 頁 061301	X-ray Microbeam Three-Dimensional Topography Imaging and Strain Analysis of Basal-Plane Dislocations and Threading Edge Dislocations in 4H-SiC
21221	11B 11A	3200	24XU	篭島 靖 兵庫県立大学	ロ頭/ポ	日本放射光学会年会・放射光科学合同シ ンポジウム	CT再構成法によるX線円形多層膜ラウエレンズの集光特 性評価

利用実験課題リスト(BL08B2)

※JASRIの成果公開基準を満たす成果(査読付き論文または研究成果集)のみのリスト

2017A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3302	李雷	兵庫県立大学	BL08B2 XAFSステーションの調整	
2221	维田 功績	(トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	
3321	第日 乞谚	(一刻)電力中关研究所	課題名 BL08B2 XAFSステーションの調整 トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ シャル膜中の欠陥評価 放射光を利用したゴム中の階層構造追跡 BL08B2における研修会	
3352	城出 健佑	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡	
3393	桑本 滋生	兵庫県立大学	BL08B2における研修会	

2016B

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.	
3302	李雷	兵庫県立大学	BL08B2 XAFSステーションの調整		
3321	鎌田 市積		トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ		
	第日 乞谚	(一刻)電力中关研究所	シャル膜中の欠陥評価		
2220	和白 笨上	けちゃ クライト (井)	半導体パッケージ用熱硬化性樹脂の高次構造	25160	
3330	和永 馬上	住及ベージリイト(株)	解析4	30109	
2246	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	口木電气(株)	次世代リチウムイオン二次電池用正極材料の		
3340			局所構造解析		
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡		
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	高分子複合材料中の構造形成と反応解析5		

2016A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2221	鎌田 市積		トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	
3321	業日 乞寇	(一刻)電力中天研究所	シャル膜中の欠陥評価	
2225			XAFSによるエネルギーデバイス材料の構造	
3325 末広 省吾	木仏 自音	(株)注化方析センター	解析	
2220			半導体パッケージ用熱硬化性樹脂の高次構造	25100
3330	机永 馬工	住友ページライト(休)	解析3	35169
2246			次世代リチウムイオン二次電池用正極材料の	
3340	户田 昭天	日本電気(休)	構造評価	
3352	城出 健佑	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡	35171
3354	横山 和司	兵庫県立大学	陶磁器釉薬の発色機構の解明	
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	高分子複合材料中の構造形成と反応解析4	35075
3389	住田 弘祐	マツダ (株)	触媒材料のin-situ XAFS	

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3321	鎌田 功穂	(一財)電力中央研究所	トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ シャル膜中の欠陥評価	
3324	末広 省吾	(株)住化分析センター	小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス 材料の構造解析	
3325	末広 省吾	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の構造 解析	32821
3326	鈴木 拓也	(株)MCHC R&D シナジーセンター	有機薄膜材料のX線散乱構造解析	33986
3330	和泉 篤士	住友ベークライト(株)	半導体パッケージ用熱硬化性樹脂の高次構造 解析	32139 32271

3346	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン二次電池用正極材料の 局所構造解析	
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	高分子複合材料中の構造形成と反応解析3	35075
3373	末広 省吾	(株)住化分析センター	放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析	
3386	藤江 正樹	三菱レイヨン(株)	高分子の結晶化構造評価	
3387	永田 祥平	兵庫県立大学	XANES・粉末X線回折常時測定によるAl2O3 を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ ミュレーション予測	
3388	犬飼 潤治	山梨大学	in-situ 電気化学セルを用いた燃料電池用白金 触媒のXAFS測定	35211
3389	横山 和司	兵庫県立大学	触媒材料および薄膜試料の構造評価	35167

2015A

LUIDA				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3320	東口 光晴	旭化成(株)	無機材料の製造・使用プロセス下その場解析	33176
2221			トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	
3321	球田 切惚	(一刻)電力中央研究所	シャル膜中の欠陥評価	
2225	十千 冬田		XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所	
3325	木仏 自音	(株)注化方価センター	構造解析	
3330	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	金属ナノ粒子の構造および化学状態の解明	32271
2246			次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料	
3340	户田 哈大		の構造解析	
3354	横山 和司	兵庫県立大学	陶磁器釉薬の発色機構の解明	
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	高分子複合材料中の構造形成と反応解析2	35075
3386	藤江 正樹	三菱レイヨン(株)	高分子の結晶化構造評価	
			XANES・粉末X線回折常時測定によるAl ₂ O ₃	
3387	永田 祥平	兵庫県立大学	を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ	
			ミュレーション予測	

20110				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2200			高立体規則性ポリブタジエン系材料のX線散	22100
3306	今永 公大	旭北风(株)	乱による構造解析	33199
3319	津坂 佳幸	兵庫県立大学	次世代半導体基板のトポグラフィ観察	30662
3320	東口 光晴	旭化成(株)	XAFSによる食塩電解用電極の化学状態解析	33176
2221	十日 米		トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	21152
3321		(一刻)電力中央研究所	シャル膜中の欠陥評価	31103
2224	百四 法土	(性) けんしゃちょうし	小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス	
3324	同尿 连大	(株)住宅方街センター	材料のナノ構造解析	
2225	百四 法土	(性) けんしゃちょうし	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所	
3320	同尿 连大	(株)住宅方街センター	構造解析	
2226	鈴木 切出	(株)MCHC R&D	ち機薄暗材料のX線数利構造解析	33985
3320	亚小 招也	シナジーセンター	有成海族物料の木林取む伸迫胜物	33986
2220	古碑 诗子	付ちベークライト(件)	半導体パッケージ用封止樹脂の熱硬化過程に	20072
3330	日豚 明千		おける高次構造変化その場観察	30073
2246	百田 叼土	口木電气(件)	次世代リチウムイオン二次電池材料の構造解	24422
3340			析	34422
3352	城出 健佑	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡	30082
3354	横山 和司	兵庫県立大学	陶磁器釉薬の発色機構の解明	
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	高分子複合材料中の構造形成と反応解析	35075
3373	高原 達夫	(株)住化分析センター	放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析	
3381	久保渕 啓	(株)日産アーク	DSC/USAXSによるポリマーの高次構造解析	32270

2014A				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3306	今泉 公夫	旭化成(株)	高立体規則性ポリブタジエン系材料のX線散 乱による構造解析	33199
3320	東口 光春	旭化成(株)	XAFSによる複合金属酸化物の構造解析	33176
2221			トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	31153
3321	工田 汚一	(公煎)電力中天研究所	シャル膜中の欠陥評価	31154
3325	高原 達夫	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所 構造解析	27991
3329	立石 純一郎	(株)アシックス	ポリマーフォームのX線イメージング	28944
3330	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	半導体パッケージ用封止樹脂の熱硬化過程に おける高次構造変化その場観察	30073
3346	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン二次電池材料の構造解 析	34422
3352	城出 健佑	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	30082
3366	松本 典大	住友ゴム工業(株)	ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析	
3373	高原 達夫	(株)住化分析センター	放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析	27993
3380	中野 真也	日東電工(株)	フォーム材の多孔形成挙動の動的3次元観察	29294

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3306	今泉 公夫	旭化成(株)	高分子構造の小角X線散乱測定6	33199
3319	津坂 佳幸	兵庫県立大学	次世代半導体基板のトポグラフィ観察	30662
3320	東口 光春	旭化成(株)	XAFSによる複合金属酸化物の構造解析	33176
2221	十四 禾	(2)时) 雷力中中环突派	トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	31153
3321	工田 秀一	(公則)電力中关研究所	シャル膜中の欠陥評価	31154
2224	百百 法土	(株) 住化分析センター	小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス	
3324	同尿 连大	(株)住宅方術センター	材料のナノ構造解析	
2225	百百 法土	(株) 住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所	27001
3320	同尿 连大	(株)住宅方術センター	構造解析	27991
2226	给木 坛地	(株)三菱化学科学技術研究	「「「「「「」」」を発行していた。	22025
3320		センター	府波淳族的科の不够取品牌色胜加	33905
2220	立石 紘一郎	(株)アミックフ	圧縮変形下におけるポリマーフォームのX線	28044
3329	꼬긴 째 파		イメージング	20944
2220	ざ 蒔 法 寺	付ちベークライト(件)	ナノフィラーコンポジット材のフィラーの構	27619
3330	日旅 明辛	住及ベージライト(株)	造および分散状態の解明	27010
3331	山木 友之	口木合成化学工業 (株)	ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル	27610
3331			系樹脂のナノ構造解析	27013
2246	百田 叼土	口木電气(株)	次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料	24422
3340			の構造解析	34422
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	30082
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析	26754
3373	高原 達夫	(株)住化分析センター	放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析	27993
2275	小区 田	(株)コベリコ料理	異常小角散乱をもちいた、合金中の析出相の	20082
3375	10次 同	(休)コイルコ科研	観察(I)	30063
7772	松井 結 命	丘库 周立十尚	フィルム以外の感光材を用いた高解像度X線	20662
3377	れんナナ が出図	大津宗立入子	トポグラフィ	30002

2013A				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3306	松下 忠史	旭化成(株)	高分子構造の小角X線散乱測定5	25750
3319	横山 和司	放射光ナノテクセンター	次世代半導体基板のトポグラフィ観察	30662
3320	東口 光春	旭化成(株)	XAFSによる複合金属酸化物の構造解析	28690
2221	+□ 禾_		トポグラフィ測定による4H-SiCエピタキ	31153
3321	工田 秀一	(公別)電力中关研究所	シャル膜中の欠陥評価	31154
3325	高原 達夫	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所 構造解析	27991
3326	鈴木 拓也	(株) 三菱化学科学技術研究 センター	有機薄膜材料のX線散乱構造解析	26020
3330	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	ナノフィラーコンポジット材のフィラーの構 造および分散状態の解明	27618
3346	可田 昭井	日本雷気(株)	次世代リチウムイオン二次電池向け電極材料	27605
3340	,田間人		の構造解析	30256
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	30082
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	ゴム中のフィラー階層構造のSAXS解析	26754
			Ni基合金表面に形成される酸化物と水素の相	
3372	小林 高揚	三菱重工業(株)	聞を解明するためのXAFS測定による考察そ	
			Ø2	
3373	高原 達夫	(株)住化分析センター	放射光XRDによる機能性材料の精密構造解析	27993
3375	北原周	(株)コベルコ科研	異常小角散乱をもちいた、合金中の析出相の 観察(I)	30083

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3302	李雷	(公財)ひょうご科学技術協会	BL08B2 XAFSステーションの調整	25762
3306	松下 忠史	旭化成(株)	高分子構造の小角X線散乱測定4	25750
3318	東口 光晴	旭化成(株)	粉末X線回折における無機化合物の評価	28690
3319	横山 和司	(公財)ひょうご科学技術協会	次世代半導体基板のトポグラフィ観察	30662
3320	東口 光晴	旭化成(株)	XAFSによる複合金属酸化物の構造解析	28690
3321	土田 秀一	(一財)電力中央研究所	トポグラフィ測定による4H-SiCエピタ キシャル膜中の欠陥評価	24494 31151 31152 31153
				31154
3325	中津 和弘	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所 構造解析	27991
3326	鈴木 拓也	(株)三菱化学科学技術研究セ ンター	有機半導体材料のX線散乱構造解析	24899
3329	立石 純一郎	(株)アシックス	プラスチックフォーム材のX線イメージング	28944
3330	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	ナノフィラーコンポジット材における粒子分 散構造の変化の観察	25753
3331	山本 友之	日本合成化学工業(株)	ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル 系樹脂のナノ構造解析	27619
3340	菅野 宏明	(株)三井化学分析センター	合成触媒およびその触媒により合成された材 料の構造解析	27774
3345	尾身 博雄	日本電信電話(株)	希土類添加シリケイトの材料設計と発光増強 機構の解明	30391
3346	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造 解析	27605
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	30081

3359	鈴木 賢紀	大阪大学	Crを含有する酸化物鉱物におけるCrイオンの 近傍の配位構造の解析	31411
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	ゴム中の階層構造解析	26754
3368	漆原 良昌	(公財)ひょうご科学技術協会	X線CTによる宝石サンゴの骨軸構造解析	30203
3371	平岩 美央里	パナソニック(株)	X線トポグラフによるGaN中結晶欠陥の評価	28147 32183
3372	小林 高揚	三菱重工業(株)	PWR原子力発電プラントー次系水中におけ る溶存水素濃度に依存したニッケル基合金表 面酸化物の構造評価	

20	1	2A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3306	坂本 直紀	旭化成(株)	高分子構造の小角X線散乱測定3	24879 31386 31390 31391
3318	東口 光春	旭化成(株)	粉末X線回折による無機化合物の評価	28690
3320	東口 光晴	旭化成(株)	XAFSによる複合金属酸化物の構造解析	28690
3321	土田 秀一	(一財)電力中央研究所	トポグラフィ測定による4H-SiCエピタ キシャル膜中の欠陥評価	24494 31151 31152 31153 31153 31154
3325	中津 和弘	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所 構造解析	24881
3326	鈴木 拓也	(株)三菱化学科学技術研究 センター	有機半導体材料のX線散乱構造解析	24899
3329	立石 純一郎	(株)アシックス	プラスチックフォーム材のX線イメージング	28944
3346	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造 解析	27605
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	23760
3365	中前 勝彦	(公財)ひょうご科学技術協会	天然ゴム結晶の応力下での変形挙動の解析	27988
3366	岸本 浩通	住友ゴム工業(株)	SAXS法を用いたゴム中のフィラー分散状態 の解析	26754

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3306 坂本				24879
			京八フセノ朝進生の小会と約約4回今の	31386
	収平 直紀	1世16成(1本)	同力す他力確構迫の小角へ稼敗乱測定と	31390
				31391
3318	山崎 輝昌	旭化成(株)	粉末X線回折による無機化合物の評価	27404
		土田 秀一 (一財)電力中央研究所	トポグラフィ測定による4H-SiCエピタ キシャル膜中の欠陥評価(BL08-2011A)	21466
	土田 秀一			31151
3321				31386
				31390
				31391
3324	山津 和24	(件)住化分析センター	小角X線散乱測定によるエネルギーデバイス	27770
5524			材料のナノ構造解析	21113
3325	山津 和弘	(株)住化分析センター	XAFSによるエネルギーデバイス材料の局所	24881
5525		(本)」としの例とフラー	構造解析	24001

3326	伊村 宏之	(株)三菱化学科学技術研究 センター	リチウムイオンニ次電池in-situX線回折測定	27776
3329	立石 純一郎	(株)アシックス	プラスチックフォーム材のX線イメージング	25006
3330	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	ナノフィラーコンポジット材の変形挙動と物 理特性との相関解明	23756
3331	山本 友之	日本合成化学工業(株)	ポリビニルアルコール系樹脂およびアクリル 系樹脂のナノ構造解析	23340
3340	菅野 宏明	(株)三井化学分析センター	合成触媒およびその触媒により合成された材 料の構造解析	27774
3346	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極材料の構造 解析	22076
3352	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	23760
3353	横山 和司	(公財)ひょうご科学技術協会	電池電極材料の構造研究	25755
3355	曽根 卓男	JSR(株)	末端変性SBRを用いたゴム組成物中でのシ リカ凝集構造の解析	24812
3356	河辺 雅義	(株)日東分析センター	ネオジム磁石の水素吸蔵離脱反応の解明	28149
0057	미수 원기		エナメルに形成された初期虫歯の再石灰化過	07770
3357	田屮 督于	江崎クリコ(休)	程におけるその風袖構造回復に与えるリン酸 オリゴ糖カルシウムの影響の時空間的解析	27770
3359	鈴木 賢紀	大阪大学	Crを含有する酸化物鉱物におけるCrイオンの 近傍の配位構造の解析	25864
3360	荻野 千秋	神戸大学	セルロース構造緩和試料の構造解析	27987
3363	上野 勝之	参天製薬(株)	水中での温度変化による眼内レンズの分子構 造変化の解析	27777

利用実験課題リスト (BL24XU)

※JASRIの成果公開基準を満たす成果(査読付き論文または研究成果集)のみのリスト

2017A				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2201	古山 松串	い一日日十七	ゾーンプレート光学系を利用した高分解能X	
3201	高山 俗貝	共厚県立入学	線顕微鏡の開発とその応用に関する研究	
2202	净垢 佳寺	F 库 唱 士 十 尚	高平行度X線マイクロビームの形成とその応	
3202	洋坝 住辛	共庫県立入子	用研究	
2220	士亡 少五	(性) けんしゃちょうし	マイクロビームX線イメージングを利用した	
3220	木広 自吉	(株)住宅分析センター	材料内部構造の観察	
3231	住田 弘祐	マツダ (株)	微細複合材料界面のHAXPES	
3256	城出 健佑	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡	
3264	伊藤廉	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	
2260	一 法		マイクロビームを利用した4H-SiCエピタキ	
3209	第日 功徳	(一刻)電力中央研究所	シャル膜中の欠陥評価	
2270	仕りま 空印	十词零气工業(件)	マイクロビームを用いた産業用材料の多角分	
3270	佐々木 太礼	百川电丸工未(休)	析	
2271	点木 二声	アイシン特徴(性)	高分子における成形条件プロセスによる結晶	
3271	五子 二忠	アイシン相磁(林)	性変化の解明	
3277	漆原 良昌	兵庫県立大学	BL24XUにおける研修会	
2270	楼山和司	后度俱立士尚	HAXPES+HiPP2による材料構造解析技術の	
3210	19日1日	兴津宗业入子	開発	
3279	鷺谷 智	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム中の階層構造追跡	

2016B

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102	尾身 博雄	日本電信電話(株)	SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に 関する研究	
3201	高山 裕貴	兵庫県立大学	ゾーンプレート光学系を利用した高分解能X 線顕微鏡の開発とその応用に関する研究	
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	
3220	末広 省吾	(株)住化分析センター	マイクロビームX線イメージングを利用した 材料内部構造の観察	
3231	住田 弘祐	マツダ(株)	複合材料の内部構造の観察	
3264	伊藤康	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	34041
3270	佐々木 宏和	古河電気工業(株)	マイクロビームを用いた産業用材料の多角分 析	
3271	舟本 三恵	アイシン精機(株)	高分子樹脂における成形条件プロセスによる 結晶性変化の解明	35170
3273	高尾 直樹	(株)日産アーク	樹脂材料の溶着界面評価	
3275	工藤 喜弘	ソニー (株)	放射光マイクロビームX線を利用した化合物 半導体の格子歪み解析	

2016A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	

3250	嶺重 温	兵庫県立大学	マイクロビーム放射光X線回折法を用いた固 体電解質の粒界構造研究	
3264	伊藤康	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	34041
3265	堀川 智之	グローバルウェーハズ・ ジャパン(株)	放射光高平行度XRCによるSiウェーハ表層の 結晶歪み解析	
3267	立石 純一郎	(株)アシックス	X線イメージングによるポリマー発泡プロセ スの可視化	
3270	佐々木 宏和	古河電気工業(株)	アルミ中の介在物分析	
3271	舟本 三恵	アイシン精機(株)	POMにおける成形条件プロセスによる結晶 性変化の解明	35170

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102	尾身 博雄	日本電信電話(株)	SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に	
2200	安白 捷	6度 月 立 十 尚	メッる切え ソ 娘 師 微 倍 の 言 府 ル と 広 田 に 閉 す ス 珥 の	24402
3200	电场 坍	共厚宗立入子	A 稼娯做現の商長化と心用に関9 る研先	34493
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	
3231	三根生 晋	マツダ(株)	複合材料の内部構造の観察	32272
2250	延弗 	后库俱立士尚	アパタイト型イオン伝導体の粒界観察による	
3250	領里 洫	共庫県立入子	特性制御	
3264	伊藤廉	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	34041
2265	5日 3日 3日 3日	グローバルウェーハズ・	放射光X線マイクロビームによるSiウェーハ	
3205	堀川 省之	ジャパン(株)	表層深さ方向における結晶歪み解析	
2267	去石 纳 的		X線イメージングによるポリマー発泡プロセ	
3207		(株)アシックス	スの可視化	
			XANES・粉末X線回折常時測定によるAl2O3	
3268	永田 祥平	兵庫県立大学	を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ	
			ミュレーション予測	

2015A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	34493
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	30662
3264	伊藤廉	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	34041
3267	立石 純一郎	(株)アシックス	X線イメージングによるポリマー発泡プロセ スの可視化	
3268	永田 祥平	兵庫県立大学	XANES・粉末X線回折常時測定によるAl ₂ O ₃ を担体とする自動車触媒の分光学的評価とシ ミュレーション予測	

20110				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2102	尼白 柿 状		SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に	
3102	尾身 降雄	日本電信電話(休)	関する研究	
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	34035
2202	油店 住去	F 库 唱 士 十 尚	高平行度X線マイクロビームの形成とその応	20662
3202	洋坝 住辛	共庫県立入子	用研究	30002
2202	计图 本台	后床间六十卷	X線マイクロイメージング技術の高度化及び	24025
3203	高野 労札	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	応用14	34035
3231	住田 弘祐	マツダ (株)	複合材料の内部構造の観察	30074

3250	嶺重 温	兵庫県立大学	アパタイト型イオン伝導体の粒界観察による 特性制御	
3253	横山 和司	兵庫県立大学	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	
3256	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造評価	35171

2014A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102	尾身 博雄	日本電信電話(株)	SiO ₂ -Si界面構造制御によるナノ構造形成に 関する研究	28535
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	34035
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	34256
3203	高野 秀和	兵庫県立大学	X線マイクロイメージング技術の高度化及び 応用15	34035
3253	横山 和司	兵庫県立大学	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	
3264	伊藤廉	(株)ミルボン	加齢毛髪の内部構造変化に関する研究	34041
3265	堀川 智之	グローバルウェーハズ・ ジャパン(株)	放射光X線マイクロビームによるSiウェーハ 表層深さ方向における結晶歪み解析	

2013B

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2102	民自 博世		SiO ₂ -Si界面構造制御によるナノ構造形成に	27165
3102	尾牙 時雄	日本电信电话(休)	関する研究	28535
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	30486
2202	净垢 佳寺	反 唐俱 去 十 尚	高平行度X線マイクロビームの形成とその応	30662
3202	洋坝 住辛	—————————————————————————————————————	用研究	34256
2202	百昭 禾和	丘 唐俱立十学	X線マイクロイメージング技術の高度化及び	
3203	同封乃和	—————————————————————————————————————	応用14	
3204	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析	27775
3247	中野 真也	日東電工(株)	フィラー含有高分子材料の内部構造観察	29294
2240	给未感幻	十限十学	クロムを有する酸化物鉱物におけるクロム原	21/11
3240	郭 小 貝花	八败入子	子近傍の局所構造の解析	31411
3253	横山 和司	放射光ナノテクセンター	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	

2013A

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
2102	皮白 描 拢		SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に	27165
3102	尾牙 時雄	口半电信电站(休)	関する研究	28535
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	30486
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	30662
3203	高野 秀和	兵庫県立大学	X線マイクロイメージング技術の高度化及び 応用13	
3204	戸田 昭夫	日本電気(株)	リチウムイオンニ次電池電極構造の物性評価	27775
3220	高原 達夫	(株)住化分析センター	各種材料のX線イメージングによる機構の解 明	27989
3247	中野 真也	日東電工(株)	フィラー含有高分子材料の内部構造観察	29294
3253	横山 和司	放射光ナノテクセンター	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	

2012B				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102	尾身 博雄	日本電信電話(株)	SiO ₂ -Si界面構造制御によるナノ構造形成に 関する研究	27665
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	30486
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	28448
3203	高野 秀和	兵庫県立大学	X線マイクロイメージング技術の高度化及び 応用12	32064
3204	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析	27775
2200	推图 白品		マイクロビームを用いた有機材料の微小領域	27641
3209	官野 太明	(休)三井化学分析センター	の結晶構造解析の研究	27666
3220	中津 和弘	(株)住化分析センター	各種材料のX線イメージングによる機構の解 明	27989
3229	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	ナノフィラーコンポジット材の階層的粒子分 散構造と光学特性との相関解明	25753
3230	澤部 孝史	(一財)電力中央研究所	軽水炉燃料被覆管材の耐食性向上に向けた酸 化皮膜・金属界面部のサブマイクロビームに よる微細構造・応力測定	27405
3237	土田 秀一	(一財)電力中央研究所	SiC半導体の結晶欠陥の歪み解析	24494
3247	中野 真也	日東電工(株)	フォーム材の多孔形成挙動の動的3次元観察	25749
3253	横山 和司	(公財)ひょうご科学技術協会	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	24885 25755
3255	小寺 賢	神戸大学	すれすれ入射X線回折・散乱法によるポリ-α -オレフィン/接着剤界面の微細構造解析	28383
3258	平岩 美央里	パナソニック(株)	X線マイクロビームによるGaN中の結晶欠陥 の評価	28147 32183
3261	三浦 靖史	(一財)電力中央研究所	Fe-18Cr-16Niモデル合金の局所応力評価	28696

201	24
201	

2012A				
課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102 尾身 博雄	尾身 博雄	推 日本電信電話 (株)	SiO ₂ -Si界面構造制御によるナノ構造形成に 関する研究	23451
				27184
				27665
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	28448
3203 高野		哥野 秀和	X線マイクロイメージング技術の高度化及び 応用11	25254
	高野 秀和			30488
				32064
3204	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析	23764
3220	中津 和弘	(株)住化分析センター	各種材料のX線イメージングによる機構の解 明	24881
3229	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	ナノフィラーコンポジット材の階層的粒子分 散構造と光学特性との相関解明	25753
3237	土田 秀一	(一財)電力中央研究所	SiC半導体の結晶欠陥の歪み解析	24494
3247	中野 真也	中野 真也 日東電工(株)	フォーム材の多孔形成挙動の動的3次元観察	25254
				25749
3250	嶺重 温	兵庫県立大学(工学部)	アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価	27667
3253	横山 和司		マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	24885
				25755

3256	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	放射光を利用したゴム材料中の階層構造追跡	23760
3258 平岩 美央	平坦 半日田	パナソニック(株)	X線マイクロビームによるGaN中の結晶欠陥	28147
			の評価	32183

201	1	в
	•	_

課題番号	実験責任者	所属機関	課題名	JASRI No.
3102	尾身 博雄	日本電信電話(株)	SiO2-Si界面構造制御によるナノ構造形成に 関する研究	24525 23451
3200	篭島 靖	兵庫県立大学	X線顕微鏡の高度化と応用に関する研究	25945 25902
3202	津坂 佳幸	兵庫県立大学	高平行度X線マイクロビームの形成とその応 用研究	23769
3203	高野 秀和	兵庫県立大学	X線マイクロイメージング技術の高度化及び 応用10	30488 25254 23322
3204	戸田 昭夫	日本電気(株)	次世代リチウムイオン電池用電極の構造解析	23764
3205	中川 武志	(株)東レリサーチ	マイクロビームX線を用いた各種材料の評価	23768
3209	菅野 宏明	(株)三井化学分析センター	マイクロビームを用いた有機材料の微小領域の結晶構造解析の研究	27641 27666
3230	澤部 孝史	(一財)電力中央研究所	軽水炉燃料被覆管材の耐食性向上に向けた酸 化皮膜・金属界面部のサブマイクロビームに よる微細構造・応力測定	27405
3233	竹田 晋吾	(公財)ひょうご科学技術協会	エネルギー高分解能XANES装置の開発	25755
3237	土田 秀一	(一財)電力中央研究所	SiC半導体の結晶欠陥の歪み解析	24494 21466
3238	末広 省吾	(株)住化分析センター	活物性特性に及ぼす電極構造の影響の解明	27778 28032
3247	中野 真也	日東電工(株)	フォーム材の多孔形成挙動の動的3次元観察	25254 25749
3248	鈴木 賢紀	大阪大学	クロムを有する酸化物鉱物におけるクロム原 子近傍の局所構造の解析	25864
3249	曽根 卓男	JSR(株)	末端変性SBRを用いたゴム組成物中でのシ リカ凝集構造の解析	24812
3250	嶺重温	兵庫県立大学(工学部)	アパタイト型イオン伝導体の粒界特性評価	27667
3253	横山 和司	(公財)ひょうご科学技術協会	マイクロXAFS光学系と実験装置のスタディ	24885
3255	西野 孝	神戸大学	微小角入射X線回折・散乱法によるポリ-α- オレフィン/接着剤界面の微細構造解析	23759

兵庫県ビームライン年報・成果集 Vol. 5,6 2016,2017

2018年3月1日 オンライン 発行

編集 兵庫県ビームライン成果集編集委員会
 編集委員長
 編集副委員長
 横山和司
 編集委員
 松井純爾
 中前勝彦
 津坂佳幸

発行・印刷 兵庫県立大学放射光ナノテクセンター

〒 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都1丁目 490-2 Phone: 0791-58-1415 Fax: 0791-58-1457 URL: http://www.hyogo-bl.jp

